# INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES AUTARQUIA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESTUDO COMPREENSIVO DA FOTODISSOCIAÇÃO DO ION OHO NOS HALETOS ALCALINOS E SUA INTERAÇÃO COM CENTROS DE COR

LAÉRCIO GOMES

Tese apresentada ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Niucleares como perte dos requisitos para obtenção do grau de "Doutor em Ciências" — Área Tecnologia Nuclear".

Orientador: Dr. Spero Penha Morato

#### **AGRADECIMENTOS**

Agradeço ao Dr. Spero Penha Morato pela orientação, incentivo e dedicação prestadas durante a realização deste trabalho e pela amizade demonstrada.

Agradeço tembém ao Dr. Fritz Luty (professor da Universidade de Utah USA) pela oportunidade oferecida a mim aceitando-me como estudante integrante do seu grupo de pesquisa (entre 1982 e 1984) e pela orientação e apoio recebidos durante a realização da segunda parte deste trabalho. Agradeço também a amizade demonstrada por toda sua família (Uta, Markus e Christophus).

#### AGRADEÇO AINDA:

Ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na pessoa do seu Superintendente, Dr. Cláudio Rodrigues, pelas facilidades experimentais concedidas.

À Comissão Nacional de Energia Nuclear pelo apoio financeiro e pela bolsa de estudos concedida.

À Suely que datilografou.

Aos Meus Pais pelo apoio e incentivo.

Desejo expressar especialmente minha gratidão a minha esposa Suely pela compreensão, apoio e incentivo recebidos desde o início da minha pós-graduação, e ao meu filho Brian que nasceu durante a complementação desta tese; ambos me inspiraram à continuar.

LAERC10

Nesse trabalho constatou-se que o ion OH substitucional nos haletos alcalinos modifica ou interfere nos processos eletrônicos desse material (verificação no dano de radiação na rede e no ciclo óptico das transições eletrônicas de centros de cor).

Dois casos distintos foram considerados: com o ion OH no estado (1) excitado e (2) fundamental.

1. O estudo compreensivo da fotodissociação do ion CH nas diversas matrizes dos haletos alcalinos mostrou que esse ion produz armadilhas (produtos da quebra do OH) eficientes na captura dos elétrons provenientes do dano na sub-rede aniônica ou da ionização de centros de cor. Foi observado principalmente que nas redes (KI e RbI) onde o espaço intersticial disponível é grande (onde a; 2,7 A) ocorre a manifestação de um segundo canal de desexcitação eletrônica do ion OH que conduz à formação direta (à 77 K) e acentuada de centros F e moléculas OH intersticiais às custas de ions OH.

Considerando o ciclo completo desse tipo de estudo (fotodissociação + tratamento óptico + térmico + CHg) propos-se um modelo fenomenológico capaz de explicar o comportamento observado da fotodissociação ressonante do Ion OH em função da ampla variação do parâmetro de rede (KCl + RbI). Observando o diagrama de níveis de energia do OH e centros F em função do parâmetro de rede observou-se que o estado fundamental não relaxado do centro F intercepta energeticamente o estado excitado relaxado do Ion OH. Num diagrama de coordenada de configuração isso é visualizado pelo cruzamento das curvas de potencial respectivas, permitindo a formação alternativa da vacância com o elétron no estado fundamental não relaxado (que relaxa posteriormente e forma o centro F) e uma molêcula neutra OH localizada na posição intersticial.

2. Verificou-se que o îon OH presente na rede influência e interfere no processo de desexcitação de defeitos ele trônicos do tipo F e também de seus agregados F<sub>2</sub> e F<sub>2</sub>. Foi verificado dois efeitos principais:

A) Indução de uma desexcitação râpida (10<sup>-9</sup> ≥ τ<sub>nr</sub> ≥ 10<sup>-12</sup> seg) e não madiativa no centro F°. Nesse caso ocorre a indução de uma desexcitação efficiente (η<sub>nr</sub> = 1) para uma distância média de até - 5 parâmetros de mede (-31 Å) de separação entre o centro P e o ion OH vizinho mais próximo (R<sub>C</sub> = 4.75 a medido para KCl à 77 K). Esse efeito é modulado pera taxa de meorientação do dipolo elétrico do ion OH que é extremamente dependente de T. A eficiência da transição não radiativa induzida no centro F por meorientação dipolar é pequena.

Uma estimativa mostrou que são necessárias -10° reorientações do dipolo OH para provocar o retorno não radiativo do elétron F para o estado fundamental da vacância.

B) Verificou-se um acentuado aumento da velocidade de reorientação dos certros F<sub>2</sub> e F<sub>2</sub> excitados na presença do for OH. O compo elétrico intenso do fon OH nas imediações desses defeitos, elimina a pequena barreira energética para o deslocamento de um dos seis anions da vizinhança (do defeito excitado) para a posição intermediária de configuração de ponto de sela (tipo H<sub>3</sub>) necessária para produzira reorientação espacial do defeito envolvido.

# OPTICAL AND ELECTRICAL STUDIES ON ALKALI HALIDES DOPED WITH OH AND F CENTERS

- I. COMPREHENSIVE RESONANT OH PHOTODISSOCIATION
- II. INTERACTION BETWEEN EXCITED F CENTERS AND OH MOLECULAR DEFECTS

#### **ABSTRACT**

In this work we have shown that the OH defect induces changes in the electronic processes of the alkali halides such as in radiation damage and optical cycles of colour centers.

Two cases were considered: with the presence of an OH ion in the (1) excited state and (2) in the ground state.

1. The comprehensive study of resonant OH photodissociation in several hosts showed that deep traps (for electrons) can be produced from the OH dissociation. These traps can be effective for the capture of electrons produced in the radiation damage of the lattice as well as for trapping electrons from ionized color centers.

We observed a second channel (new) for the de-excitation of the (OH<sup>-</sup>) molecule in KI and RbI.

This effect can be effective only when the lattice around the molecule holds a large enough interstitial space  $(a_i - 2.7 \text{ A})$ . This new mechanism is responsible for the strong production at LNT of F centers and CH<sup>0</sup> molecules at the expenses of OH<sup>-</sup> defects.

Considering the complete investigation of the full cycle (photodissociation + thermal and optical treatments + back production of OH defects; we proposed a pheno menological model that would explain the behaviour when one covers a wide variation of lattice parameters (KCl + RbI). Looking into the energy levels diagram of OH and F centers in alkali halides as function of lattice parameter one observes crystals with large lattice parameters like KI and the unrelaxed ground state of an F center energetically with the relaxed excited state of the OHT ion.

In a coordinate configuration diagram this would be

visualised by a crossing over of the potential curves thus allowing for an alternative formation of the vacancy plus one electron in the unrelaxed ground state (that relaxes and forms an F center) and a neutral and interstitial OH molecule.

- 2. We verified that the OH ion present in the lattice induces strong changes in the de-excitation processes of electronic defects with a spread out wave function (like F centers). A change in the reorientation behaviour of excited F<sub>2</sub> and F<sub>2</sub> centers was also verified. Two main effects should be mentioned:
  - A) The induced de-excitation is very fast (10<sup>-9</sup> ≤ τ<sub>nr</sub> ≤ ≤ 10<sup>-12</sup> seg) and non-radiative (with efficiency η<sub>nr</sub> = 1), for an F center with an OH defect inside of a critical radius of 5 lattice parâmeters ( 31 Å) according with our measurement for KCl at LNT. This effect is modulated by the rate of the OH reorientation which is dependent on the temperature. The efficiency of the induced non-radiative F de-excitation by one jump of the OH dipole is very low. An estimative has shown that 10<sup>4</sup> jumps are necessary to force the P electron to return back to the ground state of the vacancy.
  - B) Another type of system investigated (F<sub>2</sub> and F<sub>2</sub>) has shown an intense increase of the speed of reorientation of the F<sub>2</sub> and F<sub>2</sub> excited centers.

    From this we concluded that the strong electric field from the nearby OH ion eliminates the potential barrier for the displacement of a neighboring anion to produce the saddle point configuration involved in the reorientation of a double vacancy type centers.

# INDICE

				PAGIN	
1.	INTRO	oução		01	
			os	05 06	
11.	DANO DE RADIAÇÃO DE BAIXA ENERGIA NOS HALETOS ALCALINOS				
	11.1.		S PRIMÁRIOS DO EFEITO DA RADIAÇÃO EM BAIXA TEMPERATURA NOS SIÓNICOS	07	
	TT 2.	PROPRIEDADES PRINCIPAIS DO CENTRO OH			
	*****		fluorescência do OH	10 12	
			fotodissociação do OH	12	
		11.2.3.	termoluminescência do OH	13	
	11.3.	O CENTRO	U <sub>2</sub> (H <sub>1</sub> ) E SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES	13	
111.	O CEN	TRO F NO	S HALETOS ALCALINOS COM A ESTRUTURA DO NaC1	15	
IV.	PARTE	EXPERIM	ENTAL	20	
	1V.1.	PROCEDIA	ÆNTO, EQUIPAMENTO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS UTILIZADAS NA		
		FOTODIS	SOCIAÇÃO DE OE	20	
		IV.1.1.	criostato e porta amostra	20	
		IV.1.2.	preparação das amostras	21	
			medidas de absorção óptica	21 23	
			metodos de irradiação	24	
			tratamento térmico	24	
	IV.2.	PROCEDII TERAÇÃO	MENTO EXPERIMENTAL E TÉCNICAS UTILIZADAS NOS ESTUDOS DA INDE CENTROS F E ÍONS OH	25	
<b>v.</b>	RESULTADOS E CONCLUSÕES (Parte I)				
	V.1.	FOTODISS V.1.1.	SOCIAÇÃO DO OH EM RbCl E KBr	30 31	
	٧.2.	FOTODISS	SOCIAÇÃO DE OH EM REBY	38	
			fotodestruição dos centros F produzidos na destruição ter mica de centros H <sub>2</sub> O		
		V.2.2.	destruição térmica dos centros a e reconstituição dos fons OH	43	
	W 2	TOMOD 7.0	SOCIAÇÃO DE OH EM KI	45	
	<b>4.3.</b>	V.3.1.		_	
		V.3.2.	destruição térmica da banda 312 nm e recuperação dos fons OH substitucionais	55	
	V.4.	FOTODISSOCIAÇÃO DE OF EM RbI			
	****	V.4.1.	fotodestruição dos centros F (à 10 K) produzidos diretamente na fotodissociação de OH à 77 K	61 61	
	V.5.	FOTODISS	SOCIAÇÃO DE OR EM KBr + 27 P	67	
		v.5.1.	fotodestruição dos centros P produzidos diretamente na fotodissociação de OH		
	٠	V.5.2.	fotodestruição dos centros F produzidos na destruição tér mica dos centros H.O		

			PÁGINA
		V.5.3. fotodestruição da banda 333 mm	77
	V.6.	FOTODISSOCIAÇÃO DE OH EM RBBr CONTENDO 1,5% DE Na	80
	v.7.	MODELO PROPOSTO PARA A FOTODISSOCIAÇÃO DO ÍON OH SUBSTITUCIONAL NOS HALETOS ALCALINOS	84
۷I.	RESUL	TADOS E CONCLUSÕES (Parte II)	90
	VI.1.	ESTUDOS DA INTERAÇÃO DE CENTROS F E ÍONS OH EM KC1 COLORIDOS ADI	90
	VI.2.	DISCUSSÃO E MODELO PROPOSTO PARA O "QUENCHING" DA LUMINESCÊNCIA F EM KC1:0H À 77 K	106
	VI.3.	MEDIDAS DO TEMPO DE REPOPULAÇÃO DO ESTADO FUNDAMENTAL DO CENTRO F EM KC1:0H (77 K)	114
-,	VI.4.	ESTUDOS DA CORRELAÇÃO DO "QUENCHING" DA EMISSÃO F COM A VARIAÇÃO DA TAXA DE REORIENTAÇÃO DIPOLAR DO ÍON OH	119 129
	VI.5.	EFEITO DA IMPUREZA OH NAS PROPRIEDADES DE REORIENTAÇÃO DOS CENTROS $F_2$ e $F_2^{\dagger}$ EXCITADOS COM LUZ POLARIZADA EM KC1	134
	VI.6.	CONCLUSÕES	139
	VI.7.	PROPOSIÇÃO DE NOVOS EXPERIMENTOS	140
VII.		DERAÇÕES FINAIS SOBRE A ATUAÇÃO DO ÍON OH <sup>®</sup> NOS PROCESSOS ELETRÔN <u>I</u> OS HALETOS ALCALINOS	

O estudo das propriedades físicas das impurezas extrínsecas e também dos defeitos produzidos pelo dano de radiação nos materiais sólidos tem contribuido diretamente para o avanço da tecnologia de construção de dosímetros de radiação (γ, x, uv) e de lasers IR do estado sólido.

Em particular os defeitos eletrônicos (centros de cor ou centros F) nos materiais isolantes embora considerados defeitos pontuais são capazes de alterar drasticamente as propriedades ópticas, magnéticas e elétricas da rede hospedeira.

Os haletos alcalinos podem e tem sido utilizados como materiais modêlo (devido sua estrutura cristalina simples) para o estudo do dano de radiação em materiais sólidos com estruturas mais complexas<sup>1,2</sup>.

Eles são bons materiais para esses estudos pois além de possuirem estrutura cristalina relativamente simples, pode-se facíl mente detectar por absorção óptica os defeitos produzidos que apresentam transições eletrônicas ou vibracionais na banda proibida (transparente) do cristal, situando-se entre a absorção dos fonons TO da rede e a primeira absorção de excitons.

A presença de impurezas moleculares nesses materiais enri quece ainda mais as propriedades físicas do cristal hospedeiro. A impureza molecular OH foi escolhida porque pode ser introduzida subs titucionalmente na sub rede aniônica dos haletos alcalinos e se foto dissocia sob radiação UV ressonante com sua transição eletrônica, pro duzindo diretamente átomos de hidrogênio e de oxigênio em diferentes posições na rede. O dano de radiação nesse caso envolve simples e radiação de baixa energia. Também a impureza OH cional é encontrada em todos os haletos alcalinos crescidos natural mente ou sinteticamente no ar. A sua presença mesmo em quantidades pequenas (- 10<sup>-5</sup> partes/mol) produz pronunciados efeitos em muitas propriedades físicas do cristal, tais como: ópticas3,4, dielétricas5, elásticas, condutividade iônica e térmica, fotoquímica, e dano por radiação11. Além disso ela exibe momentos de dipolo elétricos12 e elásticos13, alinhamento paraelétrico14 e paraelástico15 sob aplicações de campos elétrico e mecânico respectivamente. Tais fenômenos tem estimulado estudos do defeito OH principalmente no seu estado ele trônico fundamental. Suas propriedades e comportamento no estado ex citado são pouco conhecidas.

Como o  $\overline{\text{ion OH}}$  nos haletos alcalinos se fotodissocia sob irradiação UV em baixas temperaturas (T < 200 K) ele constitue uma

fonte direta de átomos de hidrogênio (e ou lons) e de oxigênio mesmo combinações desses átomos que podem ocupar posições intersti ciais ou substitucionais na rede aniônica. As impurezas de hidrogênio nos haletos alcalinos desempenham um papel importante nos estudos dos defeitos em geral, pois fornecem grande quantidade informação sobre os mecanismos básicos envolvidos na formação e destruição defeitos sob irradiação. As impurezas de hidrogênio além de serem as mais simples imperfeições extrínsecas que se pode encontrar nos mate riais, são também excelentes testes para modêlos quânticos de defei tos em sólidos. Além da sua fácil identificação por absorção óptica eletrônica na região do ultravioleta16, pode-se observar também impurezas de hidrogênio medindo-se as transições vibracionais dos modos localizados no "Gap" 17,18. Essas transições vibracionais que são geralmente ativas no infravermelho, localizam-se energeticamente acima do ramo TO dos fonons da rede em virtude da pequena massa do átomo de hidrogênio. Em certos casos o carácter paramagnético do de feito de hidrogênio pode ser estudado por técnicas magnéticas19.

Apesar do problema da compreensão dos mecanismos de fotodis sociação do fon OH nos vários haletos alcalinos apresentar justificativas importantes e interessantes do ponto de vista da <u>física básica</u>, resolveu-se também estudar os efeitos ópticos e elétricos produzidos na interação destas moléculas OH com os centros F (centros de côr) gerados no processo de coloração aditiva da amostra.

A riqueza da física moderna dos centros de côr e suas apli cações está em boa parte baseada no fato que o simples defeito eletrô nico (centro F) nos haletos alcalinos pode ser utilizado como um ele mento de bloco na construção de uma grande variedade de centros de agregados de F. A produção controlada desses agregados é atingida através da ionização óptica dos centros F (presentes inicialmente numa distribuição estatística) em temperaturas acima de 230 K conduz à uma difusão ativada termicamente da vacância aniônica 20. Qual quer tipo de defeito, nesse caso, pode atuar como centro capturador da vacância migrante de tal forma que após a recaptura do eletron ionizado (inicialmente), é formado o centro de agregado de F. Quatro tipos de centros primários de agregados de F são conhecidos: a asso ciação de um centro F com outro centro F dando o centro F, orientado na direção <110>, a associação de um centro F com uma impureza catió nica (Li ou Na em KCl) produzindo o centro Fa orientado na direção <100>, a associação do centro F à uma impureza catiônica divalente e uma vacância catiônica produzindo o centro  $F_7$  e a associação do cen tro F à um defeito aniônico produzindo o centro FH orientado na dire ção <110>.

Como ilustração da estrutura desses defeitos veja a figura 1.

The second secon

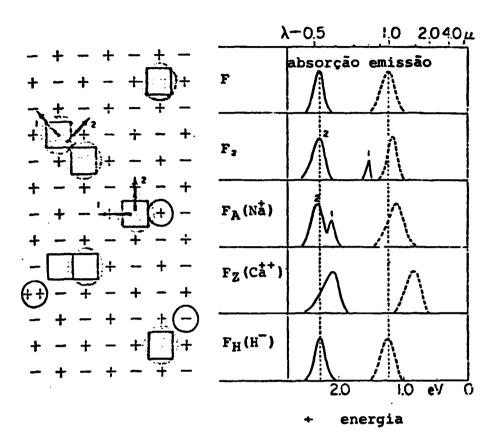


FIGURA 1. Ilustração da estrutura iônica dos centros F , FA, F2, FZ e FH produzidos nos haletos alcalinos pela associação do centro F à impurezas presentes na rede.

As bandas de absorção e de emissão são para a matriz de KCl à 77 K.

Para os três primeiros tipos de centros de agregados de F ocorre uma redução na simetria do defeito (produzido na associação) e pronunciadas mudanças na emissão e absorção comparadas as do centro F isolado. Em muitos casos, esses agregados primários originam agregados secundários com estruturas mais complexas envolvendo maior número de centros F ou outros defeitos.

A grande variedade de ef . Los do comportamento óptico e fotoquímico é ainda mais incrementada relo fato que a maioria dos centros de agregados de F existem na rede cristalina como centros com excesso ou deficiência de eletrons isto é, como F<sub>2</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>2</sub>.

Apenas um único tipo de defeito  $F_H$  tem sido produzido e in vestigado. 3 haletos alcalinos com a estrutura do NaCl, o centro  $F_H(H^-)$  que resulta da associação de um centro F com um defeito  $H_S^-$  situado em uma das posições <110> da segunda vizinhança do centro  $F^{21,22}$ . A perturbação causada no centro F pela troca de um dos 12 ha letos da segunda vizinhança por um ion  $H_-$ , é extremamente fraca de tal forma que a emissão e absorção são muito pouco afetadas. De fato, a existência da configuração  $F_H^-$  ( $H_-^-$ ) pôde ser verificada apenas pela observação do modo local de alta energia do  $H_-^-$  através da medida do espectro Raman ressonante do centro F ligeiramente perturbado.

Esse espectro apresenta um "splitting" da linha correspondente ao modo local do H em três componentes devido à redução da simetria do sistema.

Dentro de um programa tanto de interesse científico como de aplicação, nós levantamos a seguinte questão: pode o centro F ser associado ao defeito molecular diatômico (XY $^-$ ) originando portanto o centro  $F_H$  (XY $^-$ )?

Como os defeitos moleculares possuem graus de liberdade rotacional e podem ser alinhados por aplicação de campo elétrico externo e por "stress" e possuem modos internos de estiramento (da ligação molecular) de alta frequência, espera-se obter importantes interações desses defeitos moleculares com o centro F nas proximidades (segunda vizinhança).

O estudo da interação de centros F com ions moleculares CN em KCl mostrou recentemente um efeito importante de transferência de energia de excitação eletrônica em vibracional que estimulou o estudo da interação F — OH aqui proposto.

A associação de um centro F ao ion CN produz, similarmente ao caso do  $F_H(H^-)$ , um pequeno deslocamento das bandas de absorção e de emissão do centro F para o vermelho.

Apesar desse efeito pouco pronunciado, foi observado que o bombeamento óptico do centro F em KCl produz a excitação indireta

do modo interno de estiramento do Ion CN que consequentemente emite emissão vibracional em 4,8 microns .

Como a eficiência para a conversão da emissão eletrônica do centro F em emissão vibracional do ion CN é apenas - 4%, ocorre apenas uma pequena redução da intensidade da emissão IR do centro F cap turado pelo ion CN. Estudos desse tipo motivaram Sievers e outros e investigarem a possibilidade de se obter emissão vibracional do CN excitado diretamente com laser pulsado sintonizado na absorção do seu segundo harmônico  $(2,4\,\mu)$ . O resultado dessa investigação mos trouprincipalmente a viabilidade real de se construir um laser de emissão vibracional do CN nos haletos alcalinos.

#### I.1. OBJETIVOS

No presente trabalho pretende-se estudar numa primeira eta pa (Parte I), como a fotodissociação do ion OH ocorre nas diversas matrizes sólidas dos haletos alcalinos (KCl, KBr, RbCl, RbBr, KI e RbI) e qual é a influência dos diversos produtos dessa fotodissocia ção na produção e estabilização dos centros de agregados de F tais como os centros  $F_2$ ,  $F_2^+$ , produzidos indiretamente no processo do dano de radiação na sub-rede aniônica.

Numa segunda etapa (Parte II) pretende-se medir as altera ções das propriedades ópticas (absorção, emissão e fotocondutividade) do centro F perturbado pelo ion OH e verificar que tipo de interação ocorre entre eles.

Espera-se produzir modelos claros para essa interação con siderando que tanto o centro F como o defeito OH nos haletos alcalinos foram bastante estudados (cada um isoladamente) tanto por medidas ópticas, magnéticas e elétricas. Em particular os estados orientacionais <100>, as propriedades paraelétricas e paraelásticas bem como as medidas de excitação do "stretching" e da libração do defeito OH nessas redes cristalinas foram bastante investigados e são bem compreendidos.

Como será mostrado no capítulo VI desse trabalho, a presença do defeito OH altera drasticamente todas as propriedades ópticas de desexcitação radiativa e não radiativa do estado excitado relaxado do centro F.

Com esses dois tipos de estudos (I e II) estaremos produzindo condições para aumentar revisão de como o fon OH substitucio nal nos haletos alcalinos, tanto no estado excitado como no estado eletrônico fundamental, contribue A) para a estabilização dos defeitos eletrônicos B) como é capaz de alterar as propriedades ópticas dos defeitos eletrônicos excitados e localizados na sua vizinhança.

### 1.2. COMENTÁRIOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DESTE TRABALHO

A parte I desta tese foi desenvolvida no IPEN e é uma extensão do trabalho iniciado em 1978 sobre a formação e destruição de centros H<sub>2</sub>O nos haletos alcalinos provenientes da quebra do ion OH por irradiação UV. Na primeira parte (I) deste trabalho procurou-se mostrar que o mecanismo conhecido da fotodecomposição do ion OH (presentemente aceito) não é único. Um novo mecanismo foi encontrado e será discutido no capítulo

A segunda parte deste trabalho (II) foi desenvolvida na Un<u>i</u> versidade de Utah (de 1982 à 1984) durante um estágio de aperfeiço<u>a</u> mento com o professor Fritz Luty. Esse trabalho (II) introduz o est<u>u</u> do das interações de centros de côr com impurezas moleculares com grande momento de dipolo elétrico.

Quando um cristal iônico é exposto à radiação, numerosas mudanças podem ocorrer tanto nos ions da rede como nas impurezas que estiverem presentes. Os produtos finais dessas mudanças são classificados em termos de três categorias de defeitos<sup>27</sup>:

Defeitos eletrônicos: que envolvem mudanças nos estados ele trônicos de valência.

Defeitos iônicos: que resultam dos deslocamentos de ions da rede.

Imperfeições macroscópicas: tais como deslocações e vazios ("voids").

Os mecanismos pelos quais esses defeitos podem ser produzi dos resumem-se nas seguintes classes:processos eletrônicos, colisões elásticas e radiolise.

A classe dos processos eletrônicos inclue todos os processos onde um estado eletrônico é alterado ou uma carga é deslocada pela absorção da anergia radiante, porém, sem envolver a formação de defeitos atômicos ou iônicos. Na classe das colisões elásticas os átomos ou íons são deslocados devido a transferência de momento e energia pelas partículas incidentes. Pelo processo de radiólise são produzidos os defeitos atômicos ou iônicos como um resultado final de uma série de reações iniciadas com uma excitação eletrônica. Essas reações preliminares envolvem três etapas:

- 1. A excitação eletrônica provoca momentaneamente a criação de um defeito eletrônico carregado na rede.
- 2. Há uma conversão dessa energia de excitação em energia cinética para o íon da rede.
- 3. O Ion move-se e se estabiliza num ponto da rede.

# II.1. PRODUTOS PRIMÁRIOS DO EFEITO DA RADIAÇÃO EM BAIXA TEMPERA TURA NOS CRISTAIS IÔNICOS

Por radiólise a radiação ultravioleta ionizante é capaz de provocar (T < 10 K) a formação dos defeitos Frenkel que são os produtos primários da radiação na sub-rede aniônica dos haletos alcalinos. Dois tipos de defeitos aniônicos são formados: Pares Frenkel carregados (constituído por uma vacância aniônica, — , e um anion interstitial (com índice i) cuja reação de formação é a seguinte:

 $Cl_s^- + hv + e^- + Cl_i^5$ .

Geralmente são considerados os pares neutros Frenkel como os produtos primários do efeito da radiação.

A seguir será descrito o processo de formação de centros P e H a título de ilustração de um processo elementar típico de dano de radiação num cristal iônico.

# Formação de Centros H e F (T < 10 K) 27,28,29

Raios X ou UV ionizam um ion de halogênio da sub-rede anionica produzindo primeiramente elétrons e buracos livres. O buraco livre é imediatamente localizado na rede provocando uma relaxação dos ions ao seu redor tornando-se um buraco auto-aprisionado na configuração de um ion molecular  $X_2$  (X representa o átomo de halogênio), também conhecido como centro  $V_K$ . O elétron livre inicialmente produzido perde energia cinética por excitações de fonons ópticos etc, sendo finalmente aprisionado pelo centro  $V_K$  ou  $X_2$ .

O elétron aprisionado, ocupa inicialmente os níveis mais energéticos e decai rapidamente para o nível excitado de energia mais baixa do centro  $V_{\pi}$ , o estado  $2p_{\pi}$ .

No centro  $V_K$  os dois ions de halogênio estão mais próximos um do outro do que na posição normal da rede, formando uma espécie de duas semivacâncias (cada uma com carga efetiva + |e|, sendo atrativa para elétrons) na direção <110>, com o ion molecular entre elas.

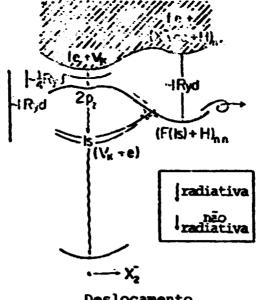
0 estado  $2p_Z$  é o estado excitado menos energético porque está localizado ao longo da direção <110> utilizando a região de potencial atrativo das duas semivacâncias.

Conforme podemos observar na figura 2, a transição do elétron  $2p_z$  para o estado ls pode ocorrer por dois caminhos: transição radiativa e não-radiativa.

Transição não radiativa: o elétron  $2p_z$  enquanto relaxa des loca o ion molecular para uma das semivacâncias ficando portanto in teiramente localizado na semivacância oposta. Em virtude da maior afinidade eletrônica dessa vacância em relação as semivacâncias ocu padas pelo elétron  $2p_z$ , essa relaxação  $2p_z \rightarrow 1s$  pode fornecer energia suficiente para que a molécula  $X_s$  se mova na direção <110> numa se quência de colisões e reposições estabilizando—se numa posição afas tada da semivacância ocupada pelo elétron no estado ls (centro F), na forma de um "crowdion" (centro H).

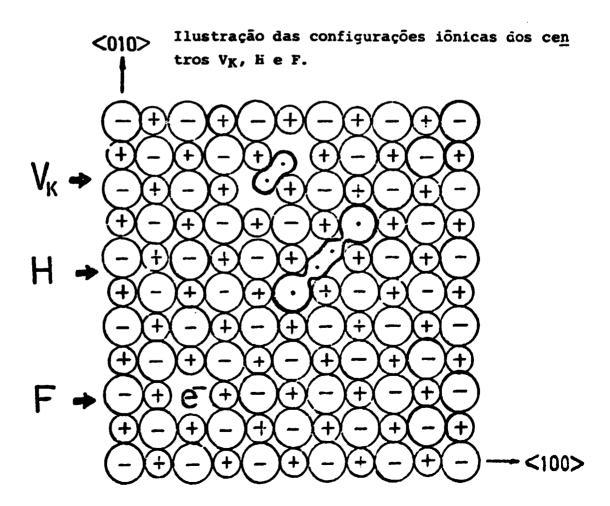
Pode ocorrer também que a molécula não receba energia cinética suficiente para mover-se, resultando numa relaxação do sistema (F(ls) + H) para uma situação onde o elétron ocupa o estado ls do centro  $V_K$ , conforme é indicado na figura 2.

V<sub>K</sub>. Centro de buraco auto aprisionado estável em temperaturas baixas (no KCL é <u>es</u> tável até – 200 K).



Deslocamento

PIGURA 2. Hecanismo de formação de centros F e H nos haletos alcali nos (proposto por Toyozawa)29.



de centro 11

Transição Radiativa: O elétron no estado  $2p_Z$  do centro  $V_K$ , emite um foton de energia aproximadamente 2eV indo para o estado ls do mesmo. Finalmente o sistema composto pelo elétron ls mais o centro  $v_K$ , decai por emissão luminescente e a rêde recompõe-se. É importante notar que existem dois canais competindo; um conduzindo à formação de centros de cor (centros F e H) e outro conduzindo à luminescência intrînseca e portanto não produzindo defeitos na rede (figura 2).

#### 11.2. PROPRIEDADES PRINCIPAIS DO CENTRO OH

As impurezas OH quando incorporadas substitucionalmente nos haletos alcalinos dão quatro tipos de absorção óptica:eletrônica, vibracional, rotacional e libracional 16,17,18.

A absorção eletrônica origina a formação de uma banda de absorção localizada na região espectral do ultravioleta, próxima à absorção fundamental eletrônica do cristal, larga e sem estrutura, apresentando um pequeno estreitamento à baixas temperaturas. A intensidade de oscilador varia entre 0,1 e 0,2 (para sete haletos alcalinos diferentes). Esses pequenos valores para a intensidade de oscilador da banda UV permitem a conclusão de que devem existir mais transições envolvendo energias maiores mas que são encobertas pelas bandas de exciton do cristal<sup>30</sup>.

A posição do máximo da banda segue a relação empírica de Molwo-Ivey que relaciona a distancia <u>d</u> entre os vizinhos mais próximos e a frequência do máximo da banda  $v_{max}$ :  $v_{max}$ = 691 d<sup>0.85</sup> (1).

Uma relação linear desse tipo reforça o argumento de Kostlin<sup>31</sup> que assume ser a banda de absorção ultravioleta do OH devida à uma transição eletrônica análoga a que ocorre na primeira absorção de excitons nos haletos alcalinos<sup>32</sup>.

Para o espectro de absorção de excitons, Hilsch e Pohl consideraram que o efeito primário da absorção de um foton  $\hat{\mathbf{e}}$  o da transferência de um elétron de um átomo de halogênio para um átomo de alcalino vizinho mais próximo ou mecanismo de absorção por troca de carga. A energia requerida nesse processo  $\hat{\mathbf{e}}$  dada por  $^{33}$  hv=E<sub>A</sub>-E<sub>I</sub> +  $^{\alpha}$ M  $^{e^2}$  (2) onde E<sub>A</sub>  $\hat{\mathbf{e}}$  a afinidade eletrônica do halogênio, E<sub>I</sub>  $\hat{\mathbf{e}}$  a

energia de ionização do átomo alcalino,  ${}^{\alpha}$ M é a constante de Madelung e  $\underline{d}$  é a distância entre vizinhos mais próximos.

Essa relação tem sido usada para predizer as posições das bandas de absorção óptica provocadas por impurezas de fons de halogê nios<sup>34</sup>.

Considerando a equivalência entre o número de elétrons da camada mais externa do ion OH e do ion de halogênio é assumido um

processo análogo para a absorção UV do OH.

Kapphan<sup>32</sup> calculou as posições dos máximos das bandas de absorção UV do OH para onze haletos alcalinos, com base nesse modêlo de transferência de carga, utilizando a equação (2) e comparou com os valores calculados pela relação de Molwo-Ivey (1) tendo obtido uma concordância dentro de 93%. Com base no modêlo de transferência de carga pode-se explicar qualitativamente que a banda de absorção UV do OH se refere à transição eletrônica do estado fundamental do OH para o estado excitônico da rede. A subestrutura observada no espectro de emissão dos centros OH<sup>35</sup>, <sup>16</sup> refere-se à transições entre os diversos níveis vibracionais do estado eletrônico excitado para o fundamental.

Cálculos teóricos da transição UV do ion OR efetuados por Chae e Dick<sup>37</sup> utilizando a função de onda do estado eletrônico funda mental para o ion OH livre e o modêlo de transferência de carga, mostraram razoável concordância entre os valores das energias da transiç; calculados e os medidos, não explicando o fator de anisotro pia q = 0,3 obtico experimentalmente.

A absorção vibracional 36 do fon molecular OH consiste numa banda do infravermelho próximo (cêrca de 2,7 μ) provocada pela excitação óptica do modo vibracional de estiramento da molécula OH. A absorção no infravermelho distante 38 (-0,035 eV) é interpretada como proveniente da excitação da vibração angular do eixo molecular ao redor de suas orientações de equilíbrio na rede cristalina.

O defeito OH apresenta um momento de dipolo elétrico per manente podendo portanto ser orientado num campo elétrico apresentan do fenômeno de dicroismo elétrico30. Isto significa que elétrico induz diferenças no coeficiente de absorção de luz polariza da em diferentes direções e está diretamente relacionado ao comporta mento paraelétrico dos dipolos. Qualquer centro substitucional possuindo dipolo elétrico pode ser assumido estar confinado potencial cristalino em n direções de equilíbrio correspondendo clas sicamente a um estado fundamental orientacional n-vêzes degenerado. Essa degenerescência é removida pela aplicação de um campo elétrico e numa temperatura de equilíbrio a população desses níveis será dada pela distribuição de Boltzmann. Excitações ópticas de um centro de dipolo produzem diferentes absorções quando os dipolos são excitados paralelamente ou perpendicularmente ao seu eixo (polarização o ou m respectivamente).

O alinhamento dos dipolos pelo campo elétrico aplicado deve produzir mudanças no coeficiente de absorção óptica. Essas mudanças foram medidas quantitativamente para a absorção eletrônica UV do OH e interpretadas como seque 32:

- 1. O centro OH nos haletos alcalinos possui dipolo elétrico (p 1 e A) e está confinado pelo potencial cristalino nas seis direções <100>. Exceção é encontrada no caso do KI onde o dipolo OH encontra-se orientado entre as seis direções <110>.
- 2. A mesma transição eletrônica espectral realiza-se para lelamente ou perpendicularmente ao eixo molecular com intensidade de oscilador (f) diferente: f<sub>II</sub> / f1 - 0,3.

A excitação óptica da transição responsável pela banda de absorção UV conduz a um retorno radioativo (luminescência) ou não radioativo 35,36 ou provoca a fotodissiciação do ion OH-3,18.

## II.2.1. Fluorescência do OH

Köstlin<sup>35</sup> concluiu que a fluorescência observada no KBr:OH está relacionada com transições radiativas da molécula excitada.Como aos máximos mais intensos correspondem as energias maiores, esse fato sugere que as transições de emissão à partir do estado excitado fin dam nos níveis vibracionais com N = 0,1,2, ... do estado fundamental da molécula. O desvio de Stokes observado é muito mais proveniente da relaxação da rede (após a excitação e emissão pela molécula) do que da relaxação molecular. É observado também um forte acoplamento dos estados eletrônicos da molécula com as vibrações da rede em vir tude da largura da banda de emissão e do seu alargamento com a tem peratura.

# II.2.2. Fotodissociação do OH

Kerkhoff estudou a fotodissociação do OH e forneceu a primeira equação para o processo de dissociação:

$$OH_{g}^{-} + hv_{OH}^{-} (T<100 K) + H_{i}^{O} + O_{g}^{-}$$
 (3)

onde o indice <u>s</u> significa posição substitucional e <u>i</u> significa pos<u>i</u> ção intersticial na rede. Uma fotodissociação correspondente é também Observada nos haletos alcalinos dopados com ions SH<sup>-19</sup>, SeH<sup>-19</sup> e TeH<sup>-40</sup>.

A equação (3) é sustentada fortemente por medidas de ESR e ENDOR<sup>16</sup> indicando sem dúvida a presença dos átomos de hidrogênio em posições intersticiais (centros U<sub>2</sub>). O ion negativo de oxigênio (0) produzido nessa reação fotoquímica, possivelmente ocupa uma posição substitucional e introduz uma banda de absorção eletrônica muito próxima à absorção de excitons do cristal o que dificulta a sua de tecção. Neste trabalho será mostrado e identificado as bandas UV do C<sub>3</sub> em vários haletos alcalinos até agora não observadas. Os centros

 $U_{a}$  ( $H_{1}^{0}$ ) e o  $O_{S}^{-}$  são os produtos primários da fotodissociação do OH dependendo da técnica utilizada no processo de irradiação. Para obter-se os centros  $U_{a}$  e  $O_{S}^{-}$  como os produtos finais do processo de dissociação do OH deve-se irradiar a amostra durante um intervalo de tempo relativamente curto, com luz monocromática na região próxima do máximo da absorção eletrônica do OH. Exposições longas e o uso de luz não monocromática produzem reações secundárias conduzindo à for mação de centros como  $U_{a}$ ,  $V_{a}$ ,  $V_{b}$ ,  $V_{b}$ ,  $V_{b}$ . Os centros  $V_{a}$  produzidos na fotodissociação do OH tornam-se instáveis termicamente a tempera turas acima de 110 K em KC1.

## II.2.3. Termoluminescência do OHT

Köstlin<sup>35</sup> utilizando uma amostra de KBr:OH encontrou um pico termoluminescente próximo de 145 K durante a destruição térmica dos centros U. Uma análise mais detalhada da curva do decaimento da absorção óptica dos centros U, e da termoluminescência, ambas regis tradas simultâneamente sob condição de aquecimento linear, revelaram que a intensidade da luminescência é rigorosamente proporcional à razão de decaimento dos centros U2. Observou-se também que a distri buição espectral dessa luminescência é idêntica ao espectro da fluo rescência do OH quando medida na temperatura do " annealing". Nesse caso conclue-se que uma fração dos átomos de hidrogênio intersticiais (centro U2) libertados de suas armadilhas recombinam-se com os ions O formando moléculas OH no estado eletrônico excitado e que, à se guir, se desexcitam por emissão luminescente. A eficiência observada nesse processo é de ~ 0,2 quanta luminescente por centro U, truído (supondo que todo (OHT) produzido se desexcite por emissão luminescente).

# 11.3. O CENTRO $U_2$ ( $H_1^0$ ) E SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES

O centro U, também conhecido como H, é basicamente constituído por um átomo neutro de hidrogênio ocupando uma posição intersiticial na rede. Em KCl torna-se instável termicamente por volta de 110 K migrando pelo cristal dando origem a novas imperfeições na rede 1. Ele pode ser produzido a partir da fotodissociação, embaixas temperaturas, de moléculas substitucionais XH nos haletos alcalinos, onde X reprerenta os elementos do grupo VI da tabela periódica. Vários estudos de absorção óptica 2 e do espectro de ressonância do centro U, na presença dos vários anti-centros (O, S, Se, Te) não mostraram diferenças entre eles. Até o presente nada se sabe sobre uma possível interação entre o defeito U, e o seu anti-centro O.

Quando aprisionado na posição intersticial o átomo hidrogênio possui uma banda de absorção óptica eletrônica na do ultravioleta. A transição eletrônica responsável por essa banda foi primeiramente descrita por Kerkhoff como a excitação de um buraco positivo que no estado eletrônico fundamental do centro U, está prin cipalmente ligado ao hidrogênio e no estado excitado está ligado mais fortemente aos quatro ions de halogênios vizinhos mais próximos ". Kurz 10 sugeriu que o primeiro processo a ocorrer após a excitação do U, é a relaxação não cúbica da rede (distorção Jahn-Teller) onde o ion de hidrogênio desloca-se ao longo da direção <100> e os de halogênio na direção <110>. Inicialmente o buraco é excitado opti camente, espalhando-se entre os ions de halogênio; logo em seguida ocorre uma relaxação não cúbica da rede provocando uma mudança potencial e polarização da distribuição de carga tornando o mais localizado. Nessa situação pode ocorrer ou uma aniquilação entre o elétron e o buraco (mais localizado) restaurando a rede escape à essa aniquilação conduzindo à formação de novas imperfeições.

O átomo de hidrogênio proveniente da quebra da molécula OH nos haletos alcalinos pode produzir várias configurações interessantes através da destruição térmica dos centros  $U_2$ . Como exemplo citase os centros  $U_{2x}^{44}$ ,  $U_3$  e  $U_{3A}^{45}$ ,  $U_4$  e  $U_{3A}^{45}$ .

O centro U<sub>2x</sub> foi mostrado ser uma configuração intermediá ria 17 na formação do centro H<sub>2</sub>O e que é essencialmente contituído por um átomo de hidrogênio neutro aprisionado numa posição intersticial de segunda vizinhança do ion OH. Essa configuração é termicamente mais estável do que o centro U<sub>2</sub> 18. O centro H<sub>2</sub>O também conhecido co mo um centro F molhado, é produzido pela reação entre um átomo de hidrogênio termicamente instável e um centro OH 19, 50. Spaeth 51 obser vou que nos cloretos alcalinos dopados com I (ou Br) e OH, centros U<sub>2</sub> produzidos pela fotodecomposição do OH à 77 K são aprisionados (à 90 K) pelas impurezas I (ou Br) produzindo uma nova configuração onde um dos cloros vizinhos mais próximo do átomo de hidrogênio é substituído pelo ion I ou Br. Configuração que ele chamou de H<sub>1</sub> (I ou Br).

Os mecanismos do dano de radiação de baixa energia e os modêlos para o centro OH e dos seus produtos de fotodecomposição discutidos aqui neste capítulo são de grande importancia para a interpretação e discussão dos resultados (do estudo compreensivo da fotodissociação de OH nos haletos alcalinos) apresentados no Capítulo V.

O centro F é constituído por um elétron ligado numa vacân cia aniônica no estado do tipo ls. Esse defeito eletrônico é um defeito pontual universal que pode ser produzido em todos os haletos alcalinos e em outros cristais ou por dano de radiação ou por coloração aditiva ou eletrolítica.

A presença do centro F nesses materiais introduz uma banda de absorção intensa (1s + 2p) na região entre o ultravioleta até o infravermelho próximo dependendo da rede hospedeira. Em cristais com parâmetros de rede pequenos como o LiF etc, essa absorção principal localiza-se no UV enquanto em KCl está no visível e no RbI no IR. Além dessa absorção principal, o centro F produz várias outras transições mais fracas para estados excitados mais altos<sup>52</sup>. A larga banda K situada no lado de maior energia da banda F é devida as transições não resolvidas do elétron 1s para os estados 2p, 3p, ..., np, enquan to que a banda L (composta por várias componentes L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>) corresponde a várias transições eletrônicas do estado 1s para estados localizados na banda de condução. A figura 3 mostra as várias bandas, F, K e L do centro F em KCl e suas respectivas intensidades em uma escala logaritmica. Mostra também a variação da posição da banda para vários haletos alcalinos.

O centro F é um modelo do sistema onde o elétron está fortemente ligado aos fonons perturbados pelos modos locais pertinentes à estrutura do defeito. Isso produz pronunciado deslocamento da posição da banda de emissão para energias menores (desvio de Stoke) com relação à absorção.

A concepção desse modelo para o centro F, pode ser ilustrada num á agrama de coordenadas de configuração (figura 4) que mostra a variação quadrática da energia eletrônica total do sistema em função de Q (coordenada de configuração) do modo local efetivo de frequência v. Na realidade o centro F acopla com um grande número de modos locais da rede com simetria A<sub>1g</sub>, E<sub>g</sub> e T<sub>2g</sub>, todos contribuindo para o alargamento da banda de absorção<sup>53</sup>.

O ciclo de bombeamento óptico (contendo somente o primeiro estado excitado não relaxado) da absorção principal do centro F é mostrado na figura 5. Ele consiste de 4 etapas: excitação, relaxação, luminescência e relaxação de volta à configuração normal. A absorção fundamental origina-se de transições do estado fundamental eletrônico do tipo ls para o primeiro estado excitado do tipo 2p constituintes de um poço quadrado de potencial formado pela vacância de anion. A

ri

os åe

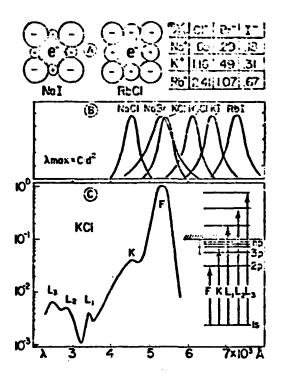


FIGURA 3. Absorção eletrônica do centro F em KCl numa escala logaritmica.

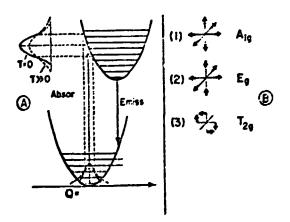


FIGURA 4. Diagrama de coordenada de configuração do centro F para os haletos alcalinos (A). Modos normais (locais) da rede que acoplam com o centro F (B).

intensidade de oscilador f associada com essa transição é próxima da unidade. A relaxação do estado excitado consiste numa simples expansão da vacância e de um correspondente ajustamento da função de onda 2p. Entretanto, quando o sistema alcança o seu estado excitado relaxado (RES), a função de onda eletrônica associada torna-se espacialmente muito difusa<sup>54</sup>.

A intensidade de oscilador da banda de emissão F é muito pequena (f = 0,01)55 em consequência da pequena superposição da fun cão de onda do estado excitado relaxado (RES) com a do estado funda mental não relaxado. Também, o (RES) é energeticamente muito raso<sup>36</sup> possibilitando uma auto absorção dos fotons emitidos . As duas rela xações da vizinhança que ocorrem tanto para o estado excitado como para o estado fundamental do centro F (logo após as transições ele trônicas) são extremamente rápidas  $^{55}$ :  $\sigma_R^{}$  e  $\sigma_{R^{1}}^{}$  são menores ou ordem de 10<sup>-12</sup> segundos. Geralmente o tempo de vida da emissão (-77 K) é da ordem de 10<sup>-6</sup> segundos, o que é muito longo comparado com o va lor esperado para uma transição eletrônica permitida do tipo 2p + ls (~ 10<sup>-8</sup> segundos). Isso é explicado pelo fato que o RES do centro F não é puramente constituído pelo estado 2p e mistura-se como estado 2s produzindo uma transição não totalmente permitida. Isso aumenta o tempo de vida radiativo do RES. No processo de desexcitação do centro F pode também ocorrer uma liberação termicamente ativada do elétron para a banda de condução entre 100 e 200 K<sup>57</sup>. Isso porque o mínimo da banda de condução está somente à - 0,15 eV (em KC1) do RES. Esse me canismo é o responsável pela fotocondutividade observada nesse mate rial. O elétron, uma vêz liberado na banda de condução, deixa para tras a vacância aniônica que é atrativa para elétrons. Assim este elétron pode ser recapturado novamente por uma outra vacância aniôni ca ou capturado por um centro F (no estado fundamental) produzindo o centro F' (estável até - 200 K no seu estado eletrônico fundamental) que é constituído pelo centro F mais um elétron. A figura 6 mostra as diversas possibilidades de desexcitação eletrônica do centro  $\mathbf{F}^{\overline{z}}$  . Considerando as probabilidades de cada canal possível de desexcita ção e ionização é possível escrever a eficiência da emissão F e da ionização em função da temperatura. Consideremos as seguintes proba bilidades:

 $\sigma_r^{-1}$  = probabilidade da transição radiativa

 $\sigma_{1}^{-1}$  = probabilidade da ionização

σ<sup>-1</sup> = probabilidade total de desexcitação

 $\sigma^{-1} = \sigma_{r}^{-1} + \sigma_{i}^{-1}$  e  $\sigma_{i}^{-1} = \sigma_{O}^{-1}$ . e  $^{-E/KT}$ 

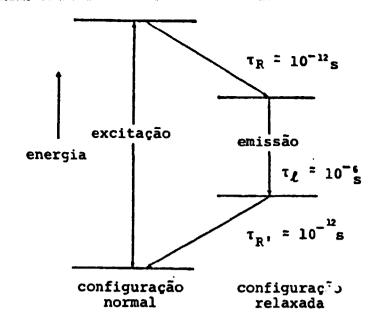


FIGURA 5. Ciclo principal de bombeamento óptico d centro F.

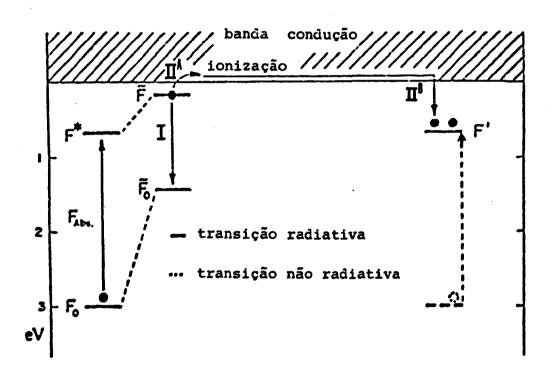


FIGURA 6. Diversas possibilidades de desexcitação do centro F:

I) Luminescência IR, II<sup>A</sup> ionização termicamente ativada , II<sup>B</sup> captura do e<sup>-</sup> por outro centro F + F<sup>1</sup>. Considerando-se agora as eficiências  $\eta_r$  de emissão radiativa e  $\eta_i$  de ionização térmica, obtém-se:

$$\eta_{r} = \sigma_{r}^{-1} / \sigma^{-1}$$
;  $\eta_{i} = \sigma_{i}^{-1} / \sigma^{-1}$ 

logo tem-se:

$$\eta_{r} = \left[1 + \frac{\sigma_{r}}{\sigma_{o}} \quad e^{-E/KT}\right]^{-1}$$

$$\eta_{i} = \left[1 + \frac{\sigma_{o}}{\sigma_{r}} \quad e^{E/KT}\right]^{-1}$$
Onde em KCl:
$$E = 0.15 \text{ eV}$$

$$\sigma_{r} = 1.73 \times 10^{6} \text{s}^{-1}$$

O modelo dinâmico aqui apresentado para o comportamento do elétron durante o ciclo de bombeamento óptico do centro F será utilizado na análise e discussão dos resultados do estudo da interação do centro F com os ions OH, apresentados no capítulo VI.

#### CAPÍTULO IV. PARTE EXPERIMENTAL

IV.1. PROCEDIMENTO, EQUIPAMENTO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS UTILIZADAS NA FOTODISSOCIAÇÃO DE OH

A necessidade de medidas ópticas em baixas temperaturas advém dos seguintes motivos:

- 1. O ion OH fotodissocia-se efetivamente somente em tempe raturas abaixo de 150 K<sup>48</sup>.
- 2. O centro U<sub>2</sub> é termicamente estável abaixo de 100 K para a maioria dos haletos alcalinos.
- 3. A fotodissociação de OH em altas temperaturas pode produzir diferentes produtos dos produzidos inicialmente na quebra do OH em baixas temperaturas (produtos primários). Como exemplo cita-se a formação de centros H<sub>2</sub>O diretamente na fotodestruição de OH em KCl acima de 150 K. Já à 77 K verifica-se a produção de centros U<sub>2</sub> e O nesse mesmo cristal.

## IV.1.1. Criostato e Porta Amostra

Todas as medidas ópticas e tratamentos térmicos das amos tras foram realizados num criostato óptico modelo 8 DT fabricado pela "Janis Research Company, Stoneham Mass". Ele foi projetado para operar com He e/ou N, líquido, possuindo dois tanques concêntricos sendo que no mais externo introduz-se N, líquido e no mais interno He ou N, líquido dependendo das condições experimentais desejadas. Nesse trabalho operou-se com nitrogênio líquido e sólido dentro dos tanques internos do criostato.

O criostato possui três acessos ópticos (janelas ópticas), dois alinhados, permitindo as geometrias paralela e perpendicular ao eixo óptico de medida (figura 7), possibilitando ainda as trocas das janelas de acordo com o tipo de medida e da transparência requerida; na região do infravermelho (janelas de KCl ou infrasil), na região do visível e do ultravioleta (janelas de safira ou suprasil). Em contac to com o banho de He ou N, líquido encontra-se uma ponta tubular de aço inox denominada câmara do gás de troca onde introduz-se gás He para efetuar o contato térmico entre o banho criostático e o porta amostra. No interior dessa câmara existem dois tubos concêntricos de cobre soldados em extremidades opostas sem produzir contato mecânico

entre suas paredes mas que estão suficientemente próximas para facilitar a condutividade térmica quando o gás for introduzido.

Na extremidade oposta à do contato com o banho há um elemento resistor (4w, 25Ω) que é alimentado externamente por um VARIAC ou por um controlador de temperatura modelo DTC-500 da "Lake Shore Cryotronics Inc.", quando for necessário aquecer a amostra de manei ra controlada.

mente de acordo com a tensão aplicada (2 - 10 volts) nos terminais do elemento resistor, combinada com uma mudança na pressão do gás de troca. O porta amostra é constituído por um único bloco de cobre la minado na forma de "L" e preso por quatro parafusos na extremidade da câmara de troca por uma flange de cobre (figura 7) que permite a rotação completa do porta amostra. Para melhorar o contato térmico entre o porta amostra e a extremidade da câmara de troca colocou-se folhas de indium entre as duas superfícies de contato. O porta amos tra pode ser preso na extremidade de modo a satisfazer as condições de geometria paralela ou perpendicular.

### IV.1.2. Preparação das Amostras

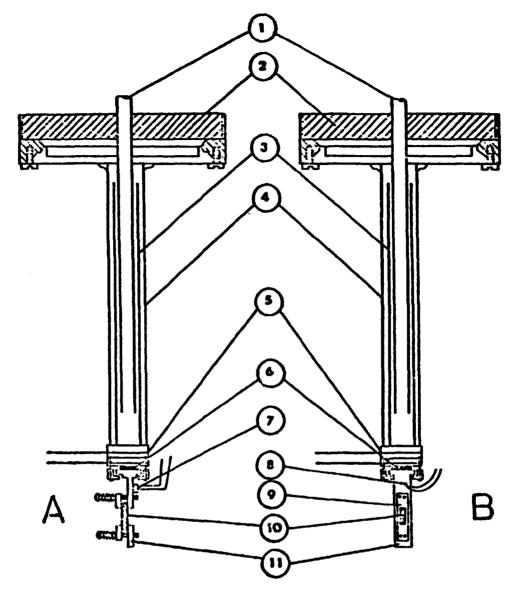
Os cristais de haletos alcalinos utilizados neste trabalho são todos ultrapuros com várias concentrações da impureza OH (- 10<sup>-5</sup> parte/mol), provenientes do "Crystal Growth Laboratory,University of Utah". As amostras foram clivadas no plano (100) com espessuras va riando entre 0,7 mm e 1,02 mm de acordo com o caminho óptico desejado. A seguir a amostra é prêsa ao porta amostra por uma moldura comprimi da por quatro parafusos com molas (figura 7). Para medidas de transições eletrônicas no visível e ultravioleta, a amostra é colocada de acordo com a geometria paralela mostrada na figura 7. Já em medidas de transições vibracionais (no infravermelho) utiliza-se a geometria perpendicular para aumentar o caminho óptico. Para evitar a transposição dos raios de luz de medida (luz espúria) o cristal é mascara do com uma fita adesiva de alumínio.

### IV.1.3. Medida e Controle de Temperatura

A medida da temperatura da amostra é efetuada utilizando-se um termopar de cobre-constantan com referência à 0°C, obtida utilizando-se o "Ice point reference" da "Kaye Instruments" ou gelo pica do. A ponta do termopar (junção entre os dois fios do termopar) foi isolada eletricamente por uma cola GE Varnish 7064 e presa no porta amostra por um parafuso.

As extremidades opostas são conectadas com fios de cobre e

1



câmara do gás de troca e porta amostra

- FIGURA 7. (1) Entrada do gás de troca He.
  - (2) Banho de nitrogênio ou hélio líquido.
  - (3) Tubo concêntrico.
  - (4) Câmara do gás de troca.
  - (5) Elemento aquecedor.
  - (6) Folhas de indium.
  - (7) Termistor.
  - (8) Termopar.
  - (9) Máscara.
  - (10) Amostra.
  - (11) Bloco de cobre.
  - A- Geometria paralela.
  - B- Perpendicular.

colocadas num banho termostático à 0°C ou na referência zero. A corrente elétrica induzida pela diferença de temperatura entre a ponta do termopar e a referência é amplificada e registrada num graficador por 7100 BM "Strip Chart Recorder". O valor da temperatura é obtido utilizando—se uma tabela tipo T da "Omega Engineering Inc.". O êrro na medida da temperatura é estimado em ± 1 K. O controle de temperatura acima de 77 K foi efetuado manualmente variando—se a tensão aplicada no resistor (que está em contato com o porta amostra) e a pressão do gás na câmara de troca. Nesse caso, uma situação de equi 1íbrio é alcançada após uns 20 (vinte) minutos.

A temperatura da amostra pode ser mantida com uma oscilação de - 8% em tôrno da temperatura desejada, com apenas pequenas altera ções na tensão e pressão do gás de troca. Temperaturas abaixo de 77 K foram atingidas solidificando o nitrogenio líquido contido no tanque interno do criostato. Para tal, introduz-se inicialmente uma pequena quantidade de nitrogenio líquido dentro do tanque interno e abaixa-se a pressão de vapor do banho bombeando sobre o nitrogenio líquido com bomba mecânica modelo ED-660 Edwards de grande vazão. À medida que a pressão sobre o N<sub>2</sub> líquido diminue, a temperatura da amostra também diminue e lentamente atinge o valor mínimo de equilíbrio quando o nitrogenio líquido contido no tanque interno do criostato se transfor ma em N<sub>2</sub> sólido. O valor de equilíbrio (- 50 K) é atingido após - 30 minutos do início da operação. A amostra pode permenecer aproximada mente umas 20 (vinte) horas nessa temperatura durante um regime de bombeamento constante.

## IV.1.4. Medidas de Absorção Óptica

dade nas medidas de absorção óptica pois ele pode ser transportado facilmente de um espectrofotômetro para outro. Também pode-se facilmente igualar as alturas dos feixes ópticos do criostato com os dos espectrofotômetros. Para medidas de absorção óptica no intervalo en tre 4000 cm<sup>-1</sup> até 350 cm<sup>-1</sup> utilizou-se um espectrofotômetro do infra vermelho da Perkin-Elmer, modelo PE-180 com duplo feixe. Para medidas de absorção óptica no intervalo entre 2500 nm até 185 nm utilizou-se o espectrofotômetro da Varian, modelo Cary 17D com feixe duplo (um para medida e outro para referência). Cuidados especiais foram toma dos nas medidas na região do infravermelho, tais como evitar a absorção óptica pelo vapor de água da atmosfera ao redor das janelas ópticas do criostato, introduzindo-se nitrogenio gasoso (sêco) no compartimento de medida, a fim de diminuir as absorções indesejadas.

A determinação da concentração dos centros envolvidos nesse

trabalho foi obtida usando-se a conhecida fórmula de Smakula para absorção óptica:

$$Nf = C \frac{n}{(n^2 + 2)^2} K \cdot H$$
 (4)

onde:

 $c = 0.87 \times 10^{17}$  (eV. cm<sup>2</sup>)<sup>-1</sup> (p/ banda com formato de gaus siana)

N = Concentração de defeitos em cm

f = Intensidade de oscilador

n = Índice de refração do cristal na frequência do máximo da banda

K = Constante de absorção (cm<sup>-1</sup>)

H = Largura da banda na metada do seu máximo (eV)

A densidade óptica medida pelo espectrofotômetro está relacionada com a constante de absorção da seguinte maneira: o decréscimo da intensidade da luz ao atravessar a amostra é dada por:

$$I = I_0 e^{-Kd}$$

onde  $I_O$  é a intensidade da luz incidente (referência), Kéa constante de absorção da amostra e d é sua espessura. A densidade óptica (D.O.) é definida como D.O. =  $log \frac{I_O}{I}$ , tal que a constante de absorção seja  $K = \frac{2,303 \times (D.O.)}{d}$ 

## IV.1.5. Métodos de Irradiação

Todos os processos de irradiação e iluminação descritos nesse trabalho foram realizados em baixas temperaturas com as amos tras no criostato. As amostras contendo ions OH foram inicialmente submetidas à um processo de irradiação UV à 50 K ou 77 K com luz monocromática de comprimento de onda próximo do máximo da absorção UV do OH. Para irradiação UV utilizou-se um conjunto "Bausch & Lomb" com lâmpada de Xenon (de alta pressão) de 150 watts proveniente da Hanovia tipo 901C-11, fonte de alimentação e um monocromador B & L com rede de difração de 2700 ranhuras por milimetros. A largura da banda passante é de ~20 nm. Em alguns casos onde necessitou-se de alta intensidade de radiação UV, utilizou-se um conjunto de irradiação da Oriel com lâmpada de xenônio, de alta pressão, de 1000 watts, fonte de alimentação, filtro de água para eliminar a radiação infra Vermelha e filtros de interferência.

# IV.1.6. <u>Tratamento Térmico</u>

Todos os tratamentos térmicos foram realizados com as amos tras dentro do criostato cujo procedimento será descrito à seguir. Retira-se o gás He da câmara de troca fazendo vácuo na mesma explica-se uma tensão constante (4 à 8 volts) nos terminais do elemento resistor para o aquecimento da amostra. Dessa forma, consegue-se elevar a temperatura da amostra de 50 K até 300 K com uma taxa de aquecimento aproximadamente constante e reprodutível. Para esfriar a amostra, desliga-se a tensão aplicada e introduz-se novamente gás He na câma ra de troca.

# IV.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E TÉCNICAS UTILIZADAS NOS ESTUDOS DA INTERAÇÃO DE CENTROS F E ÎONS OH

Monocristais de haletos alcalinos contendo diferentes con centrações de OH e OD, no intervalo de 10 a 10 partes por mol, foram utilizados nesses experimentos. A concentração real de ions OHT e OD foi determinada pela medida da intensidade da absorção óptica vibracional (OH ou OD) usando a calibração quantitativa da referên cia 7 (para o KCl) e a tabela da referência 25 que compara as inten sidades de osciladores e áreas da banda de absorção IR em KCl com as intensidades de osciladores e áreas medidas em outros haletos alcali nos. Os cristais já contendo impurezas OH foram coloridos mente no vapor de potássio metálico sob pressão controlada (de la 10 torrs) para a introdução de centros P na amostra. Após a coloração aditiva, as amostras foram clivadas da parte central e submetidas a um processo de esfriamento rápido (de - 500°C para 20°C em - 2-3 mi nutos) e no escuro, para a produção de somente centros P numa distri buição estatística (distribuição aleatória). Esse processo de resfria mento rápido ("quenching") consiste essencialmente em amostra até - 500°C por uns dois minutos no escuro e resfria-la pos teriormente colocando-se a mesma em contacto com uma placa de cobre fria. Em seguida a amostra é transferida no escuro para o criostato, resfriando-se em seguida para 8 K.

1月日本の大学では著する大学の大学になって

As bandas de absorção foram medidas num espectrofotômetro Varian modêlo Cary 17 DX que mede no intervalo entre 3000 mm até 185 nm. As medidas de emissão F foram feitas utilizando-se o laser de argônio "Spectra Physics" 170 (514 nm p/l.Cl), kryptônio da "Coherent" e "Dye Laser" bombeado pelo laser de argônio a fim de cobrir o intervalo de absorção de centros F em outros haletos alcalinos no intervalo entre 500 nm até 650 nm. Para a detecção da emissão IR dos centros envolvidos (F, P<sub>2</sub>, F<sup>+</sup><sub>2</sub>,...etc...) utilizou-se um detetor de PbS resfriado com gêlo sêco, possibilitando medidas até 3 microns e monocromador

com grades de difração cobrindo a região necessária.

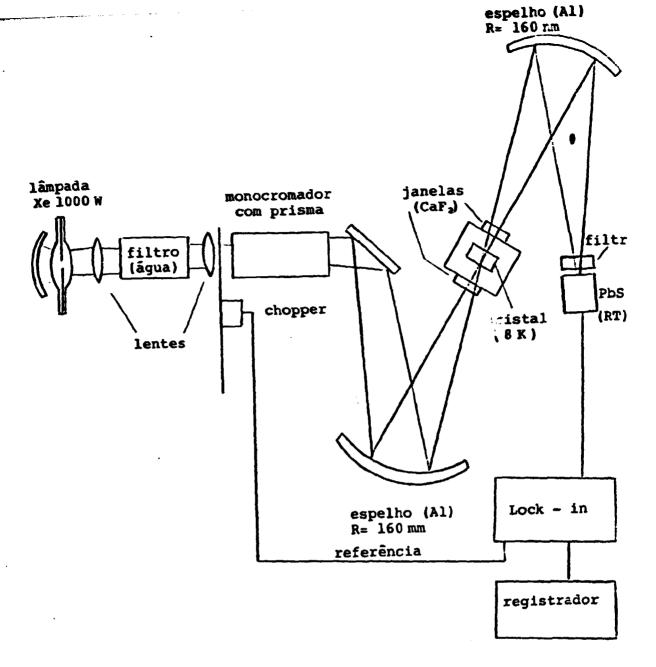
Os espectros de excitação da emissão F e F, em KCl foram medidos utilizando-se um conjunto com lâmpada de Xenon (da Oriel) de 1000 watts e um monocromador KRATOS modêlo GM 252 para trabalhar com luz de alta intensidade (grade com posicionamento automático). A figura 8a mostra o esquema do arranjo experimental utilizado para a medida da emissão infravermelha e excitação.

Todas as medidas de absorção, emissão e de excitação foram realizadas em baixas temperaturas (8 à 10 K) com as amostras presas no "dedo" frio do criostato refrigerador modêlo CSA-202E da Air Products (com ciclo fechado de gás hélio) que produz e estabiliza temperaturas no intervalo de 8 K à 300 K. As medidas de <u>fotocondutividade</u> foram efetuadas em amostras com l milímetro de espessura, sob aplicação de um campo elétrico de de 2000 V/cm. Nessas medidas, as amostras foram iluminadas com luz monocromática (na região da banda F) atravessando a malha fina de metal (40 µ) dos eletrodos que pressionam os dois lados da amostra. A corrente gerada nesse efeito, foi medida utilizando-se um eletrômetro modêlo 610 A da "Keithley". A figura 9 mostra o esquema do porta amostra utilizado na medida da fotocondutividade e a geometria utilizada que permitiu também a medida de absorção óptica além da medida elétrica.

Nos experimentos de absorção F modulada isto é, a técnica de medida do tempo de retôrno do elétron (excitado) através damedida da despopulação do estado eletrônico fundamental, utilizou-se um "dye laser" (- 540 nm) modêlo PL 2001 da "Lambda Physik" bombeado por um laser de excimeros (XeCl) pulsado, - 3 MW, - 10 ns, frequência de repetição de 10 HZ modêlo EMG-102 da "Lambda Physik". Esse feixe de luz pulsada de curta duração e de alta intensidade em 540 nm foi utilizado para produzir uma despopulação instantânea do estado funda mental do centro F. A mudança (aumento e decréscimo) da transmissão óptica da amostra na posição da banda F foi medida por um feixe de luz laser de 514 nm proveniente do laser de argônio operando em CW. O efeito do pulso de excitação no feixe de medida da transmissão F foi monitorado por um detetor de silício (tempo de resposta - 1 ns) e resolvido temporalmente por um osciloscópio.

A figura 8b mostra o esquema do arranjo experimental utilizado nesses experimentos. Em alguns casos utilizou-se o mesmo arranjo experimental porém, sem a utilização do laser de argônio, para a observação direta do tempo de vida da emissão F.

the same of



PIGURA 8 (a). Diagrama de blocos (esquemático) do arranjo experimental utilizado nas medidas da emissão IR e excitação (UV e IR) de centros de cor.

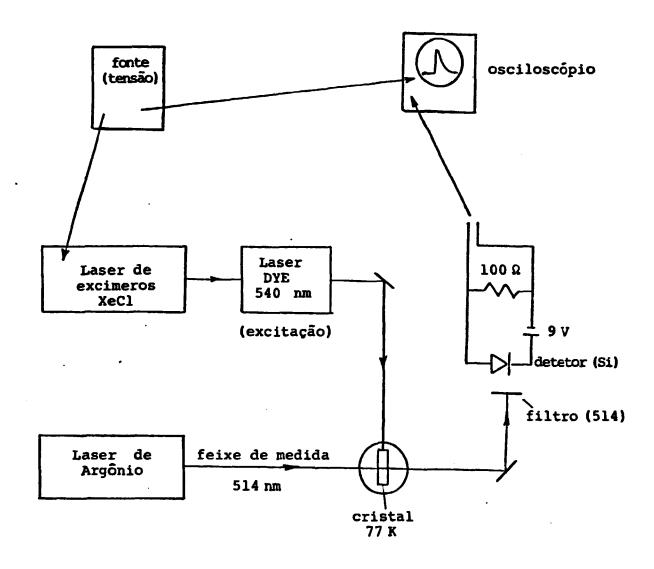


FIGURA 8 (b). Diagrama de blocos (esquemático) do arranjo experimental utilizado nas medidas de despopulação do estado fundamental do centro F.

· 大きなのでは、これは、大きなななないのである。

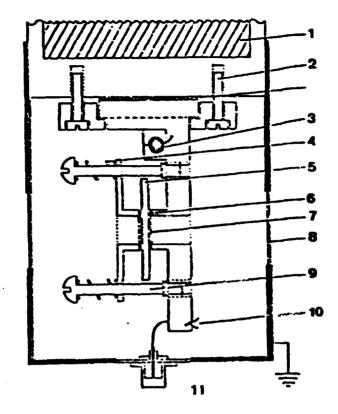


FIGURA 9. Esquema do porta amostra utilizado nas medidas da fotocon dutividade de amostras de KCl contendo centros P e lons OH.

- (1) N. liquido.
- (2) Parafusos de nylon.
- (3) Resistor.
- (4) Molas.
- (5) Cristal.
- (6) Folhas de indium.
- (7) Tela de metal (40  $\mu$ ).
- (8) Janelas de Suprasil.
- (9) Parafusos de nylon.
- (10) Termopar isolado eletricamente do bloco de cobre.
- (11) Conector tipo BNC para coletar o sinal de medida.

Até o presente sabe-se que o ion OH substitucional nos ha letos alcalinos se fotodissocia sob irradiação UV ressonante com a absorção eletrônica OH em temperaturas baixas produzindo o centro U2 (átomo de hidrogênio neutro intersticial, H<sub>1</sub>0) e o centro O<sub>S</sub> (ion de oxigênio negativo situado na posição substitucional). Neste capítulo será mostrado porém que os produtos primários da fotodissociação de OH em temperaturas baixas dependem do parâmetro da rede hospedeira. Por exemplo, demonstramos que em redes com espaço intersticial com volume correspondente maior do que ~ 20 Å<sup>3</sup> (diferença entreo volume da célula convencional e o volume ocupado pelos ions) ocorre a formação de centros F e moléculas OH intersticiais. Esses resultados serão mostrados e discutidos no desenrolar deste capítulo que tratará da formação, estabilidade térmica e fotoreações dos produtos e sub - produtos da fotodecomposição do ion OH em vários haletos alcalinos es tudados por medidas ópticas.

#### V.1. Fotodissociação do OH em RbCl e KBr

Inicialmente as amostras puras de RbCl e KBr contendo bai xas concentrações de ions OH (- 10 /mol) foram clivadas e colocadas num criostato para medidas ópticas em temperaturas baixas (50 - 300 K). A figura 10 mostra os resultados obtidos no processo de fotodissocia ção de OH à 77 K em RbCl por luz monocromática ressonante com o máximo da banda de absorção OH em 212 nm. Inicialmente esse cristal apresenta somente uma banda de absorção localizada em 212 nm devida aos centros OH presentes na rede. A medida que se aumenta o tempo de irradiação UV na banda OH (figura 10, curvas de 1 à 5), as bandas de absorção U<sub>2</sub> (em 242 nm) e O (e. 192 nm) crescem. Consequentemente a banda OH decresce. A figura inserida na figura 10 mostra um: correlação linear obtida entre o crescimento das bandas U, e O. Essa função linear obtida indica que ambos defeitos são produzidos por um só mecanismo. O mesmo tipo de comportamento foi também observado para a fotodissociação de OH em KBr. Nesse cristal (KBr) observou-se a formação de centros U2 e 0 cujos máximos das bandas de absorção localizam-se em 270 nm el96 nm respectivamente.

A figura 11 mostra também a correlação linear verificada entre os crescimentos das bandas  $U_2$  e  $O_2$  para KBr.

Os resultados até aqui apresentados estão de acordo com o mecanismo de fotodissociação do OHT presentemente aceito por outros autores. A detecção de átomos de hidrogênio intersticiais (centros

u,) tem sido comprovada por medidas de ENDOR no KCl\*3. Por outro lado, a configuração estrutural do ion negativo de oxigênio produzido dire tamente na fotodissociação do OH não tem sido investigada sistemati camente nos haletos alcalinos. Encontrou-se somente alguns trabalhos que utilizaram medidas magnéticas (ENDOR) para a rede de RbCl foi concluído que o ion O localiza-se na posição substitucional fo ra de centro<sup>56</sup>. De um modo geral é presentemente aceito que o ion o se localiza na posição substitucional na rede dos haletos nos. A banda de absorção desses ions (0) não tem sido também siste maticamente medida para as diversas matrizes dos haletos alcalinos. Dessa forma a medida das bandas Os realizadas (neste trabalho) RbCl e KBr e a correlação linear obtida entre o aumento dessa banda e o aumento da banda U, constituem um fato importante na sequência de experimentos para o entendimento da fotodissociação de OH nos haletos alcalinos.

Visando uma melhor compreensão do comportamento do ion de oxigênio substitucional submeteu-se o cristal de KBr previamente fotodissociado (como mostrado na figura 11) à uma irradiação (λ 200 nm) intensa à 50 K com uma lâmpada de Xenon de 1000 W. Apenas algumas exposições de curta duração (~ minutos) da amostra à irradiação produziram a destruição da banda Os (em 196 nm) e a forma ção da banda a em 202 nm (absorção eletrônica proveniente de vacân cias aniônicas). A figura 12 mostra a formação de vacâncias aniônicas (banda  $\alpha$ ) as expensas dos fons  $O_s^-$  (banda  $O_s^-$ ). Observa-se também aumento do fundo de absorção em  $\lambda \stackrel{<}{\sim} 190 \, \text{nm}$  (curvas 1  $\rightarrow$  6 da figura 19). A figura inserida na figura 12 mostra a correlação linear obtida entre o crescimento da banda a e o aumento da absorção de fundo ( me dida pelo aumento da absorção em 191 nm). Esse importante pois mostra que o fon O produzido inicialmente na posição substitucional (na fotodissociação OHT), quando excitado pode disso ciar-se da vacância produzindo um ion 0 na posição intersticial e uma vacância aniônica. Esses resultados mostram que a ions de oxigênio intersticiais é responsável pelo aumento da absorção em  $\lambda \stackrel{<}{-}$  190 nm que ocorre em paralelo à produção da banda  $\alpha$ .

### V.1.1. <u>Fotodestruição dos Centros F Produzidos pela Destruição</u> <u>Térmica de Centros H.O</u>

Os centros H<sub>2</sub>O (também conhecidos como centros F molhados<sup>69</sup>) podem ser produzidos pela destruição térmica dos centros de hidrogênio U<sub>2</sub> e U<sub>2X</sub>, respectivamente à 100 K e à 180 K em KBr contendo fons OH previamente fotodissociados em temperaturas menores do que 100 K<sup>47</sup>. Estes centros são instáveis termicamente (mesmo no estado eletrônico

COMA NUCLEAR SE

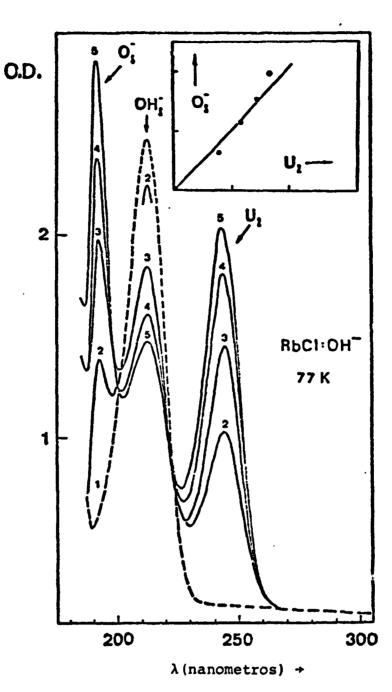


FIGURA 10. Fotodissociação de OH em RbC1:OH à 77 K.

- 1. Espectro inicial medido antes da irradiação UV.
- 2. Espectro após 5 horas de irradiação UV(213 nm) com Xe 150 W.
- 3. Ídem após 11 horas.
- 4. Ídem após 16 horas.
- 5. Idem após total de 21 horas.

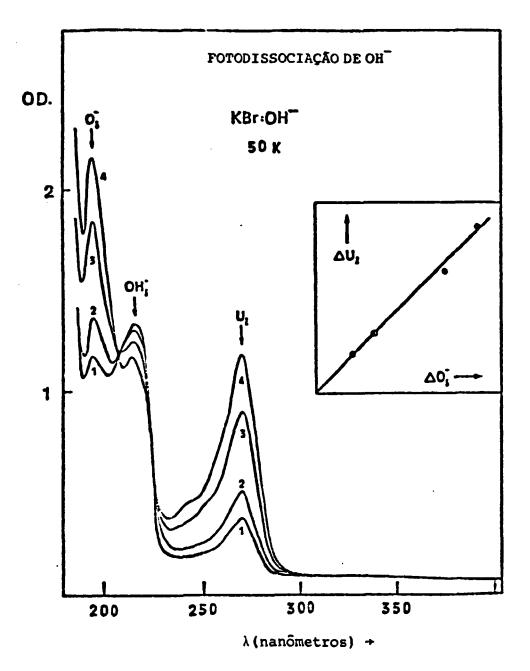


FIGURA 11. Fotodissociação de OH em KBr:OH à 50 K.

- 1) Após 17 horas de irradiação UV(OHT) em 214 nm com Xe 150 W.
- 2) Após 21 horas (ídem).
- 3) Após 38 horas (idem).
- 4) Após total de 54 horas (idem).

A figura inserida mostra que o crescimento da banda  $O_S^-$  está correlacionado linearmente com o crescimento da banda  $U_2$ .

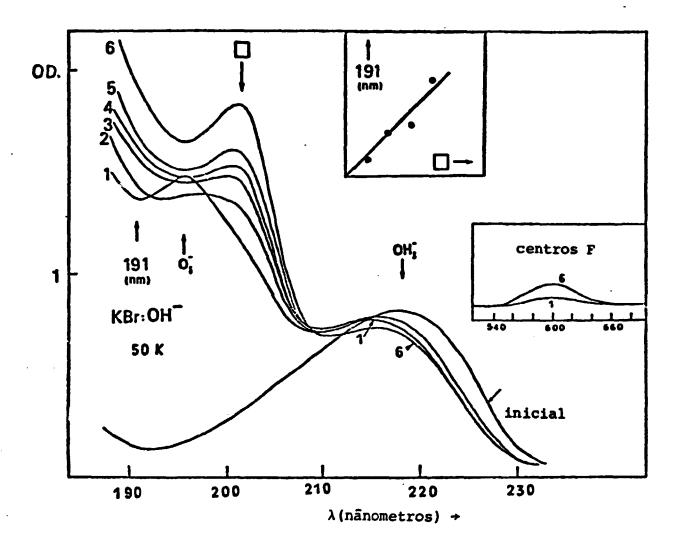


FIGURA 12. Fotodestruição dos centros Os à 50 K.

Intensa irradiação UV com lâmpada de Xe 1000 W filtrada com filtro de interferência em 200 nm.

- Espectro absorção após a fotodissociação de OH a 50 K com Xe 150 W.
- 2) Após 15 segundos de iluminação UV (200 nm) com Xe 1000 W.
- 3) Após mais 40 segundos.
- 4) Após maos 50 segundos.
- 5) Após mais 60 segundos.

fundamental) e dão origem à formação de centros F e átomos de hidro gênio e de oxigênio neutros ocupando posições intersticiais na rede. Em redes com grande espaço intersticial (a<sub>i</sub> > 2,7 Å) acredita-se que ocorra a formação de moléculas OH intersticiais nesse processo. As propriedades ópticas, formação e destruição térmica de H<sub>2</sub>O nos hale tos alcalinos foram intensamente estudadas no trabalho da referência.

Portanto a destruição térmica de centros H<sub>2</sub>O à 300 K em KBr produz centros F, átomos de oxigênio neutros intersticiais e átomos de hidrogênio (centros U, termicamente instáveis que produzem moléculas de H<sub>2</sub>). Verificou-se porém que o átomo de oxigênio nesse caso está localizado próximo do centro F pois ele captura o elétron excitado (2p) do centro F durante o processo de excitação óptica da banda F à 50 K. Em paralelo a isso ocorre formação de centros α (absorção máxima em 202 nm). A figura 13 mostra claramente os resultados obtidos. Em paralelo à destruição óptica dos centros Fe formação de centros α observa-se o decréscimo gradativo da banda β em 192 nm. Esse comportamento da banda em 192 nm está de acordo como comportamento esperado para a banda β que é produzida pela transição de estados de excitons perturbados e localizados na vizinhança do centro F. Com a extinção dos centros F, a banda β também é extinta.

Com a finalidade de verificar a estabilidade térmica dos ions de oxigênio produzidos pela captura dos elétrons F\*, efectiou-se um tratamento térmico pulsado do cristal no escuro, após o "bleaching" dos centros F. A figura 14 mostra claramente que -54% dos centros F inicialmente fotodestruídos são recuperados após o pulso de tempera tura até 350 K. O efeito principal observado é a destruição dos tros α em 202 nm e a formação dos centros F devido à recaptura dos elétrons F\* (termicamente liberados dos fons O intersticiais) pelas vacâncias aniônicas. Houve também nesse caso, formação parcial centros OH substitucionais como o esperado pela reação termicamente ativada envolvendo o centro F, o átomo de oxigênio neutro intersticial e a molécula de H, intersticial. As figuras inseridas na figura mostram as correlações obtidas na formação das bandas F, β e 199 nm e a destruição da banda α. Com o aumento de temperatura 200 K, a vacância aniônica torna-se móvel podendo aproximar-se do fon O intersticial produzindo uma configuração intermediária O ( ) e estável até -260 K. Nessa configuração, a perturbação da vacância Produz um abaixamento da energia da transição eletrônica do fon O intersticial deslocando-a de  $\lambda$  < 190 nm para  $\lambda$  = 199 nm. Essa nova Configuração produz a nova banda de absorção em 199 nm e deve ser Visualizada como uma troca de carga eletrônica entre o ion 0 e a Vacância aniônica. Essa é uma configuração intermediária no processo ativado termicamente de recuperação dos centros F.

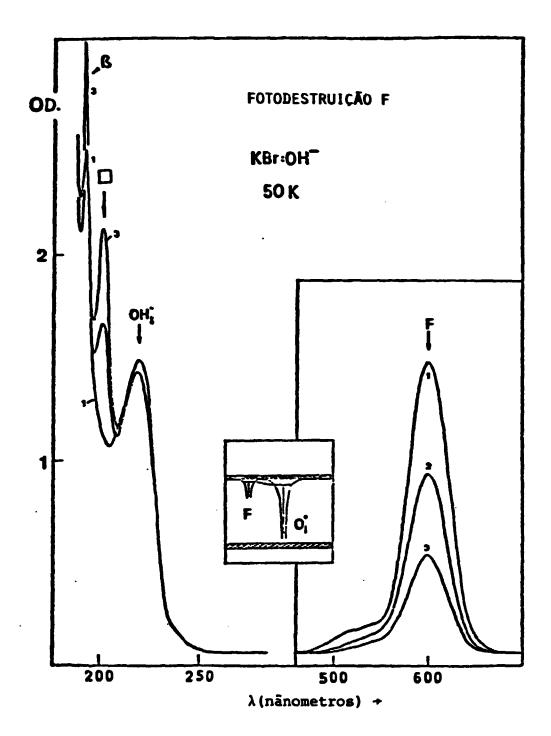


FIGURA 13. Fotodestruição dos centros F(em KBr à 50 K) provenientes da destruição térmica de centros H<sub>2</sub>O<sup>-</sup>.

- 1) Após destruição térmica de H2O.
- 2) Após 3 horas de iluminação na banda F(à 50 K) com Xe150W + filtros de absorção KG-4, GG-395 e vidro de 5 mm de espessura.
- 3) Após mais 2 horas de iluminação F(idem).

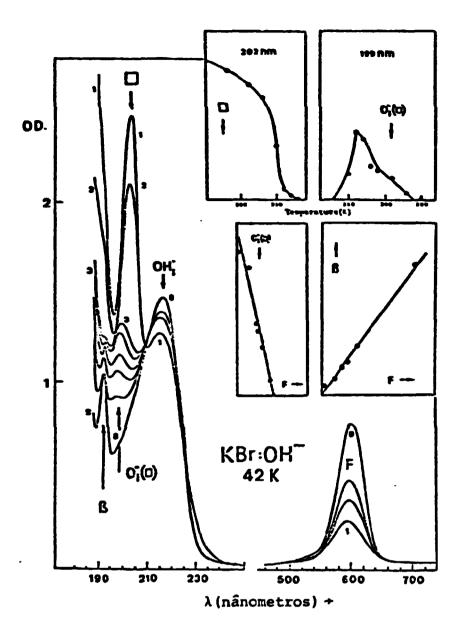


FIGURA 14. Tratamento térmico pulsado no KBr:OH previamente submetido à uma fotodestruição de F. Observa-se principalmente a destruição térmica dos centros α (202 nm).

- Espectro inicial medido à 42 K após destruição óptica dos centros F.
- 2) Após pulso até 231 K.
- 3) Após pulso até 260 K.
- 4) Após pulso até 270 K.
- 5) Até 280 K.
- 6) Até 310 K.
- 7) Até 329 K.
- 8) Até 350 K.

As seguintes equações resumem as reações fotoquímicas observadas para o RbCl e KBr:

1. Fotodissociação de OH

$$OH^{-}$$
 + hv  $(OH^{-})$   $\frac{50 \text{ K}}{}$   $O^{-}$  +  $H_{1}^{0}$ 

2. Fotodestruição de Os

$$0^-$$
 + hv( $0^-$ )  $\frac{50 \text{ K}}{(\text{Xe } 1000 \text{ W})}$  +  $0_1^-$ 

3. Destruição Térmica de H2O

$$H_2O^-$$
 + KT (300 K)  $\frac{100 \text{ %}}{}$   $e^-$  +  $O_1^0$  +  $(H_2)_1$ 

4. Fotodestruição de F

$$e^{-}$$
 +  $O_{i}^{0}$  + hv (F)  $\frac{64 \%}{}$  +  $O_{i}^{-}$ 

5. Destruição Térmica de  $\alpha$ 

$$+ O_{i}^{-} + KT (260 \text{ K}) \longrightarrow O_{i}^{-} ( )$$

6. Destruição Térmica de O ( )

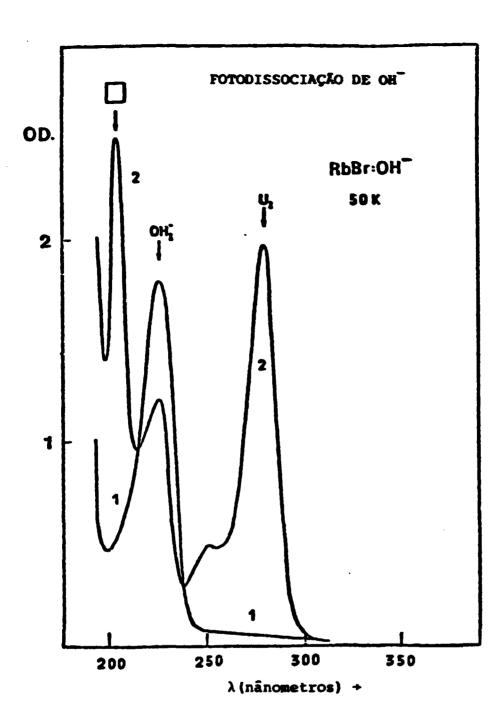
$$0_{1}^{-}$$
 ( ) + KT (> 260 K)  $\frac{56 \%}{}$   $e^{-}$  +  $0_{1}^{0}$ 

#### V.2. FOTODISSOCIAÇÃO DE OH EM RBBr

· 一、行の水子行いたからかられているないないないでは、

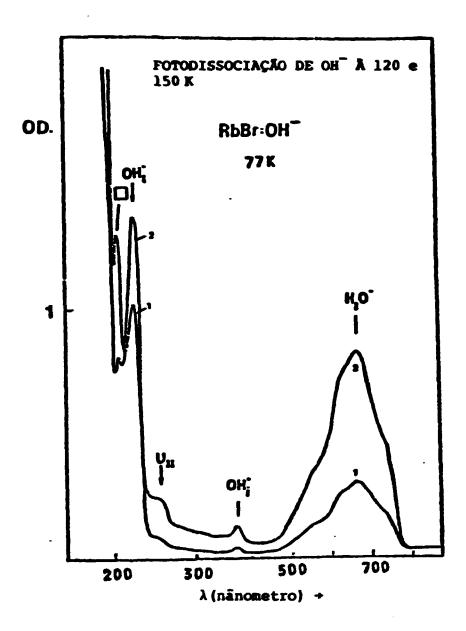
A fotodissociação UV em 226 nm de ions OH em RbBr ( $\infty$ m10<sup>-4</sup> OH) à 50 K produz diretamente centros  $\alpha$  (com máximo de absorção em 206 nm) e centros U<sub>2</sub> (em 280 nm). Esses resultados são mostrados na figura 15. Nessa rede onde o espaço intersticial é maior do que em KBr ( $\alpha_{1}$ = 2,69 Å > 2,54 Å) tanto o átomo de hidrogênio intersticial (centro U<sub>2</sub>) como o ion de oxigênio deixam a vacância e estabilizam-se numa posição intersticial.

Efetuou-se também a fotodissociação de ions OH em RbBr em altas temperaturas: 120 e 150 K. Nesse caso observou-se a formação direta de centros  $\rm H_2O^-$  e  $\rm U_{2x}$  (veja a figura 16) como consequência da



PIGURA 15. Fotodissociação de OH em RbBr:OH à 50 K.

- 1) Espectro inicial medido à 50 K.
- 2) Espectro medido após 17 horas de irradiação UV(OH<sup>-</sup>) em 226 nm com Xe 150 W.



PIGURA 16. Potodissociação de ions OHT em temperaturas altas: 120 e 150 K.

- 1) Após 2 horas de irradiação UV(226 nm) à 120 K com Xe 150 W.
- 2) Após mais 2 horas de irradiação UV (idem) à 150 K.

instabilidade térmica dos centros U, em temperaturas acima de 100 K. COMO consequência da instabilidade térmica dos centros U, à 150 K, observou-se também a formação de uma nova banda de absorção em 360 nm. A correlação dessa banda com a produção de ions OH intersticiais foi estudada em maiores detalhes para o caso do KI.

### v.2.1. <u>Potodestruição dos Centros F Produzidos na Destruição Térmica de Centros H.O</u>

Como já foi mencionado anteriormente na Seção V.1.1., centros H,0 (que são produzidos na destruição térmica dos centros U,) podem ser destruídos termicamente à 300 K produzindo centros F, áto mos de oxigênio e moléculas H, intersticiais. Dessa maneira efetuouse a destruição óptica desses centros F iluminando-se a amostra com luz monocromática F à 77 K. A figura 17 mostra os resultados obtidos em RbBr. Igualmente ao que foi observado no KBr, ocorre a formação da banda α em 206 nm e a destruição das bandas F e β(em 197 nm). A fi gura inserida na figura 17 mostra a correlação linear obtida entre o crescimento da banda o e a diminuição das bandas F e \beta. Tambén aumento da absorção de fundo em 194 nm está correlacionado com o au mento da banda a. Isso mostra indiretamente que os ions negativos de oxigênio intersticiais devem introduzir uma banda de absorção resolvida) localizada na região da absorção fundamental do cristal (absorção de excitons) produzindo somente um aumento do "background" en λ - 194 nm.

Um outro aspecto importante desses resultados é que a banda α produzida inicialmente na fotodissociação de OH écoincidente com a banda α produzida na fotodestruição dos centros F mostrando consistência e justificando assim a atribuição feita inicialmente de que a banda em 202 nm produzida na fotodecomposição de OH (inicial) é devida aos centros α.

A seguir são relacionadas as equações que descrevem as rea ções fotoquímicas mais importantes observadas para o RbBr:

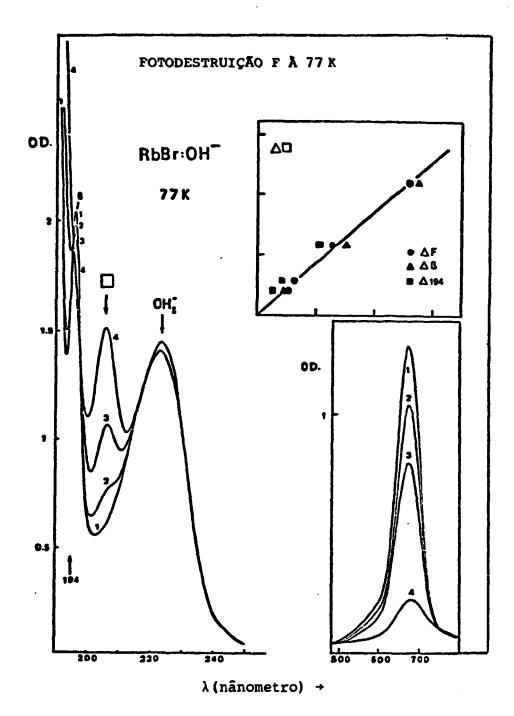
#### 1. Fotodissociação de OH

1 12

$$OH^{-}$$
 + hv( $OH^{-}$ )  $\frac{50 \text{ K}}{}$  +  $O_{1}^{-}$  +  $H_{1}^{+}$ 

2. Destruição Térmica de H<sub>2</sub>O e Formação de F à 300 K

$$H_2O^2 + KT (300 K) = 0.0 + 0.0 + (H_2)_1$$



おという のなかけいないない からないこと

とうないとうとなるとう 一次はないないというないという

FIGURA 17. Destruição óptica dos centros F produzidos na destruição térmica de centros H<sub>2</sub>O em RbBr.

- 1) Após a destruição térmica de H<sub>2</sub>O à 300 K.
- 2) Após 35 minutos de iluminação (à 77 K) monocromatica em 675 nm com luz do espectrofotômetro Cary 17 D (com fenda 3 mm).
- 3) Após mais 35 minutos (idem) com lâmpada Xe 150 W + mono cromador.
- 4) Após mais 50 minutos com Xe 150W+ filtro de absorção KG-4 e vidro de 6 mm espessura.

#### 3. Fotodestruição de Centros F à 50 K

$$e^{-} + O_{1}^{0} + hv(F) - \frac{50 K}{82 *} + O_{1}^{-}$$

## v.2.2. Destruição Térmica dos Centros α e Reconstituição dos fons OH

Os centros a produzidos na destruição óptica dos centros F (discutida na seção anterior) foram destruídos termicamente 220 K e 300 K (veja os resultados mostrados na figura 18 - lado querdo). Exatamente como foi verificado no caso do KBr, observou-se no RbBr a recuperação dos centros F fotodestruídos. Observa-se bém a formação da banda β e o decréscimo da absorção em 194 nm (discu tida na seção anterior 2.1.). Poucos centros OH são produzidos duran te esse processo. A figura 18 - lado direito mostra o aumento da banda OH e o decréscimo das bandas F e β em função do tempo acumulado de exposição da amostra (previamente submetida à uma destruição térmica total dos centros a) à temperatura ambiente e no escuro. Após cada período de tempo de exposição à 300 K (no escuro) a amostra resfriada à 77 K para a medida do espectro de absorção entre 185 nm e 2000 nm. Esse processo de recuperação dos ions OHT fotodissociados é lento e envolve possivelmente o movimento térmico do centro F cuja energia de ativação para uma troca de posição com o ion de Cl é l eV. Esses resultados mostram claramente que não ocorre formação de nenhuma configuração intermediária envolvendo o átomo de oxiqênio antes da formação do ion OH e que a configuração do átomo de oxigê nio neutro deve ser bastante estável termicamente pois a recuperação OH é lenta e compatível com a velocidade da difusão centros F por saltos. As seguintes equações explicam os resultados Obtidos:

#### 1. Destruição Térmica dos centros α e Formação de F

$$O_{1}^{-} +$$
 + KT  $\xrightarrow{> 240 \text{ K}} - O_{1}^{0} + e^{-}$ 

2. Reconstituição dos fons OH

$$e^-$$
 +  $O_1^0$  +  $\frac{1}{2}$  H<sub>2</sub> + KT  $\frac{300 \text{ K}}{}$  OH

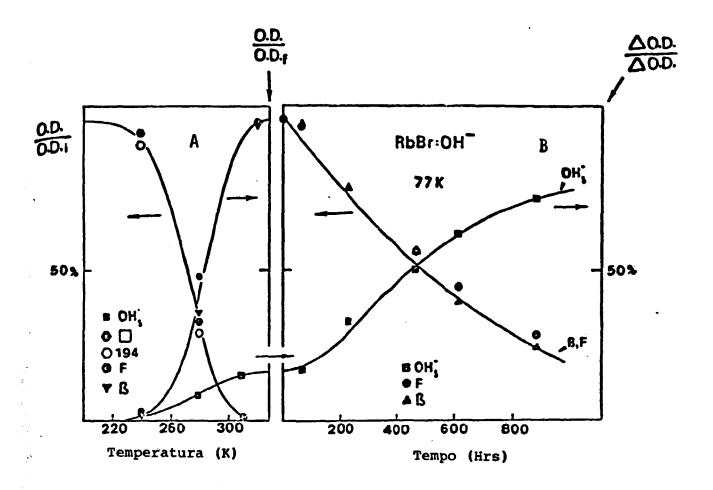


FIGURA 18. A- Destruição térmica de centros α (205 nm) em RbBr produzidos na destruição óptica da banda F e produção de centros F, β.

B- Reconstituição dos centros OH em RbBr à 300 K (no es curo) às custas dos centros F, em função do tempo de exposição à 300 K (no escuro). As medidas de absorção nesse caso foram sempre efetuadas com amostra à 77 K.

A fotodissociação de OH em amostras de KI contendo baixas concentrações de OH (~ 10 ° OH) apresentou resultados ainda mais surpreendentes. Observou-se um mecanismo novo que produz centros F as expensas dos ions OH excitados à 77 K. Nesse caso, não se observa os centros U, ou qualquer outro centro correlacionado com o aprisionamento dos átomos de hidrogênio intersticiais. Também não se observou qualquer outra banda de absorção na região do ultravioleta (outra além da banda α em 238 nm aqui produzida) que pudesse ser atribuída aos centros de oxigênio. Também as medidas de absorção na região do infravermelho distante até ~ 350 cm 1 não apresentaram bandas de absorção que pudessem ser atribuídas aos modos locais introduzidos por defeitos de hidrogênio. Observou-se porém a formação clara de uma banda em 312 nm correlacionada com a formação das bandas F e α(238 nm). A figura 19 mostra os efeitos observados na fotodissociação de OH em KI à 77 K.

A fim de verificar se a produção de centros F observada em KI:OH não era um efeito do dano de radiação na sub rede aniônica do KI, irradiou-se uma amostra pura de KI (sem ions OH) nas mesmas con dições à 77 K. Nesse caso observou-se uma pequena produção de centros F desprezível com relação à produção observada no KI contendo OH, veja os resultados mostrados na figura 20. Por outro lado, a fotodis sociação de OH em KI à 50 K apresenta-se normal isto é, ocorre a quebra da ligação O-H resultando num ion de oxigênio negativo e num átomo de hidrogênio (centro U<sub>2</sub>). Nesse caso, ambos produtos abandonam a vacância e estabilizam-se em posições intersticiais. O mecanismo observado à 50 K é o mesmo que ocorre na fotodissociação de OH em RBBr com a diferença de que no KI os centros U<sub>2</sub> são menos estáveis termicamente.

Dessa maneira, mesmo durante o processo de fotodissociação de OH eles (centros U<sub>2</sub>) decaem produzindo configurações mais está veis como a configuração do centro U<sub>2x</sub> (átomo de hidrogênio aprisio nado na segunda vizinhança do íon OH substitucional) e docentro H<sub>2</sub>O (átomo de hidrogênio aprisionado pelo centro OH). A figura 21 mostra os resultados obtidos na fotodissodiação de OH em KI à 50 K. Nesse caso observa-se também a formação de centros α em 238 nm. Irradiações UV mais prolongadas conduzem a uma formação de centros U<sub>2x</sub> e H<sub>2</sub>O como discutido no parágrafo anterior. O importante é notar que à 50 K ocorre formação de centros de hidrogênio do tipo U<sub>2x</sub> e H<sub>2</sub>O (e a não formação de centros F) o que mostra claramente que o mecanismo de fotodissociação de OH à 50 K conduz à dissociação da molécula (CH) enquanto que à 77 K o mesmo processo de fotodissociação do OH não

produz a quebra da ligação O-H da molécula (OH) e sim sua ionização, por retirada do seu elétron mais externo.

A fim de confirmarmos que os centros F produzidos no proces so de fotodissociação de OH à 77 K em KI não provém da destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O, efetuou-se um estudo da estabilidade térmica dos produtos primários e secundários produzidos na fotodissociação de OH à 50 K. Os resultados desses estudos (por técnica de tratamento térmico pulsado) são mostrados na figura 22.

Primeiramente os centros U, produzidos na fotodissociação OH à 52 K são termicamente destruídos à 70 K produzindo centros U2x e H2O. Posteriormente os centros U2x (mais estáveis do que os centros U2) são termicamente destruídos à 180 K produzindo mais centros H2O. Finalmente os centros H2O são termicamente destruídos à 260 K produzindo centros F. Esse resultado é muito importante e vem confirmar que os centros F produzidos já na fotodissociação OH em KI à 77 K não podem ser provenientes da instabilidade térmica dos centros H2O du rante o processo de fotodissociação OH (77 K) pois foi provado que os centros H2O são estáveis termicamente em KI até ~ 250 K.

Numa segunda etapa mediu-se cuidadosamente o estiramento do ion OH através da medida da absorção infravermelha localizada em 2774,6 nm com uma resolução de 1 nm na região da banda. utilizou-se um cristal de KI contendo uma concentração de OH aproxi madamente 10 vêzes maior (- 10 OH ) do que a normalmente utilizada. Todas as medidas de absorção infravermelha foram efetuadas à 8 K sando uma maior resolução de possíveis perturbações na banda OH que sofre uma drástica redução na sua largura a temperaturas líquido. A figura 23 mostra a produção acentuada de centros F obtida na fotodissociação de OH à 77 K nessa mesma amostra. A figura mostra as alterações produzidas na banda de absorção do estiramento do OH após a fotodissociação OH à 77 K (curva cheia). A banda inicial posicionada em 2774,6 nm é reduzida de 34% do valor e uma nova banda surge localizada em 2765 nm e deslocada para energia maior com relação à posição da absorção do estiramento do OHT perturbado (deslocamento de - 0,0015 eV). A figura 24 mostra o efeito da temperatura (curva 1 + 10 K, 2 + 50 K, 3 + 90 K, 4 + 130 K) posição da banda em 2765 nm e compara com o efeito conhecido da tem peratura no modo de estiramento do Ion OH substitucional.

As seguintes observações experimentais mostram que essa banda IR (nova) em 2765 nm é devida à absorção do estiramento da ligação O-H em sua nova configuração: ou seja, de molécula OH<sup>0</sup> intersticial ou de fon OH<sup>-</sup> intersticial produzidos no processo de fotodissociação de OH<sup>-</sup> em KI à 77 K. Essas observações são enumeradas a seguir:

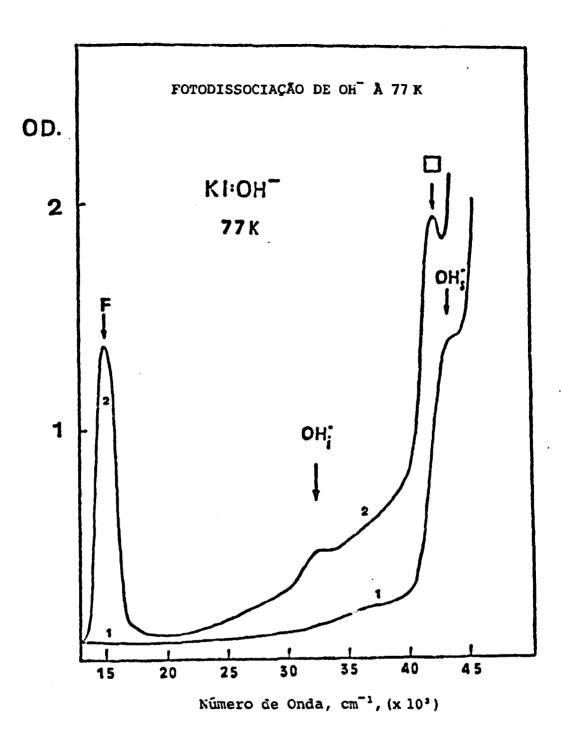


FIGURA 19. Fotodissociação de OH em KI:OH à 77 K.

- 1. Espectro inicial medido à 77 K.
- 2. Após 15 horas de irradiação UV (OHT) monocromática em 230 nm com Xe 150 W.

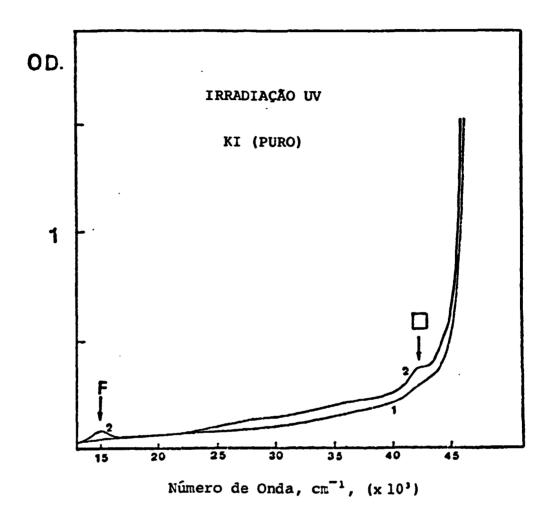


FIGURA 20. Efeito da irradiação UV em KI puro da Harshaw à 77 K.

- 1) Espectro inicial.
- 2) Após 16 horas de irradiação UV em 230 nm com Xe 150 W.

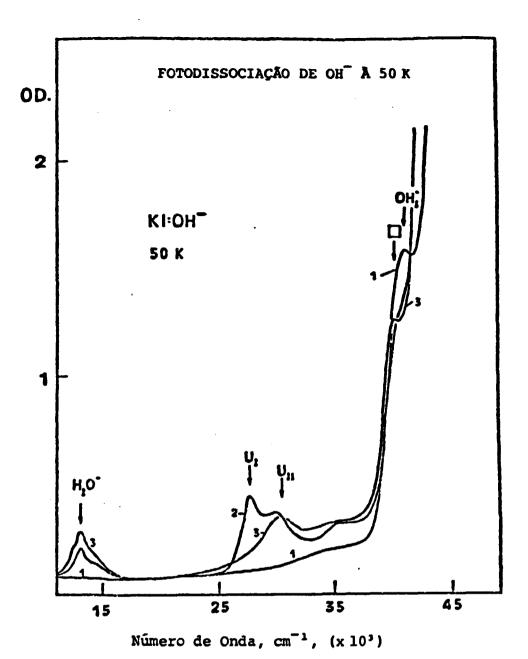


FIGURA 21. Fotodissociação de OHT em KI à 50 K.

- 1) Espectro inicial medido à 50 K.
- 2) Após 12 horas de irradiação UV(OHT) monocromática em 230 nm com Xe 150 W.
- 3) Após mais 16 horas de irradiação UV (OHT) à 50 K.

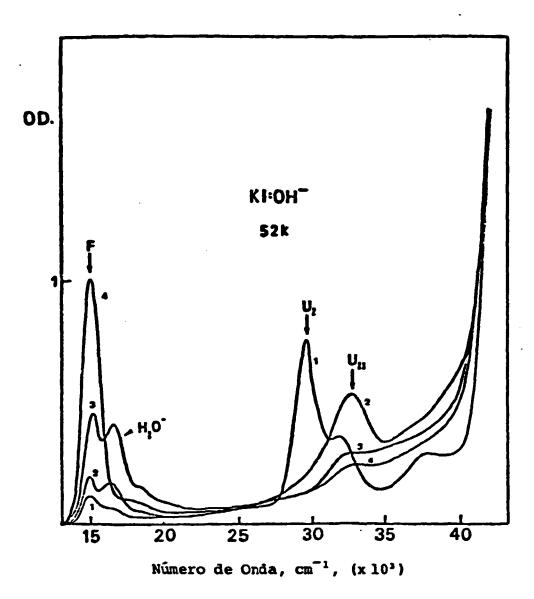
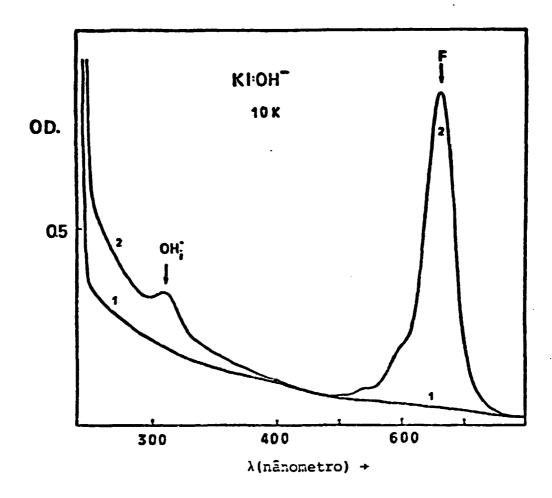


FIGURA 22. Estabilidade térmica dos produtos da fotodissociação de OHT à 50 K.

- Após fotodissociação de OH à 50 K (irradiação UV (230 nm) durante 15 horas com Xe 150 W).
- 2) Após pulso de temperatura até 67 K.
- 3) Pulso até 177 K.
- 4) Pulso até 260 K.



PIGURA 23. Produção de centros F em KI (contendo alta concentração de OH - 10 mol %) à 77 K.

- 1) Espectro inicial.
- 2) Após 15 horas de irradiação UV(OHT) monocromática em 230 nm com Xe 150 W.

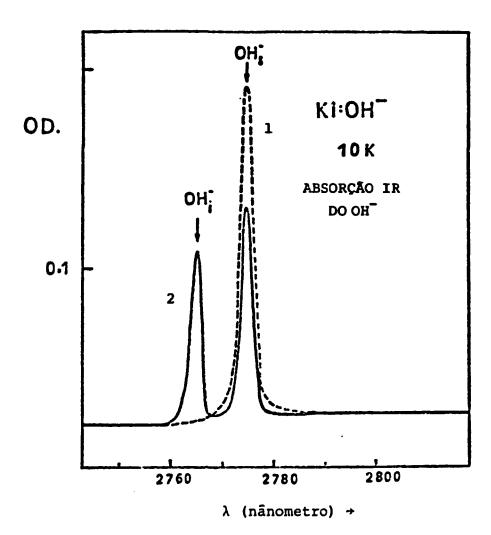
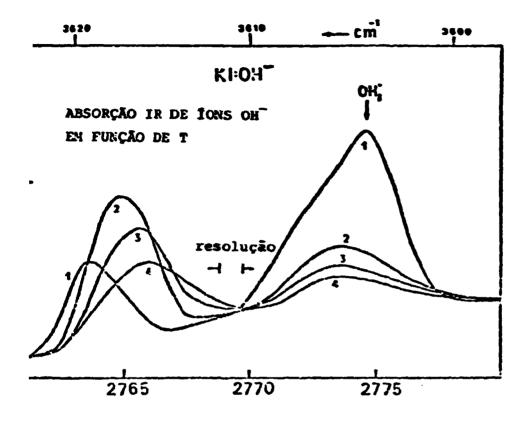


FIGURA 24.(a). Medida da absorção infravermelha do fon OH substitucional OH em KI contendo 10 mol % de OH, à 10 K com o espectrofotômetro Cary 17 DX.

- 1) Espectro IR inicial à 10 K.
- 2) Após 15 horas de irradiação UV(OHT) em 230 nm à 77 K.



λ (nânometro) →

- (b). Efeito de temperatura nas bandas de absorção IR de ions OH em KI fotodissociado.
  - 1) Medida à 10 Kapós 15 horas de irradiação UV (CHT) em 230 nm (à 77 K) com Xe 150 W.
  - 2) Medida à 50 K.
  - 3) A 90 K.
  - 4) À 130 K.

- 1. A banda IR em 2765 nm é produzida somente na fotodissocia ção de OH em temperaturas acima ou da ordem de 77K (não é produzida na fotodissociação à 50 K) indicando que esse mecanismo de produção de centros F (e consequentemente da banda IR em 2765 nm) é um processo assistido por fo nos.
- Essa banda IR é produzida juntamente com a formação de centros P e α onde não se observa centros de hidrogênio e de oxigênio separadamente.
- 3. Seu máximo de absorção se localiza no lado de maior ener dia da banda de absorção do modo de estiramento docentro OH, como o esperado para uma molécula OH situada numa posição intersticial cujo espaço disponível (intersticial) foi reduzido de 36% do espaço substitucional.

# V.3.1. <u>Fotodestruição dos Centros F (à 50 K) Produzidos Diretamente</u> <u>na Fotodissociação de OH à 77 K ou Indiretamente na Des-</u> <u>truição de Centros H,O à 300 K</u>

A destruição óptica dos centros P produzidos diretamente na fotodissociação de OH à 77 K produz um aumento bastante nítido da banda em 312 nm e da banda e em 238 nm (ambas também produzidas inicialmente com a banda F). A figura 25 mostra o efeito produzido nesse processo. A partir deste resultado conclue-se que o parceiro do centro P também produzido diretamente na fotodissociação do ion OH à 77 K captura o elétron P excitado produzindo a banda em 312 nm. Os seguintes argumentos experimentais levam a supor que a molécula OH intersticial é produzida diretamente na fotodissociação de OH em KI à 77 K:

- 1. A produção direta de centros P observada na destruição dos centros (OH<sup>-</sup>) e a não observação de centros de hidrogênio e de oxigênio (na região de absorção UV-VIS-IR) mostra que o parceiro mais simples que equilibra a equação fotoquímica da destruição óptica dos centros P é o fon OH<sup>0</sup> intersticial.
- 2. A verificação (para maior constatação experimental veja as seções V.4. e V.5.) de que esse mecanismo novo de fotodissociação do centro OH manifesta-se somente nas redes onde o espaço intersticial disponível é maior do que ai = 2,7 h está de acordo com a produção de moléculas

OH<sup>0</sup> que necessitam de mais espaço intersticial para a acomodação na rede.

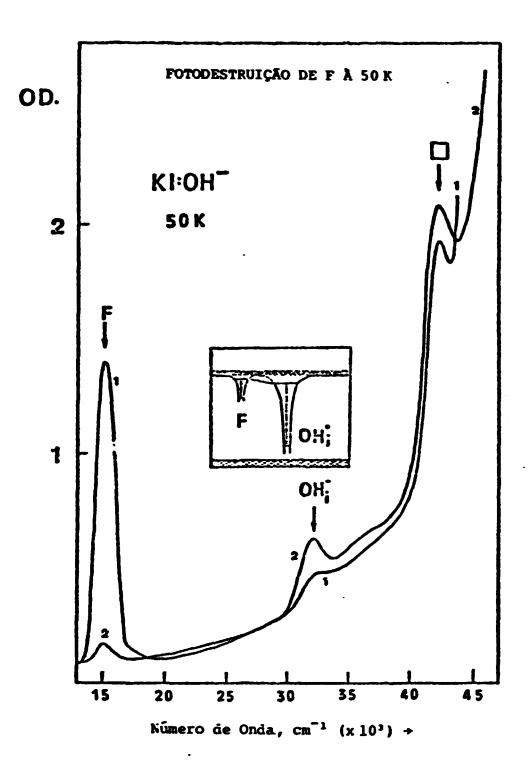
3. A produção de uma nova banda de absorção (em 2765 nm) no infravermelho (no processo de fotodissociação de OH à 77 K) indica a produção de um ion ou molécula OH com uma energia vibracional ("stretching") deslocada para energia maior possivelmente devido sua localização na posição intersticial (menos espaço +> constante de mola KI).

Numa segunda etapa estudou-se a fotodestruição dos centros F produzidos indiretamente na destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O à 300 K em KI. Nesse caso observou-se (veja figura 26) um efeito seme lhante ao obtido na destruição óptica dos centros F produzidos dire tamente na destruição dos centros OH. Paralelamente à destruição da banda F ocorre produção da banda em 312 nm e da banda a em 238 nm. A curva tracejada mostrada na figura 26 mostra a diferença entre os espectros de absorção final (após a fotodestruição F) menos o de absorção inicial (medido após a produção térmica de F). Esse tipo de análise mostra claramente a banda F destruída e as bandas produzidas em 312 nm e em 238 nm (a). Mostra também um decrescimo nítido da absorção fundamental do cristal com a destruição de F. Considerando esses resultados conclue-se que:

- Os produtos da destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O em KI não são os mesmos que os observados na destruição tér mica dos centros H<sub>2</sub>O em KBr e RbBr. Estes produtos (em KI) devem ser idênticos aos produzidos juntamente com os centros F na fotodissociação de OH à 77 K (necanismo II).
- 2. A destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O em KI à 300 K deve produzir além dos centros P, moléculas OH intersticiais que posteriormente capturam os elétrons P ( durante a excitação óptica da banda P) produzindo fons OH intersticiais e vacâncias aniônicas (centros a). Estes fons OH intersticiais produzem a banda em 312 nm sendo que sua identificação não pode ser feita de forma positiva.

# V.3.2. <u>Destruição Térmica da Banda 312 nm e Recuperação dos fons</u> OH Substitucionais

Na sequência de novos experimentos visando uma melhor com preensão da banda 312 nm estudou-se sua destruição térmica após a



PIGURA 25. Destruição óptica dos centros F produzidos na fotodisso ciação de OH em KI à 77 K.

- 1) Após 17 horas de irradiação UV(OHT) à 77 K com Xe 150 W.
- 2) Após 21 horas de iluminação na banda F à 42 K com Xe 150 W + filtro de absorção KG-4 e vidro de 6 mm de es pessura.

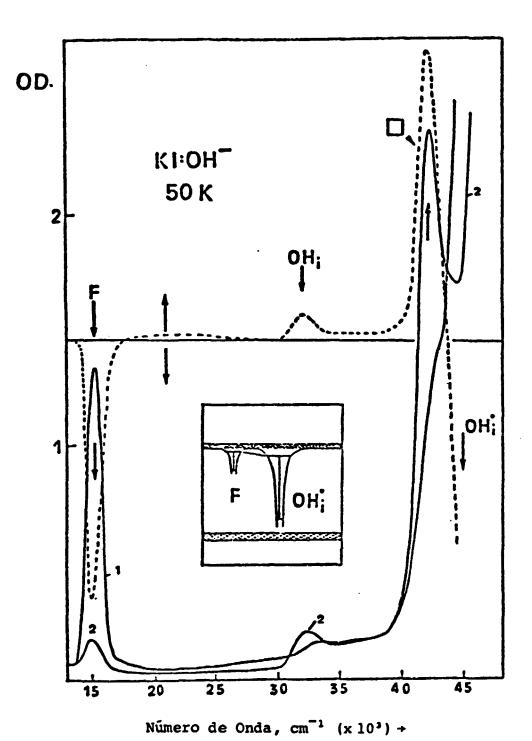


FIGURA 26. Destruição óptica dos centros F produzidos na destruição térmica de centros H<sub>2</sub>O em KI.

- 1) Após destruição térmica de H<sub>2</sub>O à 300 K.
- 2) Após 14 horas de iluminação na banda F à 52 K com Xe 150 W e filtros de absorção KG-4, GG-395 e vidro de 6 mm de espessura.

produção desta banda pela destruição óptica dos centros F ( produzi dos direta ou indiretamente). A figura 27 mostra os resultados obti dos para a destruição térmica da banda em 312 nm que é proveniente da destruição óptica dos centros F produzidos diretamente à 77 K. A figu ra 28 mostra o mesmo tipo de estudo sendo que nesse caso a banda em 312 nm foi produzida pela destruição óptica dos centros F produzidos indiretamente na destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O. Nos dois casos estudados observa-se o mesmo efeito da temperatura. Primeiramente o pulso de temperatura até 240 K desloca a banda de 312 nm para 303 nm. Desloca-se também a posição da banda α de 238 nm para 231 nm ("α"). Já o pulso de temperatura até 300 K destroi parcialmente as bandas en 303 nm e 231 nm ("a") produzindo a banda OH (substitucional) em 230 nm. É evidente nesse caso que durante o tratamento térmico à 240 K ocorre a difusão da vacância na direção do ion OH intersticial produzindo o complexo (OH); . Onde tanto a banda 312 nm (OH;) como a banda α apresentam-se perturbadas e deslocadas. O tratamento térmico à 300 K produz uma destruição gradual desse complexo em favor da produção de centros OHT (banda OHT em 230 nm).

As seguintes equações fotoquímicas foram observadas para o KI:

1. Fotodissociação de OH

2. Destruição Térmica dos Centros H<sub>2</sub>O

$$H_2O$$
 + KT (300 K) -  $e$  + (OH°)  $\frac{1}{2}$   $H_2$ 

3. Fotodestruição dos Centros F (à 50 K) Produzidos Direta ou Indiretamente na Fotodissociação de OH

$$e^-$$
 +  $(OH^0)_i$  +  $hv(F)$   $\xrightarrow{50 \text{ K}}$  +  $(OH^-)_i$  (banda 312nm)

4. Destruição Térmica da Banda 312 nm

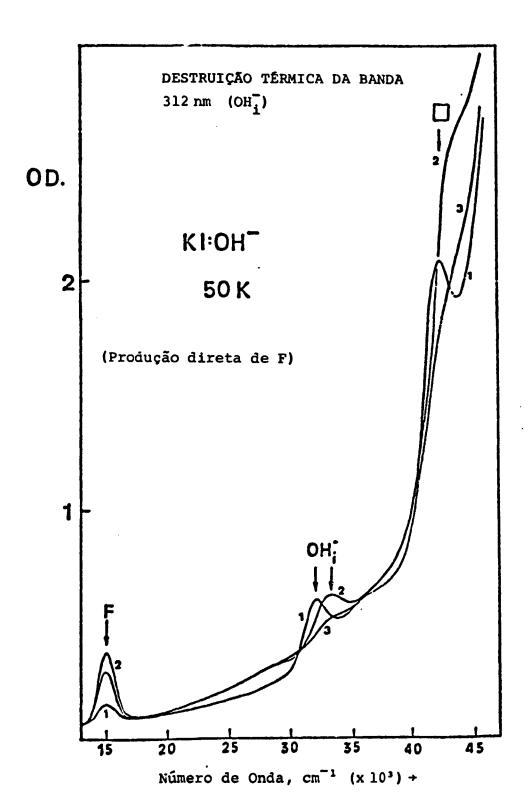


FIGURA 27. Destruição térmica da banda 312 nm em KI (produzida na destruição óptica da banda F).

- 1) Após fotodestruição F à 52 K.
- 2) Após pulso de temperatura até 240 K.  $OH_{i}^{-}$  (312  $\rightarrow$  303 nm)
- 3) Até 300 K.

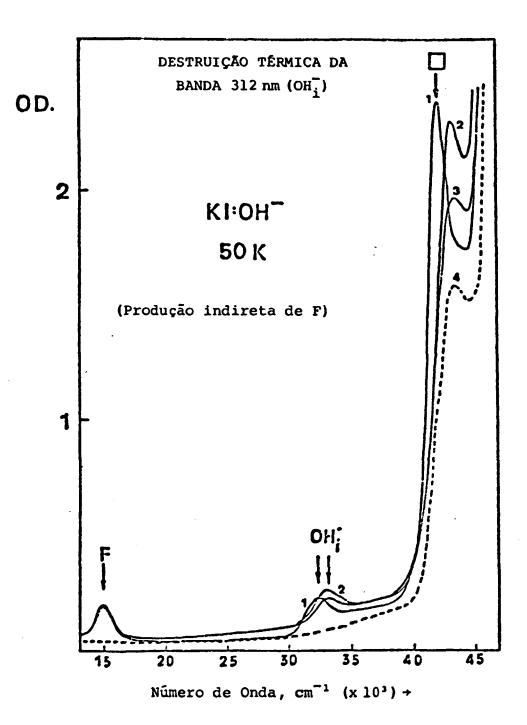


FIGURA 28. Tratamento térmico pulsado em KI:OH após a destruição óp tica dos centros F produzidos inicialmente às custas de H<sub>2</sub>O.

- 1) Após a fotodestruição F à 52 K.
- 2) Após pulso de temperatura até 240 K.  $\alpha$  (238 + 231 nm)
- 3) Até 300 K.
- 4) Espectro inicial antes da irradiação UV(OHT) para com paração.

A fotodissociação de OH no RbI mostrou resultados idênticos aos obtidos no KI. Isto é, produção direta de centros F à 77 K e a produção de átomos de hidrogênio e ions de oxigênio (intersticiais) quando efetuada à 50 K. As figuras 29 (a,b) mostram a produção da banda F e da banda em 349 nm (devida aos ions OH intersticiais) em consequência da destruição da banda OH (substitucional), localizada em 230 nm, sob irradiação UV (OH) realizada à 77 K. Observou-se tam bém que a fotodissociação de OH à 77 K produz uma banda de absorção (IR) em 2769 nm que está deslocada para energia maior (0,0021 eV) com relação à banda de absorção de estiramento do centro OH substitucio nal (localizada em 2782 nm). A produção dessa nova banda e o efeito da temperatura são mostrados na figura 30 que compara os resultados (aqui medidos) com o efeito de temperatura na banda IR (OH) normal.

Por outro lado, a mesma fotodissociação OH quando realizada à 50 K (em RbI) não produz banda IR nova; somente ocorre um decrés cimo da absorção no infravermelho (2782 nm), veja a figura 31. Os resultados obtidos até aqui para o RbI confirmam a suposição inicial (para o KI) de que ocorre produção direta de centros F e moléculas OH intersticiais no processo de desexcitação (OH), somente para as redes hospedeiras que possuem um espaço intersticial onde  $a_i > 2,7$  Å (KI  $+a_i = 2,73$  Å e RbI +a = 2,86 Å).

Cabe esclarecer ainda que nesta seção, os estudos da esta bilidade térmica dos produtos primários (centros U<sub>2</sub>) e secundários (centros U<sub>2x</sub>, H<sub>2</sub>O e F) produzidos a partir da fotodissociação de OH à 50 K, mostram claramente (como no caso do KI) que os centros F produzidos <u>diretamente</u> na fotodissociação de OH à 77 K em RbI não podem ser provenientes da destruição (ou instabilidade) térmica dos centros H<sub>2</sub>O durante a irradiação UV(OH) em baixas temperaturas / T < 100 K. Veja na figura 32 que nesse caso, o centro F só é produzi do termicamente entre 220 e 250 K.

## V.4.1. Fotodestruição dos Centros F (à 10 K) Produzidos Diretamente na Fotodissociação de OH à 77 K

Da mesma forma que ocorre no KI, nesse caso, os centros F podem ser opticamente destruídos eficientemente à 10 K sob iluminação na banda F em 700 nm. Aqui porém, não se observou um aumento nítido e claro da banda em 349 nm com o decréscimo da banda F ( reduzida à 33% do valor inicial). Também a banda IR em 2769 nm não variou com a destruição parcial da banda F. Somente observou-se um aumento do fundo de absorção da amostra na região do violeta e do ultravioleta

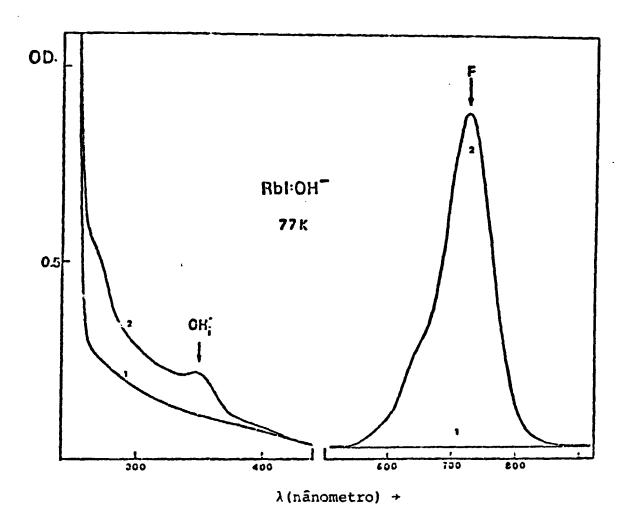


FIGURA 29 (a). Fotodissociação de OH à 77 K em RbI:OH.

- 1) Espectro inicial medido à 10 K.
- 2) Espectro medido à 10 K após 20 horas de irradiação UV (OHT) com Xe 150 W + filtro de interferência em 230 nm.

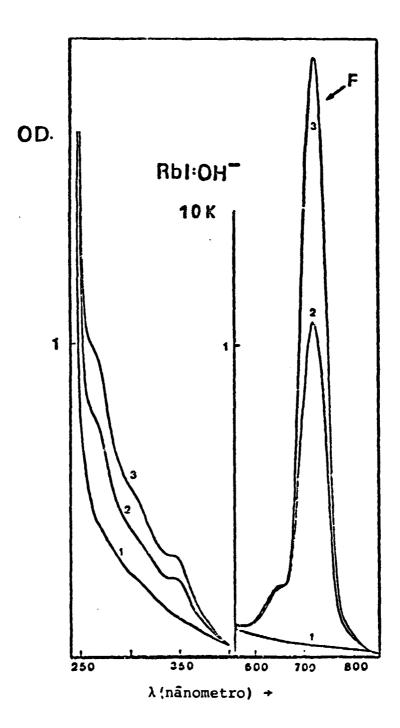
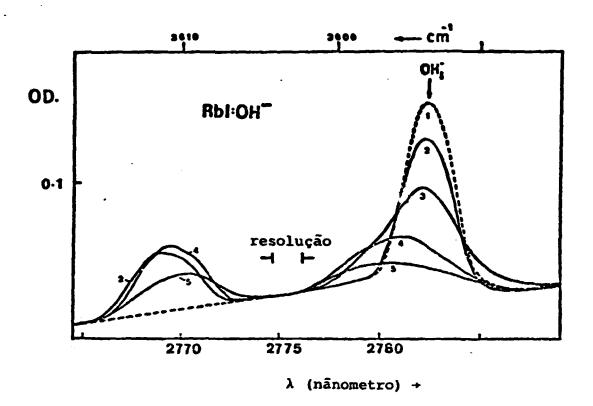


FIGURA 29 (b). Fotodissociação de OHT em RbI:OHT (0,5 mol % de OHT) à 77 K.

- 1) Espectro inicial medido à 77 K.
- 2) Após 15 horas de irradiação UV(OHT) com Xe 150 W + filtro de interferência em 230 nm.
- 3) Após mais 17 horas de irradiação UV(OHT) com Xe 150 W + filtro de interferência em 230 nm.



PIGURA 30. Absorção infravermelha (IR) ao redor da banda IR(OH) em RbI:OH.

- 1) Espectro inicial medido à 10 K (antes da irradiação W).
- 2) Após 32 horas de irradiação UV(OHT) à 77 K.
- 3) Espectro medido à 30 K.
- 4) Espectro medido à 50 K.
- 5) Espectro medido à 90 K.

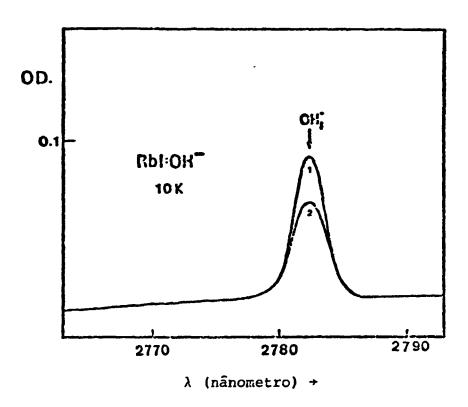
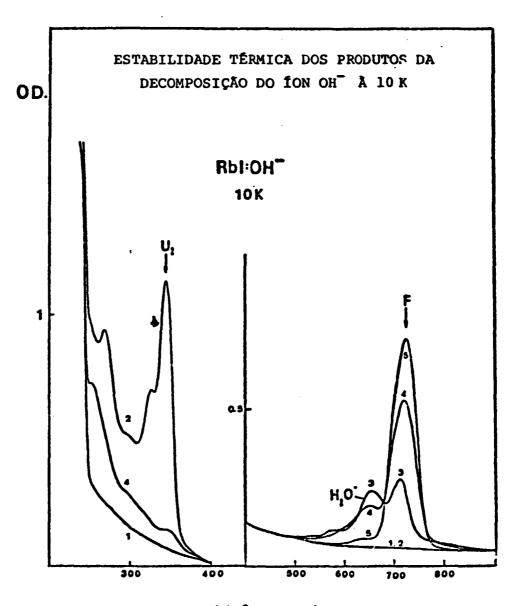


FIGURA 31. Efeito da irradiação UV(OH) à 10 K na banda IR de ions OH substitucionais em RbI.



λ(nânometro) →

FIGURA 32. 1) Espectro inicial medido à 10 K.

- 2) Após 16 horas de irradiação UV(OH) à 10 K com Xe 150 W + filtro de interferência em 230 nm.
- 3) Após pulso de temperatura até 80 K.
- 4) Após pulso até 220 K.
- 5) Após pulso até 285 K.

(veja as curvas 1, 2, 3 da figura 33). Embora os resultados para a fotodestruição de F em RbI não sejam muito claros, o importante é que a produção direta de centros F na fotodissociação de OH à 77 K vem confirmar uma vêz mais que este mecanismo é extremamente dependente do parâmetro da rede. Continuando nessa linha de raciocínio surge a proposta de que esse mecanismo possa se manifestar em uma rede cujo espaço intersticial seja ligeiramente menor do que o espaço crítico (onde ai = 2,7 Å) porém impurificada com ions substitucionais positi vos ou negativos e menores do que os ions da rede. Espera-se nesse caso, que o pequeno tamanho da impureza (quando presente em grande quantidade - 10 partes/mol) aumente o espaço intersticial disponí vel ao redor do ion OH aumentando a chance de produção direta de centros F. Para tal cresceu-se os cristais:

KBr + 2% F + OH e RbBr +1,5% Na + CH

#### V.5. FOTODISSOCIAÇÃO DE OH EM KEr + 2% F

Com a introdução de alta concentração de fluor, o cristal de KBr apresentou os dois mecanismos de fotodissociação OH verifica dos anteriormente para o KI e RbI:

- I) Que conduz à quebra da molécula.
- II) Que conduz à produção direta de centros F.

A figura 34 mostra os resultados obtidos na fotodissociação (à 77 K) gradativa (curvas l → 4) do ion OK nessa rede impurificada. Nesse caso, ocorre a manifestação dos dois canais de fotodissociação. O canal I é evidenciado pela produção de centros U, e o canal II pela formação direta de centros F. A fim de tornar mais evidente a forma ção de centros F, irradiou-se uma segunda amostra desse cristal mais intensamente também à 77 K. Os resultados obtidos são mostrados na figura 35. Observa-se uma acentuada produção de centros F (0.D = 2) é uma nítida e clara produção da banda OH; com máximo de absorção em 333 nm. Devido à grande produção de centros F, observou-se também a formação de centros U em consequência da captura de átomos de hidro gênio móveis (produzidos pelo canal I) pelo centro F nas suas nhanças. A formação de centros U é um resultado evidente da mistura dos dois canais de fotodissociação de OHT possíveis devido o aumento do espaço intersticial criado pela substituição de um Cl peloF nas vizinhanças do ion OH. Esse modelo implica que, nesse caso, o ion OH não entra na rede distribuido estatisticamente e sim entra na

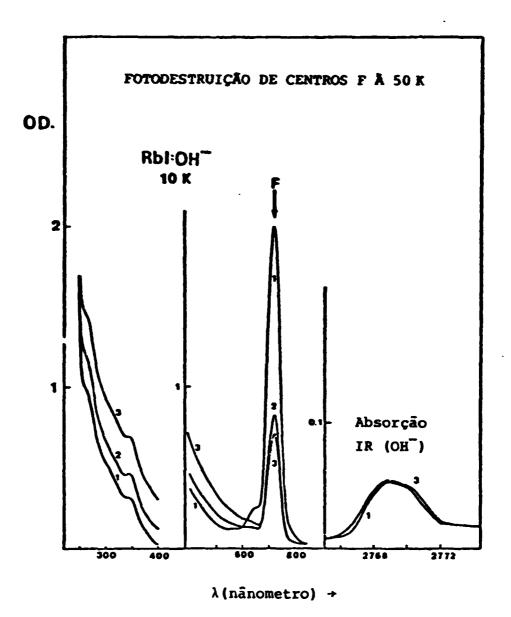


FIGURA 33. Fotodestruição de centros F produzidos diretamente às cus tas de centros OH.

- 1) Espectro medido à 10 K após 32 horas de irradiação UV (OHT) à 77 K com Xe 150 W + filtro de interferência em 230 nm.
- 2) Após 1 hora de iluminação na banda F à 50 K com Xe 150 W.
- 3) Após mais 1 hora de iluminação F ídem 2.

rede junto com a impureza F (\*\*).

Por outro lado, a fotodissociação de OH nessa mesma matriz de KBr contendo 2% de F, quando realizada à 50 K, produz somente átomos de hidrogênio intersticiais (centros  $U_1$ ) e ions de oxigênio substitucionais (centros O) exatamente como foi verificado anterior mente para o KBr puro (seção V.l.). A figura 36 mostra a destruição parcial da banda OH e a formação da banda  $O_S$  com máximo de absorção em 196 nm. A figura 37 mostra a estabilidade dos produtos da fotodis sociação de OH à 50 K em KBr + 2% F. Inicialmente o pulso de tempe ratura até 126 K destroi os centros  $U_2$  e produz os centros  $U_{2X}$  e  $H_2O$ . Estes centros  $H_2O$  são destruídos termicamente à 285 K produzin do centros F. A figura 38 mostra o efeito do pulso de temperatura até 285 K na banda  $O_S$  (196 nm) mostrando o quase total desaparecimen to desta banda (196 nm) e o surgimento das bandas  $\beta$  (192 nm) e banda U (produzida na destruição térmica dos centros  $H_2O$  como já foi estudado anteriormente na referência 48).

## V.5.1. Fotodestruição dos Centros F Produzidos Diretamente na Fotodissociação de OH

A destruição óptica quase total dos centros F produzidos diretamente na fotodissociação de OH, produziu um aumento marcante da banda 333 nm (devida a absorção dos ions OH intersticiais). Além desse efeito pronunciado, observou-se também a destruição total da pequena quantidade de centros U, e a consequente formação de centros U. Os resultados desse tratamento óptico são mostrados na figura 39.

# V.5.2. Fotodestruição dos Centros F Produzidos na Destruição Térmica dos Centros H<sub>2</sub>O

De forma contrária ao que foi observado e mencionado na Seção V.5.1., a destruição óptica dos centros F produzidos na destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O à 285 K, não produz a banda 333 nm.Obser va-se somente a formação da banda α em 202 nm e o decréscimo da banda β em 192 nm. Esses resultados são indicados na figura 40.Isso mostra que na destruição térmica de centros H<sub>2</sub>O não há produção de ions OH intersticiais, isto é, o átomo de oxigênio precisa estar independente do átomo de hidrogênio. No processo de destruição óptica dos centros F, estes átomos de oxigênio intersticiais (O<sub>1</sub>) capturam o elétron F produzindo ions de oxigênio negativos (O<sub>1</sub>) localizados intersticial mente. Nesse processo o átomo de hidrogênio móvel precisa reagir com

<sup>\*\*</sup> Caso contrārio, somente 24% des Jons OHT seriam responsaveis pelo ejeito observado.

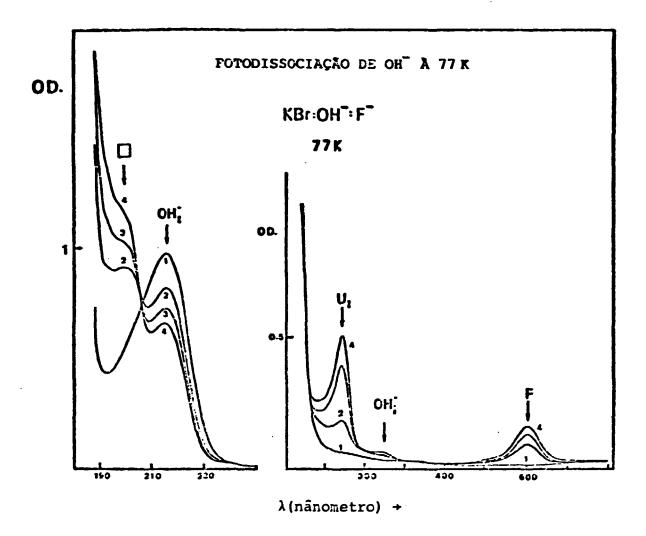


FIGURA 34. Fotodissociação de OH em KBr + 2% F (à 77 K).

- 1) Espectro inicial medido à 77 K.
- 2) Após 15 horas de irradiação UV(OHT) utilizando uma lam pada de Xe 150 We um monocromador B&L posicionado em 216 nm e um filtro de interferência ARC em 214 nm.
- 3) Após mais 1 hora de irradiação UV(OHT) com Xe 1000 W + monocromador B&L em 216 nm e filtro de interferência ARC em 214 nm.
- 4) Após mais 2 horas de irradiação UV idem 3.

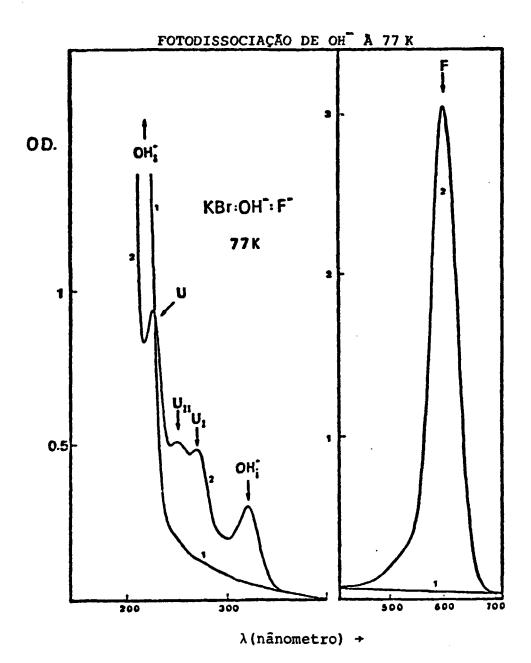


FIGURA 35. Formação acentuada de centros F as custas de fons OH substitucionais em KBr + 2% F + 10 3 OH à 77 K.

- 1) Espectro inicial medido à 77 K.
- 2) Após 16  $^1/_2$  horas de irradiação UV(OH $^-$ ) à 77 K com Xe 150 W mais filtro de interferência em 214 nm (com 47% de T).

C 2 ..

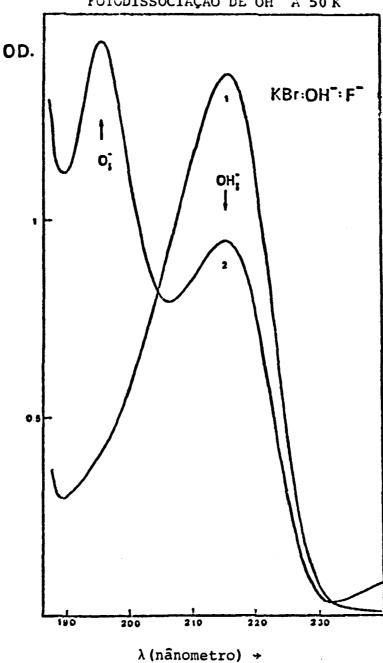


FIGURA 36. 1) Espectro inicial medido à 50 K.

2) Após 15  $\frac{1}{2}$  horas de irradiação UV(OH) monocromática em 216 nm utilizando uma lâmpada Xe 150 W e monocromador Bauch & Lomb.

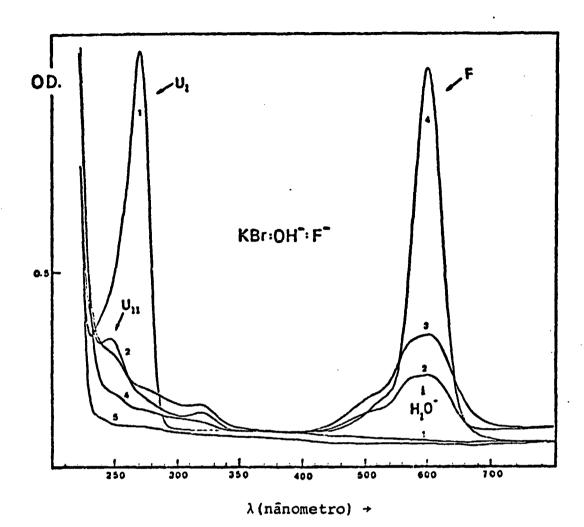


FIGURA 37. Estabilidade térmica dos produtos da fotodissociação de OH à 50 K em KBr + 2% F.

- 1) Após 15  $\frac{1}{2}$  de irradiação UV(OH<sup>-</sup>) à 50 K.
- 2) Após pulso de temperatura até 126 K.
- 3) Após pulso de 215 K.
- 4) Após pulso de 285 K.
- 5) Espectro medido inicialmente à 50 K (antes da irradia ção UV).

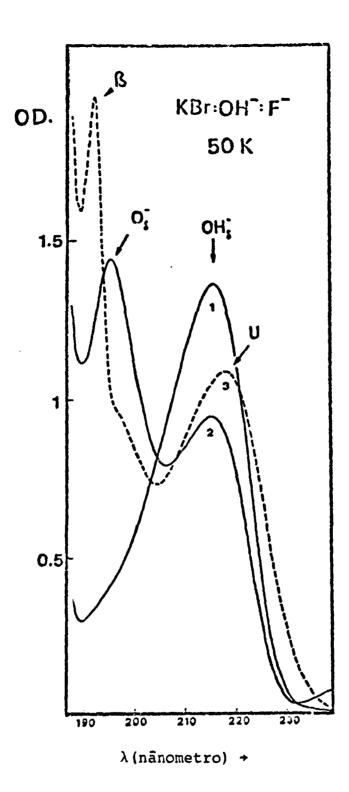


FIGURA 38. Destruição térmica da banda  $O_s^-$  em KBr + 2%  $F_-^-$  + OH $^-$ .

- 1) Espectro inicial medido à 50 K antes da irradiação UV.
- 2) Após 15  $\frac{1}{2}$  horas de irradiação UV (OHT) à 50 K.
- 3) Após pulso de temperatura até 285 K.

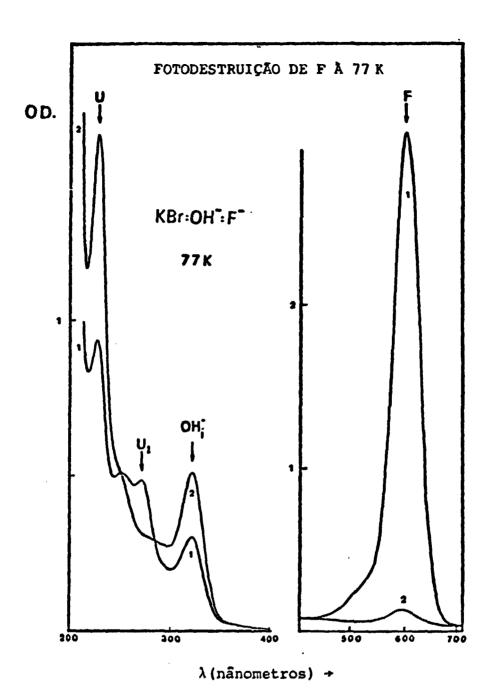


FIGURA 39. Destruição óptica dos centros F produzidos diretamente na fotodissociação de OH à 77 Kem KBr + 2% F + OH.

- 1) Espectro medido à 77 K após a fotodissociação de OH.
- 2) Após 16 horas de iluminação na banda F à 77 K utilizan do uma lâmpada de Xe 150 We filtro de interferência em 600 nm (Oriel).

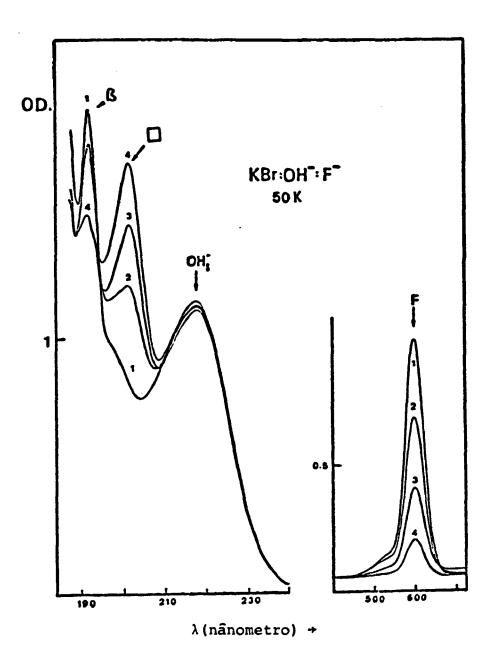


FIGURA 40. Destruição óptica dos centros F produzidos na destruição térmica de H<sub>2</sub>O em KBr + 2% F + OH .

- Espectro medido à 50 K após a destruição térmica de H<sub>2</sub>O<sup>®</sup> à 285 K.
- 2) Após 1 hora de iluminação F à 50 K com Xe 150 W e monocromador B&L em 600 nm.
- 3) Após mais 1 hora de iluminação F com Xe 1000 W e filtro de interferência de 600 nm de um lado do cristal e iluminação com Xe 150 W + filtro de absorção KG-610 + vidro de 8 mm de espessura do outro lado do cristal
- 4) Após mais 16 horas de iluminação com Xe 150 W+vidro de 8 mm espessura + filtro KG-610 de 6 mm de espessura.

um outro átomo de hidrogênio produzindo a molécula H, intersticial, uma vêz que não se observa a formação de qualquer tipo de defeito de hidrogênio com estrutura simples: U, U1 e U.

#### v.5.3. Fotodestruição da Banda 333 nm

Como foi mencionado anteriormente na Seção V.5.1., a banda 333 nm pode ser produzida as custas da fotodestruição (à 77 K) centros F produzidos diretamente na fotodissociação de OH à 77 K em KBr + 2% F. Após a produção óptica dessa banda (333 nm), submeteu-se o cristal à uma iluminação filtrada entre 300 nm e 800 nm cujo diagra ma de transmissão versus o comprimento de onda de irradiação tra-se representado na figura 41. A região hachurada ( à da figura 41 mostra a parte efetiva de excitação da banda 333 nm e a região hachurada à direita mostra a parte efetiva de excitação banda F. Submetendo-se a amostra à essa irradiação filtrada conforme foi descrito pela figura 41, durante  $2\frac{1}{2}$  horas  $\tilde{a}$  77 K, observou-se a restauração total da banda F as custas da banda 333 nm. A figura 42 mostra os resultados da fotodestruição da banda 333 nm. Esses resul tados mostram que o ion (OH) intersticial é menos estável do que o centro F\* (2p), pois iluminando-se (com - iguais intensidades de luz) nessas duas bandas de absorção, resulta na formação de centros F e destruição dos centros OH intersticiais. Porém quando ilumina-se somente na banda F, ocorre a destruição total dos centros F formação de OH intersticiais (resultados já apresentados na Seção V.5.1.) o que mostra que o ion (OH) intersticial após a captura do elétron F, desexcita-se rapidamente para o estado fundamental configuração eletrônica é mais compacta e consequentemente mais está vel do que o estado 2p do centro F.

Os resultados apresentados até aqui para o KBr + 2% F, podem ser resumidos pelas seguintes equações fotoquímicas:

1. Fotodissociação de OH em KBr na Presença do ion de Fluor (F) na Segunda Vizinhança do ion OH Substitucional

OH + hv (OH) 
$$+ H_{1}^{0}$$
 (50 K)  $+ OH_{1}^{0}$  (77 K)

2. Destruição Térmica do Centro H,O

$$H_2O$$
 + KT (285 K) -  $e^-$  +  $O_1^0$  +  $(H_2)_1$ 

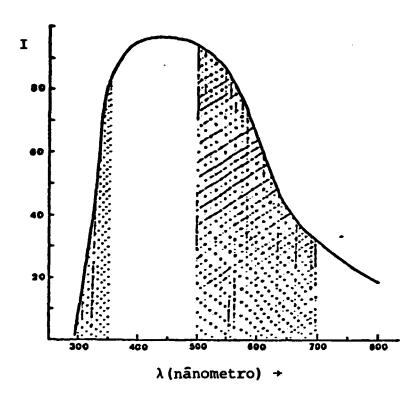
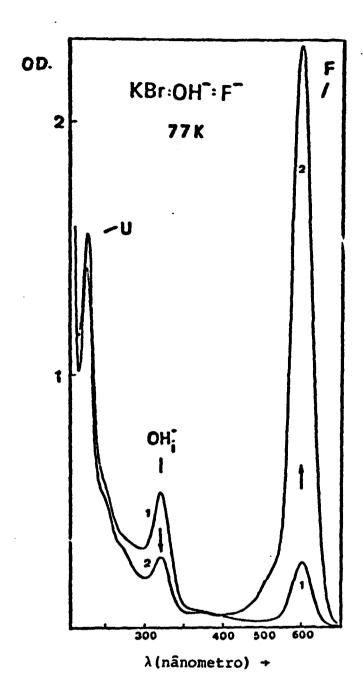


FIGURA 41. Espectro da luz de excitação utilizada na destruição óptica da banda em 333 nm no KEr + 2% F. A área hachurada à esquerda representa a região de absorção da banda em 333 nm e a área hachurada à direita representa a absorção da banda F. I (ordenda) representa a intensidade relativa da luz de excitação utilizada.



PIGURA 42. Fotodestruição da banda de 333 nm em KBr + 2% F + OH

- 1) Espectro medido à 77 Kapós os seguintes tratamentos óp ticos:
  - a) 16 ½ horas de irradiação UV ã 17 K com Xe 150 W + filtro de in terferência em 214 nm.
  - b) 6 horas de iluminação na banda F ã 71 K com Xe 150 W + filtro de interferência em 600 nm.
- 2) Após 2 horas de iluminação com Xe 150 W + os seguintes filtros: KG-4 e BG-14 cuja transmitância está indicada na figura 41.

3. Fotodestruição dos Centros F Produzidos Diretamente na Fotodissociação de OH (a) e Indiretamente na Destruição Térmica dos Centros H<sub>2</sub>O (b)

a) 
$$e^{-}$$
 +  $OH_{1}^{0}$  +  $hv(F)$   $\frac{77 \text{ K}}{}$  +  $OH_{1}^{-}$ 

b) 
$$e^{-} + O_{i}^{0} + hv(F) \xrightarrow{77 K} + O_{i}^{-}$$

4. Fotodestruição da Banda 333 nm (OH<sub>1</sub>)

$$+ OH_{\underline{i}}^{-} + hv(F_{\bullet}OH_{\underline{i}}^{-}) \xrightarrow{77 \text{ K}} = e^{-} + OH_{\underline{i}}^{0}$$

#### V.6. FOTODISSOCIAÇÃO DE OH EM RBBr CONTENDO 1,5% DE Na

Da mesma forma que o fon de fluor (F) em KBr produziu um aumento do espaço intersticial ao redor do fon OH substitucional, supõe-se que o fon Na na rede de RbBr também produza o mesmo efeito (o raio do Na é menor do que o raio do Rb da rede) de aumento do espaço intersticial ao redor do OH. Se isso ocorrer, haverá produção direta de centros F no processo de fotodissociação de OH à 77 K. Sem dúvida, esse efeito foi observado, conforme mostra a figura 43. Obser va-se nesse caso, em paralelo à formação da banda F, a formação da banda 360 nm (atribuída aos centros OH intersticiais) e a banda U2 que é proveniente da mistura dos dois canais de fotodissociação de OH possíveis à 77 K.

A fotodissociação de OH quando efetuada à 10 K (em RbBr + +1,5% Na), produz somente átomos de hidrogênio intersticiais (centros U<sub>2</sub>) e íons de oxigênio (O) intersticiais. Nesse caso os centros F são produzidos somente no processo de destruição térmica dos centros H<sub>2</sub>O à 220 K, conforme mostra a figura 44. A figura 45 mostra que a fotodissociação OH à 10 K (nesse cristal) produz somente uma diminuição da banda de absorção infravermelha do modo vibracional do íon OH sem introduzir perturbações que introduziriam bandas IR novas.

Esses resultados confirmam uma vêz mais que a produção di reta de centros F à 77 K durante a fotodissociação OH, não pode ser proveniente da instabilidade e destruição térmica dos centros H.O (que são termicamente estáveis até 220 K) e sim provenientes de um novo mecanismo de desexcitação do centro (OH) que conduz à liberação da molécula OH pelo sistema "vacância + elétron".

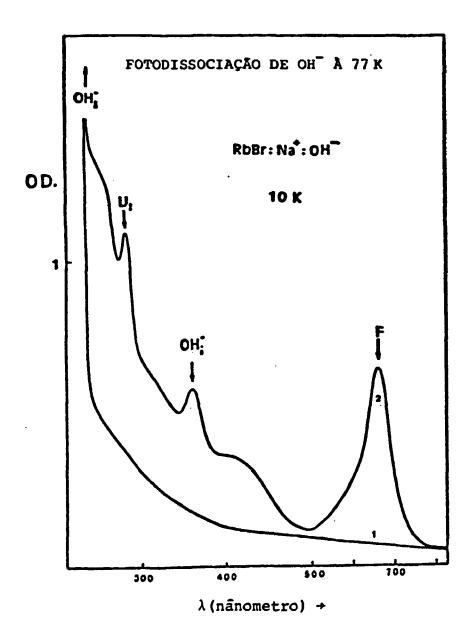


FIGURA 43. Fotodissociação de OH à 77 K em RbBr + 1,5% Na + 1% OH.

- 1) Espectro inicial medido à 10 K.
- 2) Após 17 horas de irradiação UV(OHT) monocromática em 226 nm com Xe 150 W.

DOMA TO THE THEORY A MINE CAR GR

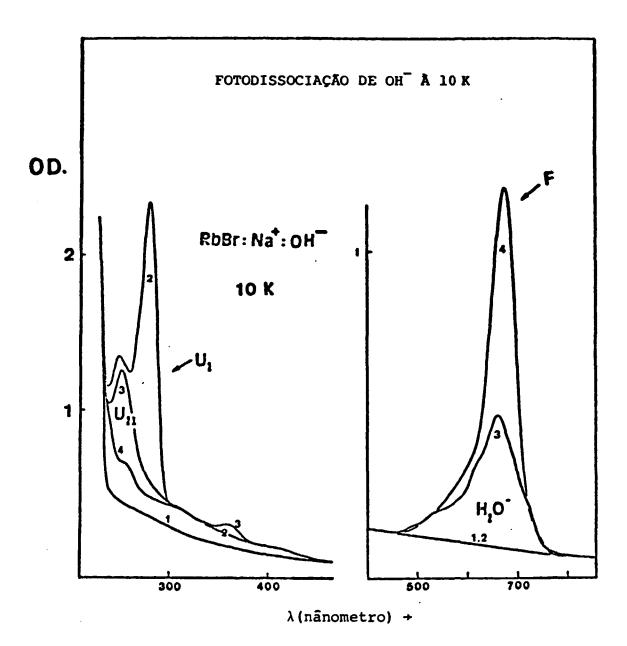


FIGURA 44. Fotodissociação de OH em RbBr + 1,5% de Nã e estabilidade térmica dos produtos da fotodecomposição.

- 1) Espectro inicial medido à 10 K.
- 2) Após 16 horas de irradiação UV(OHT) à 10 K monocromática em 226 nm com Xe 150 W e pulso de temperatura até 77 K.
- 3) Após pulso de temperatura até 180 K.
- 4) Após pulso de temperatura até 220 K.

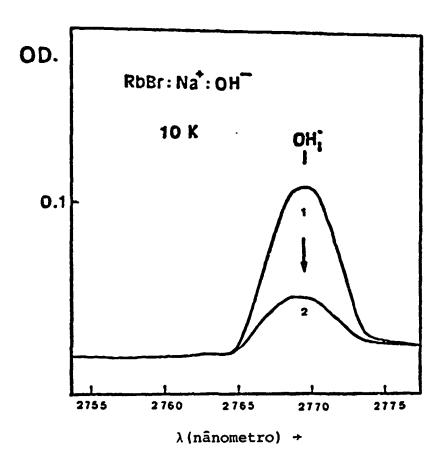


FIGURA 45. Efeito da irradiação UV(OHT) na banda IR(OHT) em RbBr + 1,5% Na + 1% OHT.

- 1) Espectro inicial à 10 K.
- 2) Após 16 horas de irradiação UV(OHT) à 10 K.

## V.7. MODELO PROPOSTO PARA A FOTODISSOCIAÇÃO DO ÍON OH SUBSTITU CIONAL NOS HALETOS ALCALINOS

O fato de se observar a produção direta de centros F duran te a fotodissociação de ions OH à 77 K nas redes cristalinas onde o espaço intersticial é a; 2 2.69 Å e por outro lado a quebra da ligação O-H (em átomos de hidrogênio e ions de oxigênio) quando a se efetua a fotodissociação OH à 50 K, mostra que se necessita de um novo modelo (para esse processo) capaz de conciliar os dois efeitos observados num único quadro físico.

Com o intuito de se obter alguma correlação entre as pro priedades ópticas do centro F e as do ion OH, graficou-se tentativa mente (num mesmo diagrama) os valores das energias totais dos estados fundamental (1S) e excitado (2p) do centro F e os valores das energias totais dos 4 estados do centro OH durante o ciclo de absorção óptica. Medindo-se a energia do máximo da banda de absorção UV (OH ) · e subtraindo-se o valor da energia do máximo da banda emissão (OHT), obtemos o valor total da energia dissipada pelas duas relaxa ções não radiativas do centro OH que ocorrem antes e após a emissão luminescente na região do violeta. É razoável considerar que essas duas relaxações (não radiativas) possíveis para o centro OH consumam a mesma quantidade de energia cada uma considerando que a transição eletrônica desse sistema (OHT) é independente do parâmetro da rede. Considerando-se também que a transição eletrônica do centro OH é do tipo de troca de carga com a rede catiônica (isto é,quasi -exciton), conclue-se que o estado excitado OH não relaxado atingido na absor ção óptica deva localizar-se energeticamente muito próximo do mínimo da banda de condução. Considerando-se agora que as duas não radiativas do (OH<sup>-</sup>) consomem a mesma quantidade đe energia, conseguiu-se posicionar os 4 níveis de energia total para o óptico do centro OH em 5 redes diferentes; KCl, KBr, RbBr, KI e RbI. Esses valores são representados no diagrama (linhas cheias) da figura 46. As linhas tracejadas da figura 46 representam os valores energias totais do estado excitado relaxado (2p) (do qual ocorre emissão luminescente) e do estado fundamental não-relaxado (15) do centro F para 5 redes diferentes. Os valores da energia total do estado excitado relaxado (2p) do centro F para os vários haletos al calinos considerados, foram encontrados de forma simples sem alguma consideração extra. Para tal, utilizaram-se apenas os valores experimentais medidos (por outros autores 56 ) para a distância entre o mínimo da banda de condução e a energia do estado excitado relaxado (2p) do centro F, através da medida da fotocondutividade F em função

da temperatura da amostra.

Curiosamente observou-se nesse diagrama (figura 46) que à medida que se aumenta o parâmetro da rede, diminue a energia de sepa ração entre a configuração do estado excitado relaxado do centro OH e a do estado fundamental não-relaxado (lŝ) do centro F.Nas redes de KI e RbI ocorre uma coincidência entre as energias dessas duas configurações. Essa situação deve sem dúvida produzir um aumento da probabilidade de produção direta de centros F durante o processo de desexcitação do centro OH em consequência de um mecanismo novo que depende também do espaço intersticial para a acomodação da molécula OH fora da vacância aniônica.

Estabelecida as evidências experimentais de que deve ocorrer um cruzamento das curvas de energia total do centro F ( no estado 1S) e do centro OH no estado excitado relaxado, construiu-se um dia grama de coordenadas de configuração incluindo as curvas de energia total dos dois defeitos, mostrando então o ponto de cruzamento (figu ra 47). No plano do papel (lado esquerdo da figura 47) são represen tadas as energias totais dos dois estados (fundamental e excitado) do centro OH em função da coordenada espacial Qo do modo local efetivo que acopla com o estiramento da ligação O-H. Do lado direito da figu ra 47 representou-se somente a curva de energia total ( parabola num plano 1 ao plano do papel) do centro F no estado fundamental 1S em função da coordenada espacial Qr do modo local efetivo mode") ao redor da vacância. De acordo com esse modêlo, a molécula OHT é excitada verticalmente (durante o processo de absorção UV) para um estado vibrônico acima do limite dissociativo introduzindo uma chance da molécula dissociar-se em (0) e H (mecanismo I) durante o proces so de relaxação. A eficiência desse processo (dissociação) é pequena pois a relaxação para o mínimo da curva (ponto A) é muito (- 10<sup>-12</sup> seg.). Após o sistema relaxar para o ponto A, pode ocorrer somente a emissão luminescente ou o sistema pode relaxar para a figuração B de acordo com o mecanismo II. Se a rede hospedeira tal que o ponto de cruzamento esteja situado próximo (e acima) do ponto A (como ocorre no KI, RbI), o grau de população pela temperatura) do nível vibracional (n= 1) do estado excitado do centro OH produzirá as condições necessárias para o sistema passar para a configuração B (mecanismo II). É claro que esse mecanismo (II) é termicamente ativado e ocorre para temperaturas > 77 K. Em tempera turas mais baixas (< 50 K), o sistema luminesce a partir do mínimo A.

Uma questão que pode surgir é porque o sistema enquanto relaxa para o ponto A e passa pelo ponto de cruzamento (das parabo - las), não atinge sempre o ponto B e sim o ponto A (na maioria das

vêzes). Acontece que esses dois modos locais (um descrito pela ccordenada Q<sub>0</sub> e o outro pela coordenada Q<sub>F</sub>) representam movimentos independentes e complexos dos ions da rede envolvendo muitas coordenadas espaciais e seria muito pouco provável que esses movimentos coincidissem em toda sua amplitude de vibração. Dessa maneira o cruzamento ocorre somente para uma configuração particular e instantânea. O tem po gasto nessa configuração "particular" é muito pequeno e a probabilidade é muito maior para o sistema atingir o ponto A. Somente com o aumento da temperatura (~77K), a população do sistema em torno desse ponto de cruzamento aumenta produzindo um aumento significativo do tempo médio gasto pelo sistema nessa posição particular de cruzamento, propiciando a passagem do sistema para a configuração B (centro F + molécula OH° intersticial).

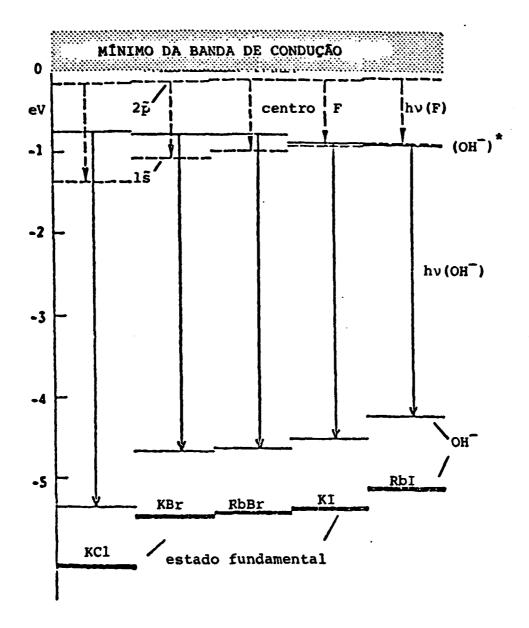


FIGURA 46. Diagrama da posição dos níveis de energia: (--) do centro

F excitado relaxado 2p e fundamental não relaxado 1s, (-)
do centro OH excitado relaxado (OH e fundamental.

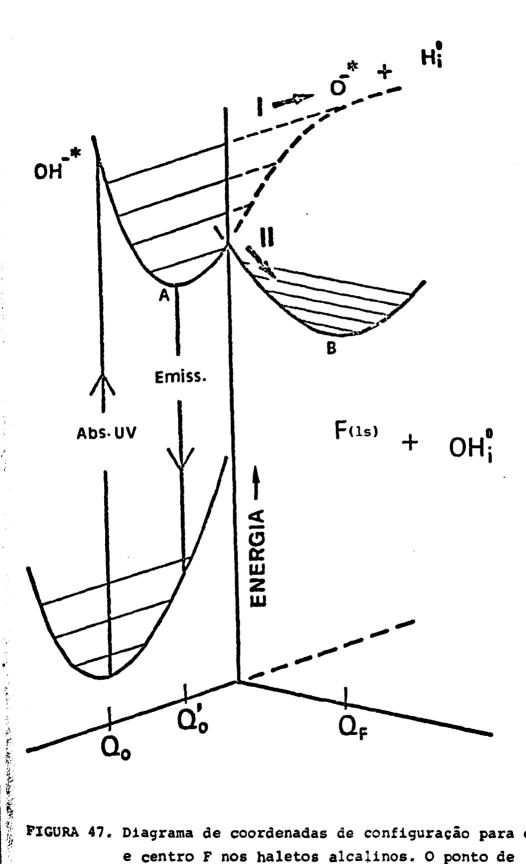


FIGURA 47. Diagrama de coordenadas de configuração para o centro OH e centro F nos haletos alcalinos. O ponto de cruzamento das curvas dos estados F(ls) e (OH) favorece a relaxação do sistema de A para B (mecanismo II termicamente ativado T > 77 K).

TABELA DA COLEÇÃO DAS POSIÇÕES DOS MÁXIMOS DAS BANDAS DE ABSORÇÃO DE ALGUNS DEFEITOS MAIS RELEVANTES PRODUZIDOS NA FOTODISSOCIAÇÃO DE ÍONS OH<sup>-</sup> SUBSTITUCIONAIS NOS HALETOS ALCALINOS.

DEFEITO REDE	OH <sub>s</sub>	0 <u>-</u>	(alfa)	H <sub>1</sub> 0 Centro U <sub>2</sub>	β (beta)	он_
KBr	216 nm	196 nm	202 nm	270 nm	192 nm	n.o.
RbCl	212 nm	192 nm	-	242 nm	_	n.o.
RbBr	226 nm	n.o.	206 nm	280 nm	197 nm	360 nm
KI	230 nm	n.o.	238 nm	339 nm	-	303 nm 312 nm
RbI	230 nm	n.o.	-	343 nm	-	349 nm
KBr + 2% F	216 nm	196 nm	202 nm	270 nm	192 nm	333 nm
RbBr+ 1,5% Na <sup>+</sup>	226 nm	n.o.	206 nm	280 nm	197 nm	360 nm

A maioria das bandas de absorção foram medidas à 77 K. n.o. - não observado.

Os resultados e conclusões serão apresentados em duas eta pas sendo a primeira correspondente aos dados obtidos para o KCl onde determinou-se principalmente a dependência espacial da interação entre o centro F e o Ion OH. Na segunda etapa apresentar-se-aos resultados dos estudos feitos dessas interações em outros haletos alcalinos (KBr, RbCl, RbBr). Nessa segunda etapa será mostrado a importância da velocidade de reorientação dipolar OH na interação com os centros F. Nessas redes (≠ do KCl), o tempo de reorientação do dipolo OH à 8 K torna-se maior do que o tempo de vida do RES (estado excitado relaxado) do centro F (contrário ao que ocorre no KCl onde <sup>7</sup>dip << << tlum para T < 100 K) fazendo com que a eficiência do processo de desexcitação não-rediativo (do RES) seja extremamente dependente da temperatura.

### VI.1. Estudos da Interação de Centros F e fons OH em KCl Coloridos Aditivamente

Foi desenvolvido neste estudo, experimentos paralelos com as várias técnicas ópticas descritas no capítulo IV.2. em dois siste mas de defeitos diferentes. As figuras 48 e 49 sumarizam tipos de sistemas utilizados. O primeiro tipo de sistema consiste no uso de cristais de KCl contendo OH (ou OD) coloridos aditivamente e que foram submetidos a um tratamento térmico à 500°C durante ~ 1-2 minutos e resfriados rapidamente à 20°C (no escuro). Após esse trata mento térmico a amostra é colocada no criostato e resfriada à 8 K sem exposição à luz ambiente. Nessas condições tem-se uma distribuição estatística entre os defeitos OH e os centros F. Essa distribuição de centros F e ions OH em KCl produz o primeiro tipo de tratado neste capítulo, sistema não agregado. A figura 48 a mostra o espectro de absorção óptica (à 10 K) dos centros F em duas amostras de KCl contendo altas concentrações de ions OH em comparação com a amostra pura. Como pode ser visto, a absorção F é aproximadamente in distinguivel nas 3 amostras com posições dos máximos idênticas. Ape nas um pequeno efeito de alargamento (~ 3%) da banda foi observado com o aumento da concentração do fon OHT. Essa evidente insensibilidade da absorção F devido à presença da impureza OH está em grande traste com o pronunciado efeito provocado pelo ion OH na intensidade da emissão F nesses mesmos cristais, veja a Figura 48 b.

O pronunciado efeito na emissão F pode ser resumido pela seguinte afirmação. A intensidade da emissão F torna-se drasticamente

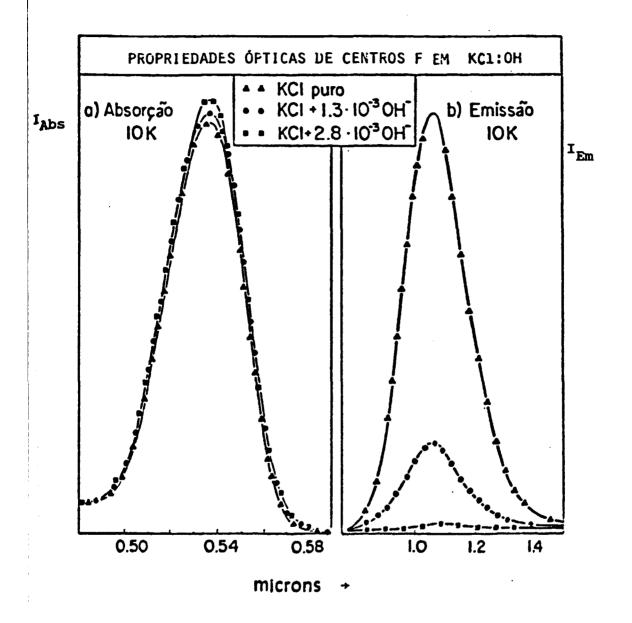
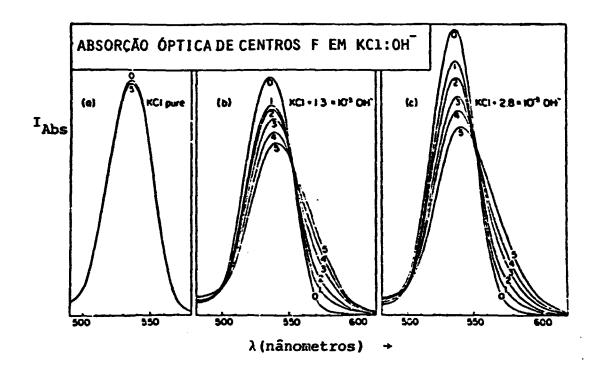


FIGURA 48. Espectros de absorção e de emissão de centros F em várias amostras de KCl (não agregado): puro e contendo 2 concentrações diferentes de lons OHT.



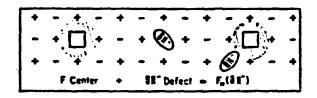


FIGURA 49. Espectro de absorção óptica (à 10 K) de amostras de KC1 (coloridos aditivamente) no estado não agregado e após cinco exposições com luz F (530 nm) à - 30°C, para (a) KC1 puro e (b), (c) KC1 com duas concentrações altas de OH.

reduzida com o aumento da concentração de defeitos OH porém sem alterar o formato e posição da banda de absorção F. Evidentemente, mesmo nesse estado não acregado isto é, o caso em que os defeitos F e OH encontram-se estatisticamente distribuídos, a presença de centros F não associados aos ions OH produz um forte "quenching" da lumines-cência do centro F.

O segundo tipo de sistema usado em nossos experimentos con siste no uso dos mesmos cristais coloridos e dopados com entretanto, após o tratamento térmico à 500°C e medidas ópticas em temperaturas baixas (10 K) foram iluminados com pequenas doses de luz visível à - 30°C. A figura 49 (b,c) mostra o efeito do aumento exposição à luz visível nos cristais de KCl com duas concentrações diferentes de OH. Em consequência disso a absorção F normal torna-se sistematicamente alargada e deslocada para energias menores durante esse processo de iluminação. Para comparação mostra-se na figura 49 a que a mesma quantidade de exposição de luz para o cristal de KCl puro produz um efeito negligenciável na absorção F. Apenas após uma consi derâvel exposição de luz à temperaturas maiores (em KCl puro) produ zir-se-a os centros de agregados de F esperados tais como centros F<sub>2</sub>, F1. ... etc. Isso demostra claramente que a exposição de luz visível empregada à - 30 °C é completamente insuficiente para produzir uma difusão térmica dos centros F foto-ionizados sobre um amplo intervalo de parâmetros de rede suficiente para formar pares de centros F. mesmo tratamento (óptico e térmico) aplicado no cristal dopado OH entretanto, introduz fortes mudanças na banda de absorção do cen tro F. Uma conclusão evidente obtida desses resultados é a sequinte: nos cristais de KCl dopados com OH (onde NOH- é aproximadamente 2 ordens de grandeza maior do que N<sub>F</sub>) são necessários poucos saltos do centro F foto-ionizado para produzir a associação com o ion OH que está presente na rede em quantidade abundante. O espectro resultante da absorção F, alargado e deslocado (mostrado na figura 49 (b) e (c)) são absorções características da mistura de centros F com o crescente número de pares de centros F-OH denominados centros FH(OH). A estru tura do centro FH(OH) é mostrada na figura 50. O processo descrito para a associação do centro F ao ion OH pode ser revertido conduzin do à dissociação térmica do complexo FH(OHT). A banda F alargada (devido o complexo FH(OH)) pode ser gradualmente modifi cada em direção à banda F normal se a amostra agregada for aquecida a temperaturas da ordem ou maiores do que 300 K no escuro. Monitoran do-se essa conversão de volta que acontece na absorção F ( curva 5+0 na figura 49 (b) e (c)) após o tratamento térmico por vários períodos de tempo em diferentes temperaturas (fixas), encontrou-se que esse

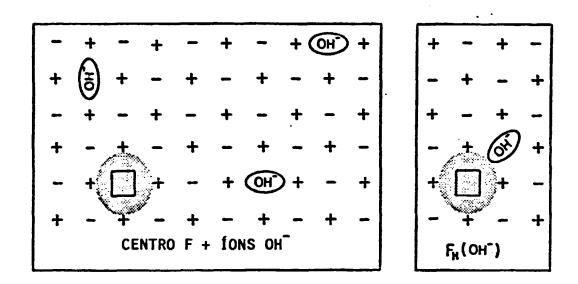


FIGURA 50. Esquema da estrutura iônica do centro  $F_H$  (OH<sup>-</sup>) nos haletos alcalinos com a estrutura do NaCl (visto pelo plano (100) do cristal).

processo de dissociação térmica obedece a lei exponencial do Arrhenius. Os resultados dessas medidas (Figura 51) mostram uma energia de ativação térmica de dissociação igual à 0,94 eV e um frequência igual à 1012 seg-1. Como é mostrado nessa figura (51), es ses valores são similares aos obtidos para a dissociação térmica do centro F<sub>A</sub>(Li) 52 mostrando que ambos defeitos possuem estabilidades térmica similares. Em ambos casos, o centro F deixa a posição associação ao defeito (Li<sup>+</sup> ou OH<sup>-</sup>) num processo de difusão por saltos com uma energia de ativação próxima à leV. Para fins práticos, importante notar que o centro FH (OHT) tem uma vida média da ordem de 10 horas na temperatura ambiente tal que permite o amostra opticamente agregada num intervalo de tempo suficientemente longo. Em todos os experimentos realizados nesses estudos, utilizou-se primeiramente sistemas não agregados onde o cristal possui uma tribuição estatística dos centros F e defeitos moleculares OH. Numa segunda etapa esses mesmos cristais (não agregado) foram transformados em sistema agregado obtido com a associação do centro F ao fon OH. A figura 52 mostra os resultados de vários experimentos realizados em cristais de KCl em função da concentração de OH para os dois estados: não agregado e opticamente agregado. O primeiro tipo de experiência (Figura 52) mostra um efeito pronunciado na eficiência de F (n<sub>lum</sub>) introduzido antes da agregação F ou seja, no estado inicial (com distribuição estatística) descrito na Figura 48. Enquanto que concentrações de OH da ordem de 10 partes por mol não efeito na emissão F do cristal não agregado, um decréscimo drástico dessa emissão F (e também de η<sub>1 μm</sub>) - por duas ordens de magnitu de - ocorre com o aumento da concentração de OH para 10 partes por mol. A agregação óptica posterior dos centros F (como descrito na Fi gura 49) produz um decreścimo ainda maior da emissão F, como é indi cado pelas setas na Figura 52. Mesmo nos cristais com pequena concen tração de OH (NOH- < 10 ) que no estado não-agregado apresenta uma emissão F com eficiência total (n<sub>111m</sub> = 1), ocorre razoável diminuição da emissão F com o processo de agregação óptica F → OH . Por outro lado, para os cristais com alta concentração de OH (> 10) a inten sidade da emissão F já se apresenta bastante reduzida para o estado inicial não agregado. Nesses cristais, o processo de agregação introduz um pequeno decreścimo extra na intensidade da emissão F cuja eficiência  $\eta_{lum}$  atinge nessas condições valores da ordem de 10.

Para centros F não perturbados e em quantidades diluídas  $(N_F < 10^{17} \, \text{cm}^{-3})$ , o processo de desexcitação radiativo em baixas temperaturas  $(T \le 77 \, \text{K})$  é o único meio de desexcitação do seu estado excitado relaxado (RES). Já em altas temperaturas (100 K  $\le T \le 200 \, \text{K}$ )

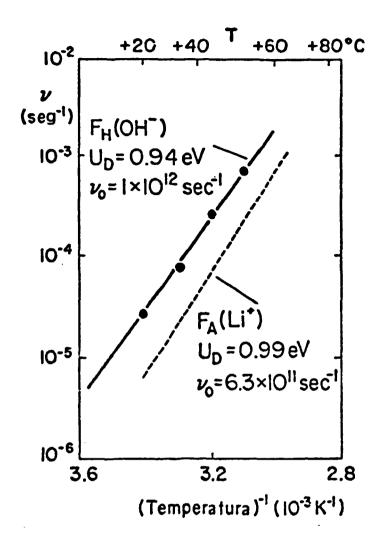


FIGURA 51. Curva tipo Arrhenius da taxa de dissociação térmica  $v_D$  de centros  $F_H$  (OH ) em KCl [em comparação com  $v_D$  dos centros  $F_A$  (L1)].

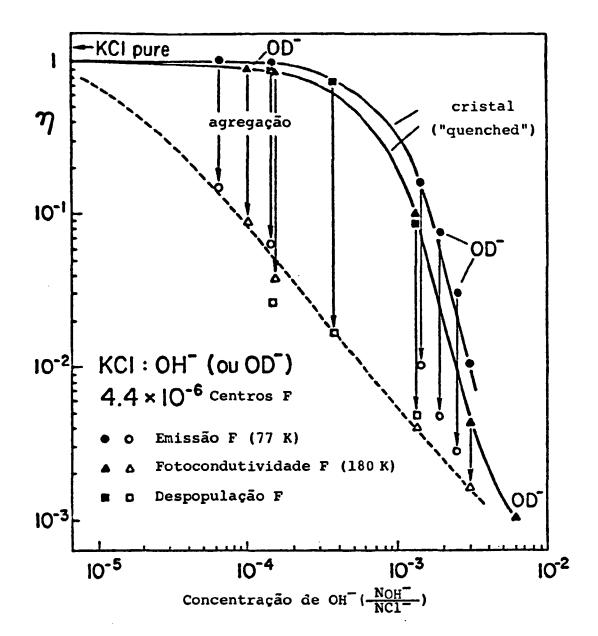


FIGURA 52. Gráfico di-logaritmo da emissão do centro F, fotocondutividade e despopulação do estado fundamental em função da
concentração de OH para KCl no estado não agregado
("quenched"), linha cheia, e opticamente agregado (linha
tracejada).

ocorre um mecanismo extra (efetivo) de ionização F onde o elétron é retirado do RES do centro F e liberado para a banda de condução através de um mecanismo termicamente ativado do tipo Arrhenius 57. Esse processo de ionização pode ser monitorado com alta sensibilidade pe las medidas da fotocondutividade. A Figura 53 exibe (numa escala logaritimica) a fotocondutividade típica do centro F em KCl puro como função da temperatura. O aumento drástico da fotocorrente por mais de duas ordens de magnitude devido o aumento da temperatura (77 K+180 K), reflete a lei de Arrhenius para o processo de ionização (do RES) ter micamente ativada. Nessa figura pode-se ver também que em temperaturas de ~ 180 K essa ionização atinge sua eficiência total e satura pos teriormente à 200 K.

As duas curvas (abaixo) na Figura 53 mostram as medidas da fotocorrente para dois cristais de KCl contendo altas concentrações de OH. Nesse caso, observou-se que a fotocondutividade é reduzida de l e de l à 2 ordens de magnitude respectivamente em todo o inter valo de temperatura (77 K → 300 K) medido. Posteriormente, a agregação óptica dos centros F aos ions OH produz uma redução ainda maior intensidade da fotocorrente como é indicado pelas setas que apontam para as curvas tracejadas da Figura 53. Novamente como no caso luminescência F - essa redução extra é muito maior no caso de amos tras contendo baixas concentrações de OHT (1074) do que ocorre amostras com alta concentração (10<sup>-2</sup>). Utilizando-se os valores das intensidades relativa da fotocorrente para o KCl puro à 180 K e con tendo diferentes concentrações de OH, construiu-se a Figura 53. Essa figura (53) mostra a eficiência da ionização F (medida através fotocondutividade) em KCl à 180 K em função da concentração de OH de 10<sup>-4</sup> a 10<sup>-2</sup>. Como pode ser visto nesse tipo de diagrama compreensivo, tanto a luminescência F à 77 K como a fotocorrente à 180 K exibem uma dependência identica de suas eficiências com a variação da concentra ção de ions OH. Isso foi verificado tanto para o estado do cristal não agregado como para o caso de centro F agregado.

Os elétrons liberados do RES termicamente (responsáveis pe la fotocorrente) podem eventualmente ser capturados por outros centros F produzindo centro F'. A taxa de conversão química de F em F' aumenta paralelamente com o aumento da fotocorrente e pode ser usada como um método alternativo para se determinar a taxa de fotoionização 57. Cabe observar que não foram feitas medidas da taxa de conversão de F + F', somente mediu-se o valor de equilíbrio F':F atingido em KCl à 180 K sob iluminação constante na banda de absorção F. A figura 54 mostra o resultado obtido em KCl (180 K) dopado com várias concentra ções de OH para o estado de cristal não-agregado e também para o

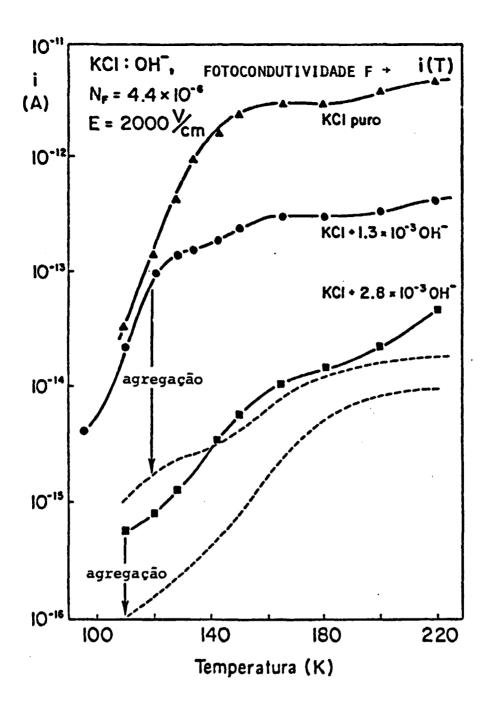


FIGURA 53. Dependência da fotocondutividade do centro F com a tempe ratura para uma amostra de KCl puro e duas amostras de KCl com duas concentrações altas de ions OH. Curvas cheia + para amostras no estado não agregado. Curvas tracejadas + para o estado agregado (F + OH).

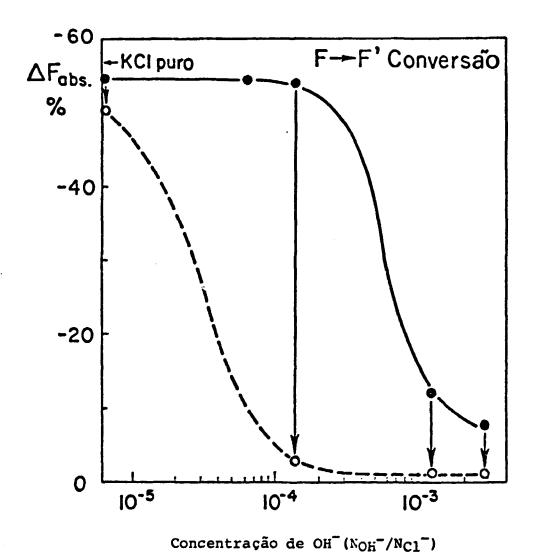


FIGURA 54. Redução máxima  $\Delta F_{abs}$  da banda de absorção F devido à conversão F  $\rightarrow$  F' em função da concentração de OH em KCl, para cristais não-agregados ("quenched") e opticamente agregados (F  $\rightarrow$  OH).

caso de sistema com centros F agregados aos ions OH. A redução de 55% da banda F devido a conversão de F + F' obtida no cristal puro é diminuida tremendamente para as amostras (não-agregadas) contendo concentrações de OH acima de 10 partes por mol. Após a agregação óptica dos centros F, é ainda mais difícil de converter F em F'. Es ses resultados confirmam os obtidos pela medida da fotocondutividade. Ambos mostram que a presença do defeito OH no cristal - ou numa distribuição estatística com os centros F ou preferencialmente agregados a eles - reduz o processo de ionização do estado eletrônico excitado relaxado (RES) do centro F.

No terceiro tipo de experimento (muito importante para a interpretação) mediu-se a dependência temporal da intensidade da sorção F durante e após a aplicação de um pulso de luz de excitação F de curta duração. A figura 55 mostra a cópia do traço original dido para esse efeito e que foi registrado pelo osciloscópio. gráfico mostra essencialmente o valor da transmissão ópticado cristal. em 514 nm (medido com laser de argônio) em função do tempo sendo que t= o coincide com a aplicação do pulso de excitação. A aplicação do pulso do laser bombeador (540 nm, 10 ns) despopula o estado fundamen tal do centro F produzindo um grande aumento na intensidade do feixe de luz de medida em 514 nm que é revertido pelo retorno gradual elétrons do estado excitado para o estado fundamental. O tempo de vida desse processo de repopulação do estado fundamental onde a centração de OH em KCl é muito pequena (10 ), é o mesmo que o tempo de vida da emissão radiativa normal ( $\tau_{lim} = 0.6 \mu seg$ ) como esperado. Duas agregações ópticas sucessivas dessa amostra ( inicialmente estado não agregado) reduziram drasticamente o aumento da transmissão óptica (em 514 nm) durante a aplicação do pulso dor, porém sem alterar a constante do tempo de decaimento. Na figura 56 são exibidos os resultados médios de medidas similares à apresen tada na figura 55 para várias amostras de KCl com concentrações dife rentes de OH. O cristal puro no estado inicial ( não - agregado) exibe o maior aumento da transmissão F inicial: 81% dos centros F são excitados em t=o.

Com o aumento da concentração de OH, a intensidade da mu dança da transmissão F inicial (em t= 0) é reduzida drasticamente porém mantendo a constante do tempo de decaimento. A agregação óptica afeta apenas ligeiramente o caso do centro F em amostra pura enquanto que produz grandes reduções no aumento da transmissão para as amostras contendo OH. Graficando-se a intensidade relativa do aumento da transmissão no instante da aplicação do pulso bombeador (t=0) em função da concentração de OH no diagrama compreensivo (figura 52),

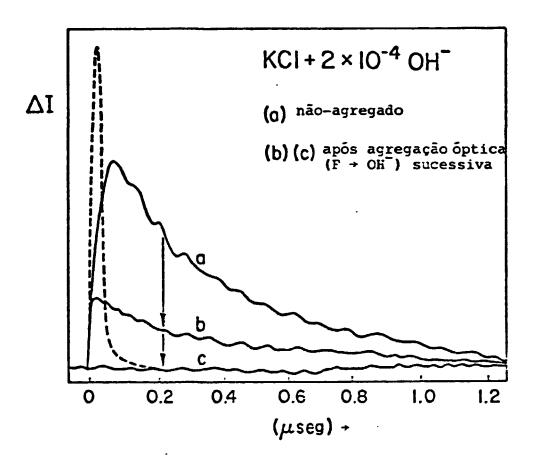


FIGURA 55. Exemplo de medidas (original) do tempo de decaimento da transmissão dos centros F após um pulso laser de excitação (em 540 nm) para um cristal de KCl dopado com OH;

- (a) Não-agregado.
- (b) e (c) Após duas sucessivas agregações ópticas (F+OHT).

A linha tracejada mostra o formato do pulso laser de excitação medido com o mesmo detetor (Si PIN-diode).

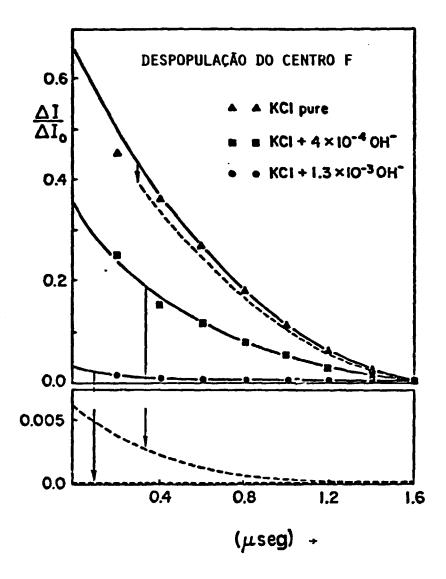


FIGURA 56. Mostra a amplitude atingida na despopulação inicial (t=0) do centro F e o decaimento do efeito no tempo para KCl pu ro e contendo duas concentrações diferentes de fons OH.

Curvas cheia → estado não-agregado. Curvas tracejadas → medidas após a agregação óptica F → OH.

verificou-se um ajuste quase perfeito com os resultados anteriores da luminescência F e fotocondutividade.

A seguir mediu-se o espectro de excitação de emissão infra vermelha dos centros de cor presentes nas amostras de KCl contendo OH para os dois estágios do cristal:

- I. não agregado
- II. agregado

O estado agreçado (II), nesse caso, consiste de um cristal tratado termicamente à 500°C e resfriado rapidamente à 20°C (no escu ro) e posteriormente submetido a uma iluminação F à - 10°C para produção não somente de centros F<sub>H</sub>(OHT) mas também para a formação de centros F2. Como pode ser visto na figura 57 (a), a quantidade de centros F, (que é caracterizado pela absorção M em 800 nm) é pequena. A figura 57 (b) mostra o resultado da medida da intensidade da emis são total dos centros F e F, em 1 e 1,2 µm em função do comprimento de onda da luz de excitação sintonizável entre 400 nm e 800 nm. Α emissão desses centros F e F, foi filtrada utilizando-se um filtro de silício de banda passante. No estado inicial não agregado (I) vou-se um pico de excitação dos centros F por volta de 520 nm. pico está achatado como o esperado devido a alta densidade óptica da banda F. Apesar do pequeno número de centros F, ([F,] << [F])inicial mente presentes, a luminescência F, (vista ou pela excitação 800 nm ou pela excitação da transição de alta energia em 500 nm) comparável com a intensidade da emissão F. A agregação óptica à -10°C (estágio II) elimina completamente a pequena luminescência F inicial acentuadamente a emissão dos centros F. Evidentemente e aumenta o forte efeito de "quenching" (introduzido pelo ion OH ) que reduz drasticamente a emissão F (ainda na distribuição estatística de cen tros F e OH ) e que elimina totalmente o resto dessa emissão após a agregação F -> OH, não é efetivo de modo algum no processo da emissão dos centros F. Dopando-se os cristais com ions OH conduz à poração inadvertida de impurezas CO, em quantidades bem do que [OH]. A fim de verificar se ocorre influência đa CO, nas propriedades do centro F, foram crescidos cristais de KCl com níveis de CO, muito maiores do que o de OH. As luminescência do centro F, nesses cristais, mostraram definitivamente que o efeito do "quenching" observado não foi causado pelo CO, ...

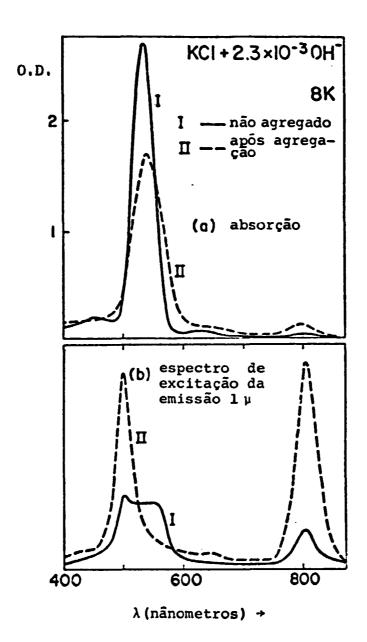


FIGURA 57. (a) Espectro de absorção óptica.

(b) Espectro de excitação da luminescência de l μ, medida à 8 K em cristal de KCl:OH colorido aditivamente, an tes (I) e após (II) e agregação óptica F → OH ã-10°C.

## VI.2. <u>Discussão e Mcdelo Proposto para o "Quenchine" da Lumines-</u> cência F em KCl:OH à 77 K

É evidente que mesmo no caso da distribuição estatística isto é, essencialmente centros F não associados aos ions OH, existe uma forte interação entre os dois tipos de defeitos. Essa interação não afeta a absorção do centro F que é encontrado virtualmente não alterado nos seus três momentos mais baixos:intensidade de oscilador, posição do máximo e largura da banda. Porém essa interação afeta pro fundamente os processos eletrônicos do estado excitado do centro F após a absorção. Antes de se fazer qualquer tentativa para explicar a natureza física dessa interação mediu—se a distância média sobre a qual essa interação é efetiva. Assumiu—se que no caso do cristal não agregado, os defeitos F e OH encontram—se distribuidos estatisticamen te . Negligenciou—se também as interações entre os centros F devido à pequena quantidade de centros F presentes ( $n_{\rm F} << n_{\rm OH}$ ). A fração de centros F  $\frac{n(R)}{n_{\rm F}}$  que terão somente um defeito OH na distância entre R e R+dR é dada por:

$$\frac{n(R)}{n_F} = \frac{4 \pi R^2}{R_0^3} \frac{NOH}{N} \left[ 1 - \frac{NOH}{N} \right] \left( \frac{4\pi}{3} R^3 / R_0^3 - 2 \right)$$
onde:  $R_0^3 = \frac{a^3}{4} = \frac{1}{N}$ 

$$a = parametro de rede$$

$$NOH^- \acute{e} a concentração de OH^-$$

$$N \acute{e} a concentração de Cl^- da rede$$

Integrando a equação 5 entre R<sub>1</sub> e R<sub>2</sub>, obtém-se:

$$\frac{n(R)}{n_{F}} \Big|_{R_{1}}^{R_{2}} = C \cdot \frac{N_{OH}}{N} \cdot \frac{1}{\log 1 - \frac{N_{OH}}{N}} \left[ (1 - \frac{N_{OH}}{N})^{\frac{4\pi}{3}} \frac{R^{\frac{2}{3}}}{R_{0}^{\frac{3}{3}}} - 2 \right]_{R_{1}}^{R_{2}}$$
(6)

A constante de normalização <u>C</u> é obtida assumindo-se que a integração da equação 6 entre R<sub>1</sub>= 0,7 a (distância mais próxima possível) e R<sub>2</sub>= 12 a dê 1, o que é bem justificado pela concentração de OH utilizada. A figura 58 mostra (histograma hachurado) a probabilidade de ocorrência de centros P com um fon OH à uma distância R como vizinho mais próximo. Essa distribuição de probabilidade foi calculada a partir da equação 6. Obviamente o máximo dessa distribuição de P e OH desloca-se para valores de R menores (em direção à R<sub>1</sub>) com o aumento da concentração de fons OH. A seguir considerou-se várias

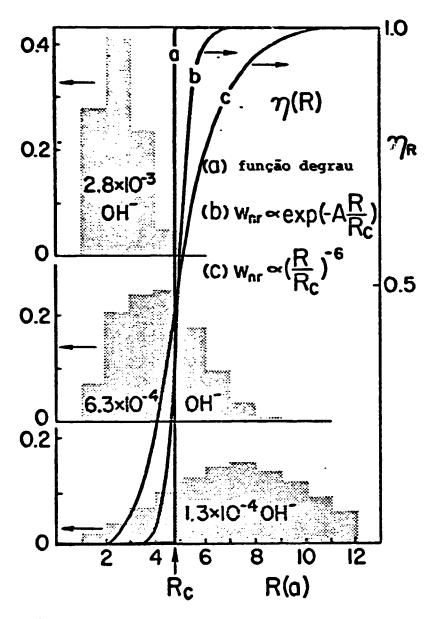


FIGURA 58. Áreas hachuradas Mostram a probabilidade estatística (es cala à esquerda) de ocorrência de defeitos Oh à uma dis tância R de centros F, calculada para três concentrações de OH.

Linhas Sólidas: mostram a dependência da eficiência ( $\eta_{1um}$  ou  $\eta_{10n}$ ) do centro F excitado à uma distância R de um fon OH vizinho mais próximo (escala à direita), calculada para três relações  $\eta(R)$  assumidas.

formas funcionais para a dependência espacial do efeito da interação entre F e OH, responsável pelo "quenching" da luminescência F e foto-ionização. O modelo mais simples é o que utiliza a função degrau. Essa função assume que:

- 1. Quando R > R<sub>C</sub>, odefeito OH não tem efeito algum nas propriedades do centro F isto é,  $\eta_{lum}$  e  $\eta_{ion}$  possuem os valores normais. À 77 K  $\eta_{lum}$  = 1 e  $\eta_{ion}$  = 0.
- 2. Quando R  $\leq$  R<sub>C</sub>, a luminescência F e ionização do centro F são completamente eliminados isto é,  $\eta_{lum} = \eta_{lon} = 0$ .

A fim de se obter a dependência da eficiência total de emis são F (à 77 K) em função da concentração de OH (para o KCl) calculou-se a seguinte somatória:

$$\eta \left( N_{OH} - \right) = \sum_{R_1}^{\infty} \frac{n(R)}{n_F} \times \eta \left( R \right) = \sum_{R_2}^{R_2} \frac{n(R)}{n_F} \times \eta \left( R \right) \tag{7}$$

η(R) representa as várias funções escolhidas para a dependência da eficiência do "quenching" da emissão F em função da distância de separação R do ion OH.

No caso de utilização da função degrau pode-se calcular a contribuição total da luminescência F integrando-se a equação 7 de  $R=R_C$  até  $R_a=12$  a e utilizando-se a distribuição  $\frac{n(R)}{n_F}$  da equação 6. Dessa forma obtém-se que a eficiência total de emissão F depende exponencialmente da concentração de fons OH de acordo com a equação 8.

$$\eta = \frac{\omega}{L} \frac{n(R)}{nF} \times 1 = \frac{R_2 = 12 \text{ a}}{R_C} \frac{n(R)}{nF} = \exp(-\frac{4\pi}{3} R_C^3 N_{OH}^{-1})$$
(8)

Para testar essa relação, graficou-se os valores medidos das eficiências (da figura 52) numa escala logarítimica versus os valores correspondentes da concentração de OH exibidos numa escala linear. Dessa maneira obteve-se sem dúvida uma linha reta cujo coeficiente angular propiciou o cálculo do valor do raio crítico ( $R_c$ ) da interação. O valor medido foi  $R_c$ = (4,75 ± 0,15) parâmetros de rece. Veja a figura 59 para a constatação desse comportamento linear.

Graficando-se a função degrau (obtida) no diagrama da figura 58, vê-se claramente como esta função divide a distribuição esta tística (entre centros F e OH) em centros F não luminescentes

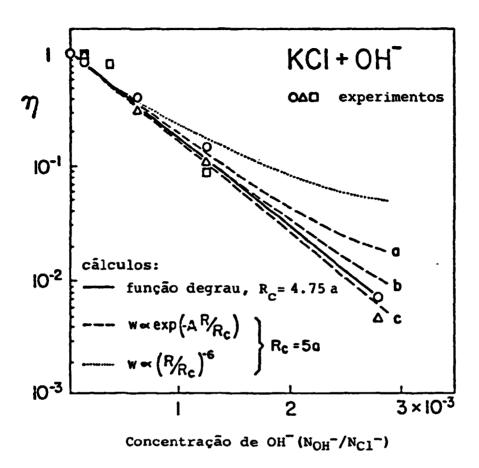


FIGURA 59. Gráfico monologaritmo da emissão (medida) do centro F (0), fotocondutividade ( $\Delta$ ), e despopulação do estado fundamental ( $\square$ ) em função da concentração de OH. A linha sólida representa, para  $\eta(R)$ , uma simples função degrau com  $R_C$  =  $4.75\,a$ ; a curva pontilhada representa um comportamento  $(R/R_C)^{-6}$ ; as curvas tracejadas representam três dependências exponenciais para  $\eta(R)$  com valores do parâmetro A diferentes, como discutido no texto.

\_\_-

 $(\eta = 0 \text{ p/R} < R_C)$  e centros F luminoscentes  $(\eta = 1 \text{ p/R} \ge R_C)$ .

Como o modelo da função degrau adapta-se extremamente bem e oferece uma magnitude correta para a distância média de interação  $(R_C)$ , ela deve ser substituída por uma função mais realística que mostre uma dependência gradual para  $\eta(R)$  sem apresentar descontinuidades (como ocorre na função degrau para  $R=R_C$ ). Para testar outras possíveis funções assumiu-se que a probabilidade da transição não radiativa  $\bar{\tau}_{nrad}^{-1}$  compete com a transição radiativa normal do centro F excitado (p/ KCl  $\bar{\tau}_{rad}^{-1}=1.73 \times 10^6 \text{ seg}^{-1}$ ) produzindo a seguinte eficiên cia quântica para a luminescência F:

$$\eta(R) = \eta_{rad} = \frac{\tau_{rad}^{-1}}{\tau_{rad}^{-1} + \tau_{prad}^{-1}}$$
(9)

A probabilidade de desexcitação não radiativa induzida pelo ion OH deve depender fortemente da distância R que os separa. Uma escolha possível válida para a interação do tipo dipolo-dipolo é a dependência do tipo  $\tau_{nrad}^{-1} = A.R^{-6}$ . O parâmetro A foi determinado assumindo-se que  $\tau_{nrad}^{-1} = \tau_{rad}^{-1}$  quando R= 5 a  $\tau_{rad}^{-1}$  Rc. Isso produz a dependência  $\tau_{rad}^{-1}$  cia  $\tau_{rad}^{-1}$  quando R= 5 a  $\tau_{rad}^{-1}$  Uma outra dependência funcional é a exponencial do tipo:

$$\tau_{\text{prad}}^{-1} = \tau_0^{-1} \exp(-AR)$$
 (10)

Escolhendo-se arbitrariamente que  $\bar{\tau_0}^1 = 10^{14}$  seg e também a condição anterior que impõe  $\eta = \frac{1}{2}$  quando R = 5 a  $= R_C$ , obtém-seadependência  $\eta$ (R) mostrada na curva (b) da figura 58.

A figura 59 mostra os resultados dos valores calculados para  $\eta(N_{OH}^{-})$  utilizando-se as equações 6, 7 e 9 e as seguintes funções para  $\tau_{nrad}^{-1}$ :

## 1. Função Degrau com R<sub>C</sub>= 4,75 a)

$$\eta(R) = 1$$
 para  $R > R_C$   
 $\eta(R) = 0$  para  $R \ge R_C$ 

## 2. Interação Dipolo-Dipolo

#### 3. Função Exponencial

$$\tau_{\text{nrad}}^{-1} = \tau_0^{-1} = \exp(-AR)$$

- a) A= 2,553 ,  $\overline{\tau_0}^1 \approx 6,06 \times 10^{11} \text{ seg}^{-1}$
- b) A= 3,627 ,  $\bar{\tau_0}^1 \approx 1,3 \times 10^{14} \text{ seg}^{-1}$
- c) A= 4,701 ,  $\overline{\tau_0}^1 \approx 2.8 \times 10^{16} \text{ seg}^{-1}$
- (R em unidades de parâmetro de rede).

Nessa figura (59) são comparados os valores experimentais com as curvas obtidas teoricamente. As seguintes conclusões foram  $t\bar{1}$  radas desses resultados:

- A) A dependência  $\tau_{nrad}^{1}$   $\alpha$   $R^{-6}$  assumida para uma interação do tipo dipolo-dipolo <u>não</u> é capaz de explicar o compo<u>r</u> tamento observado.
- B) O fator pré-exponencial  $\tau_0^{-1}$  da lei exponencial assumida precisa ter um valor grande ( $\tau_0^{-1} \ge 10^{14} \text{ seg}^{-1}$ ) para que seja obtido o ajuste da curva teórica com os dados experimentais. Em outras palavras, a dependência de  $\tau_{\text{nrad}}^{-1}$  (R) ou de  $\eta_{\text{rad}}$  (R) precisa ser fortemente dependente de R em tôrno de R= R<sub>C</sub> isto é, deve aproximar-se muito do comportamento da função degrau (figura 58) para que se reproduza a dependência  $\eta_{\text{F}}$  ( $N_{\text{OM}}$ -).

Após termos estabelecido as condições funcionais e os limites para a distância de interação F-OH, levantamos ainda a seguinte questão: Qual é a natureza da interação F + OH que produz a desexcitação F não radiativa? Uma interpretação atrativa seria a seguinte: A energia de excitação eletrônica do centro F após a relaxação (~ 1 eV) é transferida efetivamente em excitação do modo vibracional (hv = 0,45 eV) do fon OH próximo. Essa excitação vibracional da molécula OH poderia então ser dissipada radiativamente ou não radiativamente.

Nós testamos experimentalmente (com técnicas similares as utilizadas na referência 23), se ocorre uma emissão vibracional com energias menores do que 0,5 eV sob um intenso bombeamento óptico da absorção dos centros F tanto no estado agregado como no estado não agregado. O resultado dessa tentativa foi totalmente negativo. Uma possível emissão vibracional OH deve possuir uma pequena eficiência quântica n < 10<sup>-3</sup> (se existir) para ser compatível com o experimento sensível realizado. Um outro reforço para esse quadro negativo de transferência da energia de excitação eletrônica em vibracional do

portraining the second miles and the second

OH provêm do fato que ambos defeitos CH e OD produzem o mesmo efeito no "quenching" da emissão F apesar de que a energia vibracio nal do OD, é menor do que para o OH,  $v(OD^-) = v(OH^-)/\sqrt{2=0,32}$  eV Nesse modelo, a energia da emissão F seria compensada por 3 vao invés de 2 v quando se muda de OH para OD. Isso implicaria numa acentuada diminuição do efeito de interação de ions OD com centros F quando se compara com a intensidade da interação obtida no caso do OH, para uma mesma concentração de ions OH e OD.

Um outro tipo de interpretação em princípio poderia ser tentado assumindo-se que a energia da emissão F fôsse transferida para a excitação libracional (rotacional) do fon OH. A energia básica dessa libração em KCl é 300 cm<sup>-1</sup> 60, com excitações mais fracas localizadas em energias maiores 60 em 383 cm<sup>-1</sup> e 407 cm<sup>-1</sup>. Porém, novamente ocorre dificuldade quando se compara os efeitos do fon OH e OD. A energia libracional também diminue por um fator 1//2 no caso do fon OD fazendo com que seja altamente improvável que os dois tipos de moléculas (OD e OH) produzam exatamente o mesmo efeito de "quenching" da emissão F no modelo suposto de transferência de energia de excitação eletrônica em vibracional ou libracional da molécula OH ou OD.

As observações mais importantes que devem ser consideradas no modelo físico são:

- A) A total independência da eficiência e velocidade de <u>de</u> sexcitação do F observada na grande variação isotópica (-1,4) tanto da frequência vibracional como da libracio nal do OH.
- B) O fato que apenas o estado excitado relaxado do centro F com uma função de onda bastante extendida, e <u>não</u> o esta do excitado compacto do centro F<sub>2</sub>, é afetado drastica mente pelo ion OH dentro de uma distância até 5 parâme tros de rede ou ~ 32 Å.

A última observação indica que a ampla extensão espacial da função de onda do RES do centro F (detectado até ~ 5 parâmetros de rede afastado da vacância<sup>54</sup>, veja a figura 60) provoca uma superposição e interação com o OH distante até 5 a produzindo estados excitados perturbados e deslocalizados. A questão principal ainda é a mesma: porque esse estado interativo F - OH produz um tempo de vida curto para a desexcitação (não radiativa) do elétron para o estado fundamental? Uma idéia atrativa para essa questão é a seguinte: O de feito OH que possui um dipolo elétrico grande (p - 1 e Å) e que em KCl à T > 10 K reorienta-se extremamente rápido ( $\tau_{\rm dip}$  >> 10 de que em

#### NÚMERO DA CAMADA DO HALETO

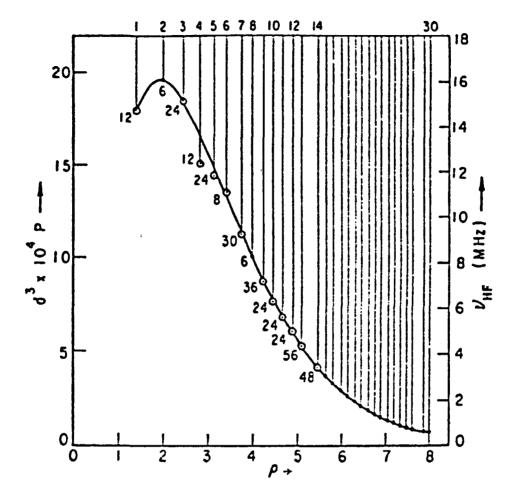


FIGURA 60. Densidade de probabilidade, P(ρ) (vêzes d³), de encontrar o elétron F no estado excitado relaxado 2p̃ em função de ρ (ρ é medido em unidade da distância entre vizinhos mais próximos no KI, d= 3,525 Å), obtida por L.F. Mollenauer e G. Baldacchini tilizando a técnica de ENDOR no KI contendo centros F.

induzir oscilações rápidas entre os dois estados eletrônicos possíveis do sistema atrativo e repulsivo. Se o lado positivo do dipolo OH (H\*) estiver dirigido para a distribuição eletrônica do RES do centro F, ele funcionará atrativamente sobre o elétron F deslocando sua trajetória e sua energia total, enfim mudando o estado relaxado F. Por outro lado, a reorientação do dipolo OH colocando o lado negativo (O) na direção do F repelirá o elétron (excitado) de volta à vacância colocando-o num estado repulsivo do qual o elétron relaxa para o estado fundamental a través de um processo não radiativo pouco eficiente (eficiência = Tdip = 10<sup>-4</sup> em T = 77 K) (\*\*). Portanto são necessárias 10° oscilações entre os estados atrativo e repulsivo antes da ocorrência da desexcitação eletrônica não radiativa. Dois tipos de experimentos decisivos foram rea lizados e que confirmam essa idéia:

- Medidas do tempo de repopulação do estado fundamental utilizando pulsos de luz laser excitadora na escala de pico segundos (~ 20 ps).
- Experimentos sobre medidas da luminescência F em outros haletos alcalinos tais como KBr, RbCl e RbBr que apresen tam uma taxa de reorientação dipolar do ion OH da mesma ordem que a taxa de desexcitação radiativa do centro F (τ<sup>-1</sup><sub>dip</sub> < 10<sup>6</sup> seg<sup>-1</sup>), pelo menos em baixas temperaturas (10K). Nesse caso deve-se esperar alta eficiência de luminescên cia F em temperaturas baixas (10K) no cristal não agrega do mesmo contendo alta concentração de OH (- 10<sup>-2</sup>). Sob o aumento da temperatura entretanto, a taxa de reorientação dipolar τ<sup>-1</sup><sub>dip</sub> aumenta drasticamente e torna-se numa certa temperatura igual e então maior do que τ<sup>-1</sup> (F<sub>1um</sub>). A emis são F nessas redes (RbCl, KBr e RbBr) deve secaracterizar com alta eficiência em baixas temperaturas (10K), e diminuição drástica para valores η \* 10<sup>-2</sup> em altas temperaturas.

## VI.3. MEDIDAS DO TEMPO DE REPOPULAÇÃO DO ESTADO FUNDAMENTAL DO CEN TRO F EM KCl:OH (77 K)

Como já foi discutido anteriormente, neste capítulo, a presença da impureza OH dentro de um raio de até - 5 parâmetros de rede, introduz uma desexcitação (eficiente) não radiativa com um tempo de vida menor ou da ordem de algumas dezenas de nanosegundos. Isso é o

<sup>(\*)</sup> Esiciência estimada p/KCl + centros F (não agregado) c/NOH- =  $10^{-5}$  onde a distância média R entre um centro F e o ion OH-  $\bar{e} \le R_c$ . A 77 K  $T_{dip} = 10^{-13}$  e  $T_{nrad} = 10^{-5}$ s.

que se concluiu das medidas do tempo de repopulação do centro F após a excitação com um "dye laser" bombeado pelo laser de excimeros (XeCl) pulsado (com 10 ns de duração). Entretanto para se medir realmente es se tempo de repopulação, fêz-se necessário utilizar um laser pulsado "mode-locked" (com pulsos de - 10<sup>-11</sup> segundos de duração). Como não se dispunha desse equipamento (laser "mode-locked") na Universidade de Utah, realizou-se tais experimentos no Departamento de Química Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em colaboração com o grupo do Professor El-Sayed. O equipamento experimental utilizado consta de um laser pulsado (10 Hz) de Nd: YAG da Quantel com 1,5 jou les por pulso (maximo) e "mode-locked" (- 30 ps) cuja frequência de emissão de luz em 1,053 microns foi duplicada por um cristal KD,PO. que produziu uma linha de luz verde (530 nm) que está em ressonância com a frequência da luz de absorção dos centros F em KCl. O feixe de laser emitido em 530 nm foi dividido em dois; um de fraca intensicade que foi utilizado para a medida da transmissão da banda F e para bombear a maioria dos centros F para o estado excitado despopu lando o estado fundamental durante a aplicação do pulso. A medida do tempo de retorno dos elétrons F não foi observada diretamente osciloscópio e sim pela técnica de correlação do atraso ou adiantamen to do pulso de medida com relação ao pulso de excitação. Os dois pul sos são gerados simultâneamente, porém eles percorrem distâncias di ferentes (variável). Enquanto que o pulso de excitação percorre uma distância fixa e é focado no cristal, atenuado pela absorção F monitorado, o pulso de medida (baixa intensidade) percorre uma distân cia variavel podendo chegar antes, coincidente ou atrasado com rela ção ao pulso de excitação (bombeador). Esse pulso de medida atinge o cristal de forma quase colinear com o pulso de excitação. Ele também sofre uma atenuação de intensidade que é proporcional ao número de centros F que permanecem no estado fundamental e é finalmente monito rado por um outro detetor de silicio. Na posição de coincidência (entre os dois pulsos) ocorre a medida do aumento da transmissão da banda F que decai gradativamente com o constante retardamento do pul so de medida. A medida da transmissão do cristal para cada tempo de retardamento, é feita acumulando-se o sinal (enviado pelo detetor ) durante aproximadamente 50 excitações através do uso de um Box Car integrador modelo 162 (PAR) funcionando no modo A/B (A,B diferentes canais).

A figura 61 mostra um sinal típico medido nesse espectrôme tro para uma amostra de KCl contendo 9,4 x 10<sup>-6</sup> OH<sup>-</sup> colorida aditiva mente e não agregada. A intensidade da despopulação do centro F obtida em quase todos os casos foi da ordem de 20 à 25%. Nessa figura vê-se o aumento da transmissão ocorrido na posição coincidente e o

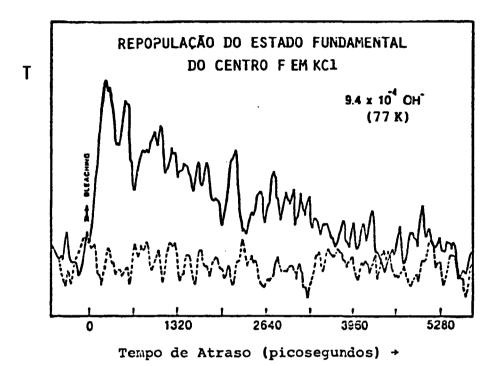


FIGURA 61. Rápida repopulação do estado fundamental do centro F em KCl:OH (não agregado) medida após o "bleaching" da banda F produzido no espectrômetro de detecção de pulsos com atraso variável na escala de picosegundos. T= transmissão óptica na banda F (em 540 nm).

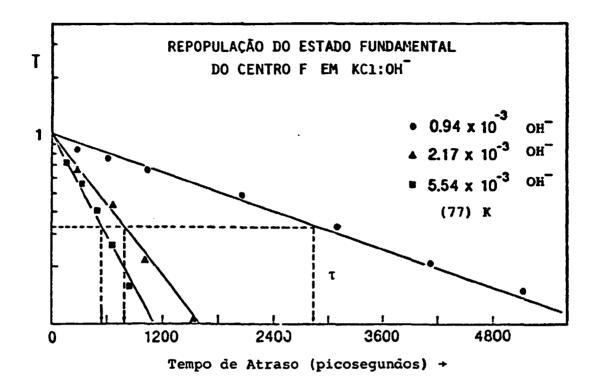
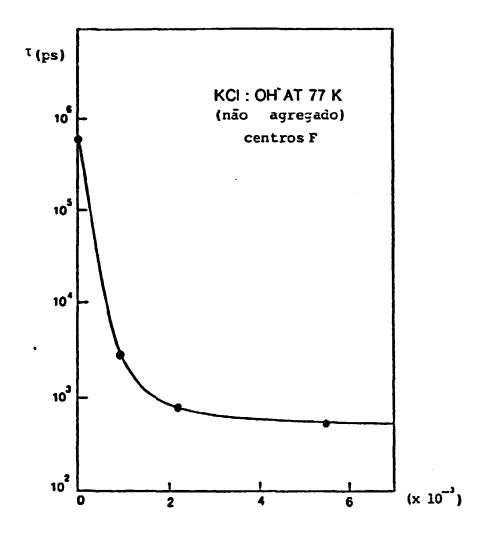


FIGURA 62. Mudança da transmissão da banda F (à 77 K) em KCl:OH (não agregado) em função do tempo de repopulação do estado ls do centro F, na escala de picosegundos, para três amos tras contendo concentrações diferentes de OH. T + indica o valor da vida média do estado excitado do centro F alterado pela presença do ion OH. T + transmissão óptica (nor malizada) da banda F (escala logaritmica).



Concentração de OH (NOH /NC1)

FIGURA 63. Tempo de vida médio (t) de repopulação do estado fundamen tal (1s) do centro F pedido em KCl à 77 K em função da concentração de CH. ps + picosegundos.

posterior decaimento para o seu valor inicial. A figura 62 mostra a variação da transmissão da banda F (à 77 K) graficada numa escala logarítimica em função do tempo de retardamento, numa escala linear para três amostras contendo diferentes concentrações de OH. curvas mostram que o decaimento da transmissão da banda F obedece uma lei do tipo exponencial da qual retirou-se o valor médio do tempo de retorno do elétron para o estado fundamental do centro F.A figura 63 mostra claramente o efeito da concentração OH no tempo de vida concentrações do estado excitado do centro F em KCl (à 77 K). Para OH pequenas (- 10 ) observa-se um tempo de vida muito próximo do tempo de vida da transição radiativa do centro Fou seja 5,8 x 105 ps. Com o aumento dessa concentração para ~ 10 OH , a desexcitação tor na-se não radiativa e extremamente rápida atingindo um valor -750 ps (que é o valor de saturação). O tempo de desexcitação F na presença do ion OH pode ser diminuido de até 3 ordens de grandeza. Esses re sultados confirmam as predições efetuadas na Seção VI.1.1. e reforçam o modelo proposto para a interação F-OH-.

## VI.4. ESTUDOS DA CORRELAÇÃO DO "QUENCHING" DA EMISSÃO F COM A VARIAÇÃO DA TAXA DE REORIENTAÇÃO DIPOLAR DO ÎON OH

Até agora mostrou-se (capítulo VI) que os processos eletrô nicos que ocorrem no estado excitado relaxado (RES) do centro F em KCl tornam-se drasticamente alterados pela presença de altas concen trações de OH (10 - 10 - 10 ) na rede cristalina. Todas as três quan tidades características do centro F\* - a luminescência F, a fotoioni zação e o tempo total de retorno para o ciclo óptico sistematicamente e intensamente com o aumento da concentração de OHT. No estado não agregado do cristal (com F e OH distribuídos estatis ticamente) o efeito observado pode ser ajustado por um modelo fenome nológico que envolve o "quenching" total da emissão e fotoionização F para a distância crítica de até 5 parâmetros de rede (Rc 25a)entre o centro F e o ion OH vizinho mais próximo. A interpretação qualita tiva desse efeito foi baseada no fato que a função de onda do centro F embora mais compacta durante o processo de absorção, torna-se bas tante espalhada com o processo de relaxação dos ions K<sup>†</sup> ao seu redor. Dessa maneira ocorre uma forte superposição com o fon OHT até 5 parametros de rede. A questão principal entretanto ainda conti nua: porque e como esse "estado interativo" produzido pelo centro F excitado e o ion OH produz uma desexcitação não radiativa eficiente e com um tempo de vida muito curto?

Anteriormente, no final da Seção VI.2., foi levantada uma

especulação interessante à respeito dessa questão. Nesse caso foi assumido que o campo elétrico do dipolo OH funciona atrativamente ou repulsivamente para o elétron F dependendo da direção do seu dipolo de modo que a reorientação dipolar induz oscilações entre esses dois estados causando a desexcitação não radiativa. Nesse modelo, a efi ciência do processo induzido depende fortemente da taxa ou velocidade de recrientação dipolar do ion OH. Até agora, os experimentos desse tipo foram realizados apenas em matrizes de KCl onde o ion reorienta extremamente rápido mesmo em baixas temperaturas (treor ≤10<sup>-16</sup> seg. p/ T ≥ 10 K). Para testar essa especulação exten deu-se as medidas da emissão F em três materiais diferentes (KBr, RbCl, RbBr) que pelo menos em baixas temperaturas (- 10 K) possuem uma taxa de reorientação Oï muito menor do que en KCl de modo que nessas matrizes, o tempo de recrientação dipolar em T 10 K é major do que o tempo de vida do estado excitado do centro F. Essa investigação foi feita sempre em cristais coloridos aditivamente. No primeiro tipo de sistema utilizado trabalhou-se com cristais não agregados ("quenched") isto é, contendo uma distribuição estatística de centros F e ions OH. A figura 64 mostra como a intensidade da luminescência dos cen tros F em KBr e RbCl depende da concentração de OH e da temperatura. Evidentemente no estado não agregado, a presença de F e OH associados produz nos dois materiais, alta eficiência de luminescên cia F em baixas temperaturas (10 K) e uma drástica redução eficiência com o aumento da temperatura (η<sub>lum</sub> = 0.8 → η<sub>lum</sub> = 10<sup>-2</sup> quando T = 10 K + 100 K).

Em todos os casos aqui investigados, mediu-se sempre a in tensidade dessa emissão F em comparação com a intensidade da emissão F na mesma matriz pura e mesma temperatura. Os resultados mostrados na figura 65 (a) estão parcialmente em contraste com os resultados apresentados na figura 65 (b). No RbBr:OHT, a luminescência F que à 10 K é intensa (n<sub>lum</sub> = 0,7), decresce apenas uma ordem de magnitude com o aumento da temperatura para 100 K. Em KCl:OH por outro lado, observa-se uma emissão F muito fraca (- 81 de eficiência) já em bai xas temperaturas (10 K) e decresce ainda mais (- 1% de eficiência) com o aumento da temperatura até 100 K. É importante mencionar que todas as matrizes estudadas não apresentaram uma banda F perturbada (isto é, alargada) para o estado não agregado. Para esse agregado), mediu-se também o tempo do decaimento da luminescência F em função da temperatura através da observação direta da intensidade da emissão monitorada num osciloscópio. O cristal de KBr puro mostra (figura 66) apenas um pequeno decrescimo da luminescência F integrada e também uma pequena diminuição do tempo de vida de emissão

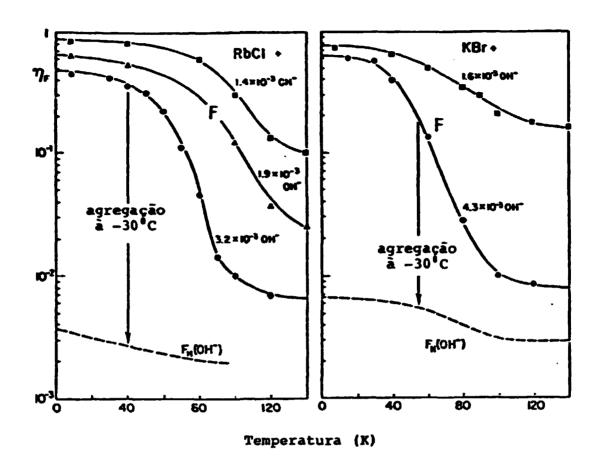


FIGURA 64. Eficiência da emissão F (η<sub>F</sub>) medida experimentalmente <u>pa</u> ra RbCl:OH e KBr:OH em função da temperatura. As curvas cheias foram obtidas para o estado não agregado. As curvas tracejadas indicam os valores obtidos após à agregação óp tica dos centros F aos íons OH.

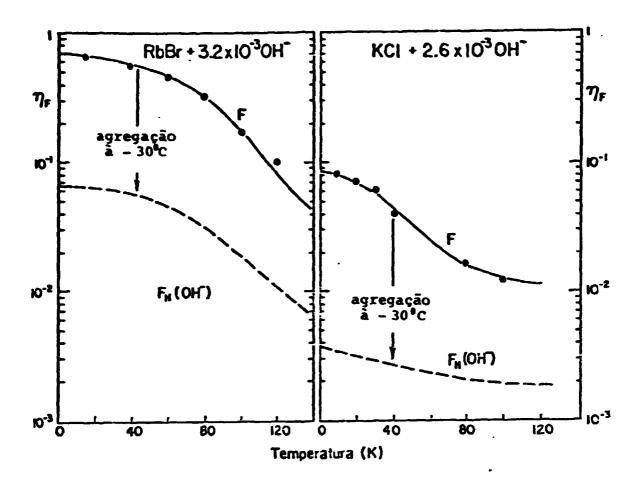
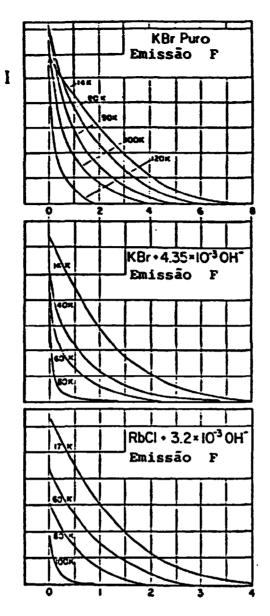


FIGURA 65. Eficiência da Emissão F (η<sub>F</sub>) em KCl:OH e RbBr:OH em função da temperatura. Linha cheia + medidas experimentais / para o estado não agreçado. Linha tracejada + medidas após a agregação óptica F + OH â - 30°C.



Tempo (microsegundos)

FIGURA 66. Emissão do centro F excitada por um pulso laser sintoniza do na banda F (duração 10 ns) em KBr puro, KBr:OH e RbCl:

:OH em função da temperatura. A área sob a curva de decai mento dá a emissão F integrada para o sistema não agregado.

F com o aumento da temperatura de 10 K para 100 K como o esperado. Em contraste à isso (veja a figura 66) observa-se um decréscimo gradual da intensidade da emissão F (e também do tempo de vida) com o aumen to da temperatura nas matrizes de KBr e RbCl contendo alta concentração de OH. Esse efeito está em boa concordância com a observação da forte dependência da eficiência da emissão F com a temperatura como foi exibico anteriormente na figura 64.

O segundo tipo de experimento aqui realizado consistiu do uso dos mesmos cristais coloridos que após o "quenching" foram subme tidos à uma iluminação (na região da banda F) fraca e controlada à - 30°C. Esse processo de agregação de F ao ion CHT (como já foi des crito anteriormente) não produziu os centros de agregados de F do tipo F, F, etc..., e sim somente o efeito de alargamento e deslocamen to da banda F. Esse efeito é indicado na figura 67 (curvas cheias)pa ra 4 haletos alcalinos diferentes. Em todos esses casos, o centro F forma o par F-OH (chamado de FH(OH)), que exide um " quenching " total da luminescência F basicamente independente da temperatura como pode ser visto pelas curvas tracejadas das figuras 64 e 65. A banda de absorção do centro FH (OHT) em KCl, RbCl e RbBr exibe um comporta mento normal isto é, um alargamento e deslocamento da banda para o vermelho comparado à banda F pura. Essa figura (67) mostra também que esses dois efeitos de perturbação na banda de absorção Faumentam com o parâmetro de rede. A figura 68 mostra (para o RbBr que é também um dos casos normais) que a dependência da posição do máximo e da meia largura da banda FH(OH) com a variação da temperatura é suave monotônica como foi observado para a banda F pura. Observou-se porém que a banda FH (OHT) comporta-se de maneira anômala em KBr. Em tempe raturas baixas, essa banda (em KBr) desloca-se para energias maiores do que à do máximo da banda F e possui uma meia largura aproximada mente igual à meia largura da banda F (figura 67). A variação espec tral dessa banda em KBr (posição e meia largura) é mostrada numa ou tra figura (69) à fim de ilustrar as fortes mudanças induzidas nessa banda na região de baixas temperaturas (T < 50 K). Também efetuou-se um diagrama mostrando a dependência da posição do máximo e da meia largura da banda FH(OH) em KBr com a variação da temperatura ( figu ra 70). Nessa figura pode-se notar o grande desvio de comportamento que ocorre (no intervalo de temperatura entre 10 → 50 K) com relação ao comportamento genérico do centro F. A banda Fg (OHT) comporta - se mais normal (em KBr) de modo semelhante ao comportamento encontrado nos outros materiais (diferentes do KBr) quando a temperatura atinge valores maiores do que 50 K.

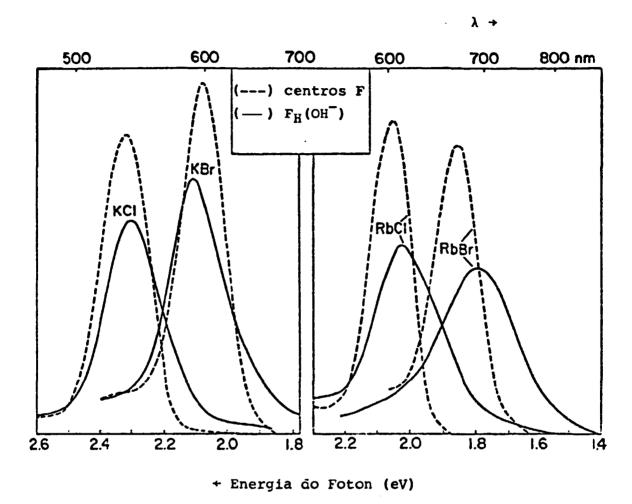


FIGURA 67. Banda de absorção do centro F<sub>H</sub>(OH<sup>-</sup>) em vários haletos alcalinos (-) em comparação com a banda de absorção prove - nientes dos centros F (---). Medidas de absorção à 10 K.

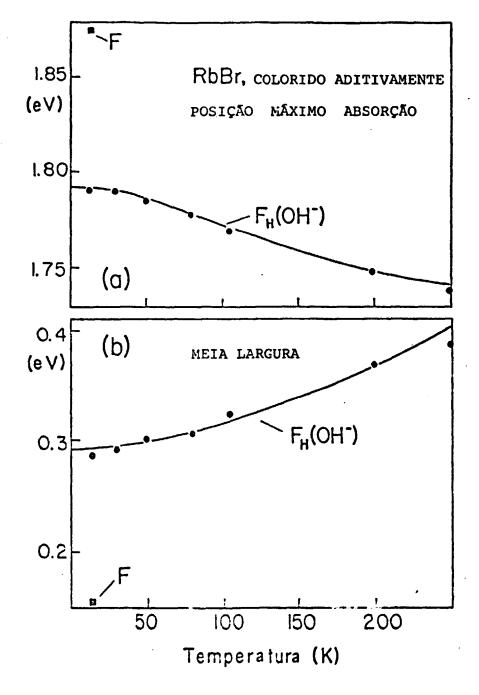


FIGURA 68. Variação do máximo e da meia largura da banda de absorção do centro F<sub>H</sub> (OH<sup>-</sup>) em função da temperatura para uma amos tra de RbBr:OH<sup>-</sup> colorida aditivamente.

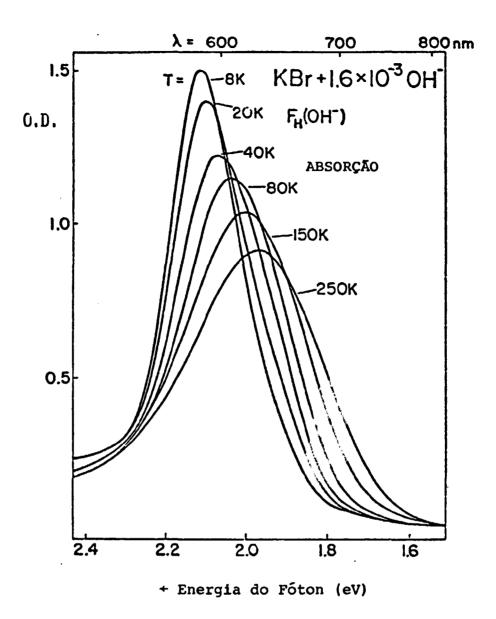


FIGURA 69. Comportamento espectral anômalo da banda de absorção do centro  $F_{\rm H}({\rm OH}^-)$  em KBr em função da temperatura.

#### VI.4.1. Análise dos Dados

É evidente (dos resultados experimentais apresentados nas seções anteriores), que existe uma interação forte entre os doistipos de defeitos F e OH, mesmo ainda para o caso dos centros não agrega dos aos ions OH. Essa interação não afeta a absorção do centro F porém altera drasticamente os processos eletrônicos que ocorrem após a absorção. Especialmente na Seção VI.4., mostrou-se que existe uma correlação qualitativa entre o efeito produzido na desexcitação F e a variação da taxa de reorientação dipolar do ion OH. Essa taxa de reorientação pode ser alterada (ou variada) de duas maneiras.Simples mente alterando-se a temperatura da amostra ou mudando-se de rede hos pedeira32. Nesta seção estamos interessados em estudar essa correla ção (luminescência F +> taxa de reorientação OH ) de forma quantitativa, utilizando-se os resultados já apresentados na seção anterior. Para isso serão utilizados os resultados das amostras que contenham somente alta concentração de OH (de 3 à 4 x 10 3) que ofe rece uma simplificação do sistema interagente. Os seguintes motivos justificam essa escolha:

- A maioria dos centros F, nesse caso de alta concentra ção de OH, possuem um ion OH dentro do raio critico de 5 parâmetros de rede, segundo a distribuição estatisti ca calculada para o KCl e mostrada pela figura 58.
- 2. Nesse caso, a contribuição principal para o "quenching" da luminescência F deve vir da temperatura que é a quan tidade física responsável pela alteração da taxa de reorientação do OH.

Para essa concentração de íons OH, o centro F deve apresentar uma desexcitação não radiativa independente de R ( distância en tre o centro F e o íon OH mais próximo) para R < R<sub>C</sub> (R<sub>C</sub> = 5 a) considerando que os dados experimentais ajustam-se muito bem à função de grau. Portanto espera-se que esses cristais com 3-4 x 10= 0H apresentem uma intensidade de luminescência F modulada principalmente pela temperatura.

A figura 71 descreve a correlação obtida entre o tempo de reorientação do dipolo OH (inverso da taxa de reorientação) e a eficiência da luminescência F em função da temperatura e da rede hospe deira. Por exemplo, observa-se alta eficiência de emissão F quando a taxa da reorientação OH é comparável com a taxa da transição radiativa do centro F. Esse é o caso do KBr e RbCl em temperaturas - 10 K. Para decrescer a eficiência da luminescência F para o valor 0,08

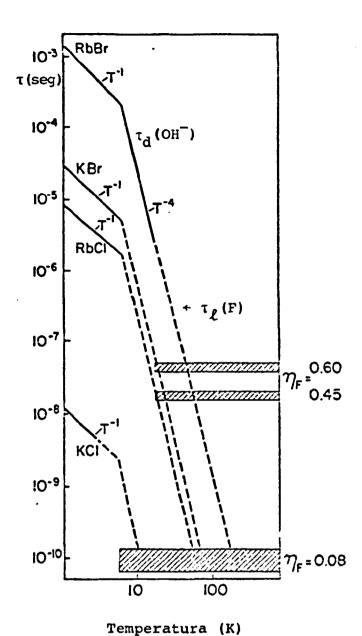


FIGURA 71. Correlação entre o tempo de reorientação dipolar do fon OH (τd(OH)) em função da temperatura (lei + T e T e) e a eficiência da luminescência (observada) dos centros F (ης + região achureada). τ<sub>ℓ</sub>(F) + meia vida da luminescência F para KCl à 77 K.

(nesses cristais) precisa-se aumentar a taxa de reorientação do OH para um valor - 10<sup>10</sup> seg<sup>-1</sup>, se a extrapolação do comportamento T' - / verificado para a variação da taxa de reorientação OH em temperaturas baixas (4-10 K) - for ainda válido próximo de 100 K. Essa taxa de reorientação (10<sup>10</sup> seg<sup>-1</sup>) que é atingida já à 10 K no KCl ou à 70 K no KBr e RbCl, introduz um processo de desexcitação F não radiativo bas tante eficiente produzindo uma emissão F muito fraca com eficiência 0,08.

Foi possível correlacionar a eficiência da luminescência F em KBr e RbCl com a variação da taxa de reorientação OH atravês da mesma lei (T). Assumindo-se que a probabilidade  $\tau_{nr}^{-1}$  da transição não radiativa (induzida) do centro F excitado seja proporcional a T e assumindo também que a probabilidade  $\tau_{r}^{-1}$  da transição radiativa do centro F isolado seja constante, espera-se que a razão  $\tau_{nr}^{-1}$  /  $\tau_{r}^{-1}$  seja proporcional a T essa razão de probabilidades pode ser escrita em termos da razão entre as eficiências medidas  $\eta_{nr}$  e  $\eta_{r}$  onde  $\eta_{nr}$  é a eficiência da transição não radiativa (induzida no centro F) e  $\eta_{r}$  é a eficiência da emissão F. Considerando-se que  $\eta_{r}$  +  $\eta_{nr}$ = 1 e que:

1) 
$$\eta_{F} = \frac{\tau_{F}^{-1}}{\tau^{-1}}$$
,  $\eta_{nr} = \frac{\tau_{nr}^{-1}}{\tau^{-1}}$ 

onde τ é o tempo de vida média total do centro F excitado.

2) 
$$\tau_{nr}^{-1} \alpha T^{b}$$
,  $\tau_{r}^{-1} = cte$  obtém-se que:
$$\frac{\eta_{nr}}{\eta_{r}} \alpha T^{b}$$
(11)

onde <u>b</u> é um parâmetro à ser ajustado utilizando-se os dados exper<u>i</u> mentais.

Utilizando-se os dados experimentais da figura 64, calculou-se os valores da razão  $\eta_{nr}$  /  $\eta_F$  em função da temperatura para os cristais de KBr e RbCl (não agregados). A figura 72 mostra o resultado do a valores graficados para a razão  $\eta_{nr}$  /  $\eta_F$  medida (normalizando se  $\eta_F$ = l em T= 10 K) versus a temperatura numa escala duplamente logaritimica. O resultado é sem dúvida, um comportamento linear entre 10 e 70 K, tanto para o KBr como para o RbCl. O coeficiente angular medido para a reta experimental (da figura 72) é igual a 4 o que verifica o expoente da lei  $T^b$  assumida (b=4). A observação dessa lei  $T^b$  para o intervalo de temperatura entre 10 K e 70 K está em excelen

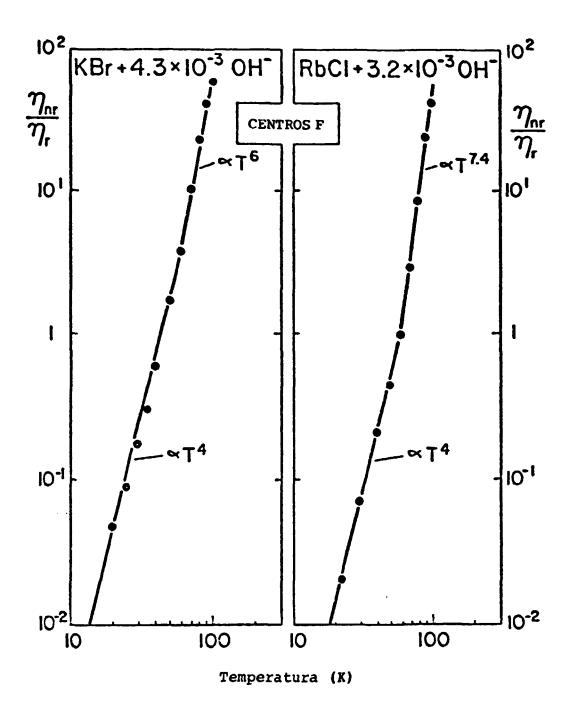


FIGURA 72. Razão medida entre a eficiência de desexcitação não radiativa e a eficiência de luminescência do centro F em função da temperatura para duas amostras (não agregadas), KBr e RbCl, contendo alta concentração de OH. -> Verificação da lei T no intervalo de temperatura entre 10 e 70 K.

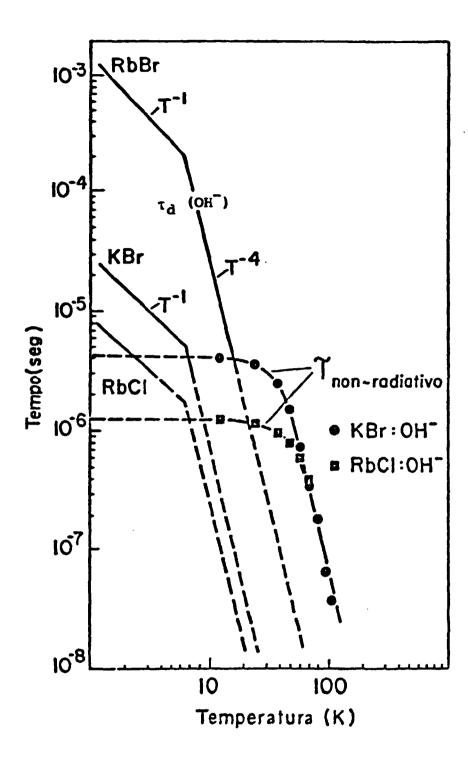


FIGURA 73. τ<sub>nr</sub> (vida média para desexcitação não radiativa do centro F\*) em função da temperatura (escala di-logarítmica) para duas amostras (não agregadas), KBr e RbCl contendo espectivamente 4,3 x 10<sup>-3</sup> e 3,2 x 10<sup>-3</sup> OH<sup>-</sup>.

te concordância com o comportamento observado 1 e esperado 2 para a variação da taxa de reorientação OH com a temperatura.

Utilizando-se a relação 
$$\frac{\eta_{nr}}{\eta_{F}} = \frac{\tau_{nr}^{-1}}{\tau_{r}^{-1}}$$
 e os valores da razão

 $\eta_{nr}$  /  $\eta_{F}$  (obtidos da figura 64), calculou-se o tempo de vidada transição não radiativa ( $\tau_{nr}$ ) em função de T para o KBr e RbCl. Nesses calculos utilizaram-se os valores de  $\tau_{r}$  conhecidos na literatura, para o centro F em KBr e RbCl. A figura 73 mostra que o tempo de vida da transição não radiativa ( $\tau_{nr}$ ) obedece também a lei T tanto para o KBr como para o RbCl. A medida que a temperatura aumenta, a taxa de reorientação OH aumenta com T induzindo um crescente aumento na probabilidade de desexcitação não radiativa que também cresce com T. Em consequência disso, o tempo de vida da transição não radiativa decresce rapidamente obedecendo a mesma lei T.

# VI.5. EFEITO DA IMPUREZA OH $^-$ NAS PROPRIEDADES DE REORIENTAÇÃO DOS CENTROS $F_2$ e $F_2^+$ EXCITADOS COM LUZ POLARIZADA EM KCl

Foi mostrado nesse tipo de estudos que o tempo de reorienta ção dos centros F<sub>2</sub> e F<sub>2</sub> torna - se mais rápido em KCl contendo concentração de fons OH (- 10 ) quando comparado com o tempo nor mal de reorientação no KCl puro. Usualmente inicia-se esse tipo de experiência com cristais de KCl:OH coloridos aditivamente (com cen tros F não agregados) e montados no porta amostra e resfriados até 8K sem exposição à luz visível. Após a medida de absorção à 8 K, iniciase o processo de agregação dos centros F iluminando-se a amostra com luz verde (ressonante com a banda F) proveniente de uma lâmpada de xenônio de 150 W, por ~ 10 minutos à 0°C para a formação de centros F, (ou M) principalmente. Esse tempo de iluminação é suficiente para a produção preferencial de centros F.. Nesse caso, não ocorre a forma ção de complexos maiores como os centros F3, F4 ...etc. Durante processo de agregação F, a maioria dos centros F, são produzidos pró ximos dos ions OH que afetam bastante as propriedades de reorienta ção do F2 . Em temperaturas baixas esse centro pode preferencialmente na direção <110> iluminando-se com luz (500 nm) po larizada na direção <110> e ressonante com a transição eletrônica com momento de transição perpendicular ao eixo de simetria do centro F1 absorção principal de major energia)61. Portanto o centro F, que ini cialmente orientado na direção <110>, reorienta-se para a <110> após a absorção de luz (500 nm) polarizada na direção emissão de luz em 1050 nm. Sob essas condições de excitação polarizada

do centro F<sub>2</sub>, observa-se uma intensidade de emissão IR inicialmente intensa que gradativamente diminue à medida que os centros F<sub>2</sub> vão se reorientando na mesma direção da luz polarizada. Nessa orientação os centros F<sub>2</sub> não absorvem mais a luz excitadora e a intensidade cai para um valor baixo (≠0) porém estável que corresponde a um pequeno número de centros que ainda absorvem e emitem independentemente da polarização da luz de excitação.

A figura 74 mostra o efeito da reorientação do centro F, em KCl puro a fim de comparar com o que ocorre no KCl contendo OH. Como esse mecanismo de reorientação é termicamente ativado 1, mediu-se a dependência desse efeito em função do tempo de iluminação em várias temperaturas. Cabe mencionar que esse mecanismo torna-se mais eficiente à 50 K e que à 10 K não se reorienta.

A figura 75 mostra os resultados obtidos para o mesmo tipo de sistema porém em KCl contendo - 10<sup>-3</sup> OH. Nesse caso (KCl:OH) o centro F, reorienta-se à 9 K com uma constante de tempo menor (reorientação mais rápida) do que ocorre em KCl puro (mesmo à 80 K). O mesmo efeito também é observado para o caso dos centros F, que é basicamente um centro F, ionizado.

Os centros  $F_2^+$  estão sempre presentes (nos cristais color<u>i</u> dos aditivamente) em pequenas quantidades porém podem ser facilmente detectados pela eficiente emissão vermelha em 605 nm (no KCl à 10 K) devida à transição radiativa  $2p \mu + 1 s \sigma g$ . Essa transição também con duz à reorientação do centro, da orientação <110> para <110>. Seme lhante ao caso do centro  $F_2$ , o centro  $F_2^+$  também absorve em 500 nm que corresponde à transição eletrônica  $1 s \sigma g + 2p \pi u$  (absorção ) e emi te em 605 nm  $(2p\pi \mu + 1 s \pi g)$  em T < 50 K ou emite em 1670 nm  $(2p\pi \mu + 1s \sigma g)$  para temperaturas acima de 50 K.

A figura 76 mostra o efeito da impureza OH na reorientação do centro  $F_2^+$  em KCl:OH e compara com os efeitos normais que ocorrem para o KCl puro. Novamente o efeito da impureza OH é o de diminuir o tempo de reorientação. À 9 K, o centro  $F_2^+$  (em KCl:OH) reorienta-se mais rápido do que em KCl puro à 60 K.

Tendo em vista esses resultados propõem-se que o efeito observado na reorientação dos centros F<sub>2</sub> e F<sub>3</sub> provém do fato que o intenso campo elétrico (oscilante) do dipolo do ion OH mistura os dois estados excitados relaxados da configuração do centro F<sub>2</sub> provo cando a relaxação iônica (ao redor do defeito) que conduz à reorientação rápida e independente da temperatura. Esse modelo pode ser tentativamente verificado. Para isso basta substituir-se o campo elétrico (AC) interno do ion OH por um campo elétrico externo DC de alta intensidade (~ 100-200 KV / cm).

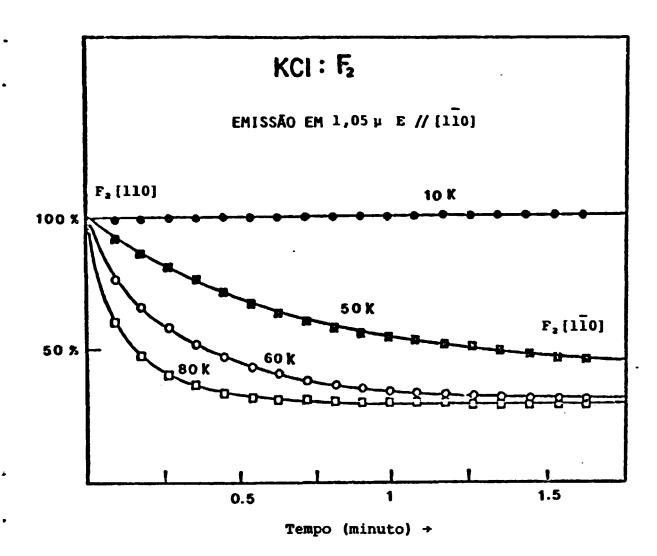
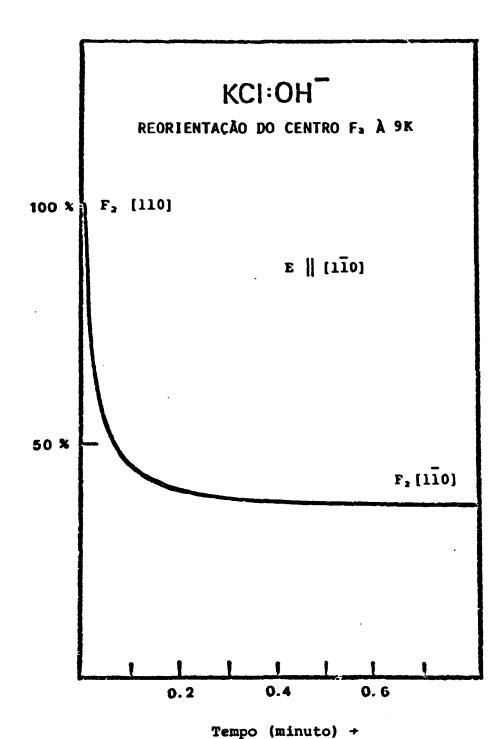


FIGURA 74. Efeito da reorientação do centro F<sub>2</sub> (inicialmente preferencialmente alinhados na direção [110]) em KCl puro para várias temperaturas: 10, 50, 60 e 80 K. Notar que τ<sub>M</sub> (puro) + ∞ para T ≤ 10 K.



Tempo (minuco) +

FIGURA 75. Efeito da reorientação do centro F, ({110}  $\rightarrow$  {110})em KC1: :OH (10 ) (após a agregação F  $\rightarrow$  F, à  $\rightarrow$  10°C) à 9 K.Notar que  $\tau_{M}$  (OH ) <<  $\tau_{M}$  (puro).

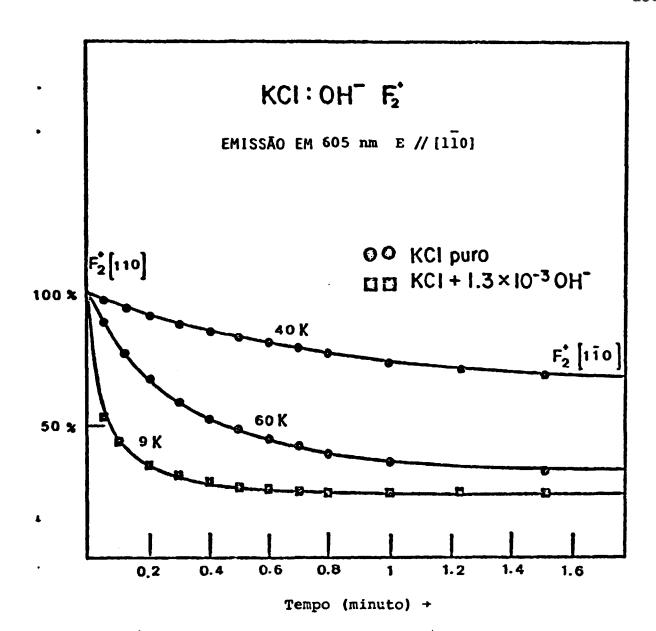


FIGURA 76. Efeito da reorientação do centro  $F_2^+$  ([110]  $\rightarrow$  [110] em KCl puro (medido à 40 e 60 K) e com 1,3 x  $10^{-3}$  OH (medido à 9 K), obtido após a agregação óptica  $F \rightarrow F_2$ ,  $F_2^+$  à  $-10^{\circ}$ C.A reorientação do centro  $F_2^+$  foi observada diretamente pela medida da intensidade da emissão vermelha em 650 nm polarizada e excitada com a linha 514 nm do laser de argônio.

1. O "quenching" da luminescência F em KCl (não agregado) à 77 K pôde ser ajustado satisfatoriamente por um modelo estatístico que utiliza uma função degrau com um raio crítico R<sub>C</sub> (para a distância média efetiva da interação F-OH).

Mediu-se que  $R_c$ = 4,8 <u>a</u> ou - 31 Å. Mostrou-se que uma ou tra função mais realistica do que a função degrau, deve aproximar-se desta função obedecendo a seguinte eficiên cia de emissão:

 $\eta = 0$  quando  $R \leq R_C$ 

 $\eta = 1$  quando  $R > R_C$ 

2. A forte dependência da luminescência F com a temperatura, nas redes de KBr e RbCl contendo ~ 3,5 x 10<sup>-3</sup> OH<sup>-</sup>, mos trou que quantitativamente o mecanismo de desexcitação não radiativo do centro F<sup>\*</sup> depende extremamente da velo cidade de reorientação do dipolo OH<sup>-</sup> que por sua vêz depende tanto da rede hospedeira como da temperatura (T<sup>\*</sup>).

A reorientação do ion OH (dentro de um raio de - 5 a ) produz oscilações do elétron F entre os estados localizados do tipo atrativo e repulsivo cuja frequência de oscilação é modulada pela taxa de reorientação do ion OH. Os resultados (figura 73) encontrados indicam que em média são necessárias - 10 oscilações entre esses estados para provocar a desexcitação não radiativa do centro F (T = 77 K).

3. Os centros F são capturados e aprisionados na segunda vizinhança do ion OH em consequência do processo de agregação F → OH controlado. Nesse caso, ocorre um aumento ainda maior na redução da luminescência, ionização e redução do tempo de vida do centro F. Em quase todos os cristais aqui estudados (exceção do RbBr) obtém-se nesse caso, uma eficiência de emissão - 0,01 e quase independente de T. Em todos os cristais utilizados foi possível de se produzir o centro FH(OH) em consequeência do processo de agregação F → OH. E em todos os casos houve um alargamento e deslocamento da banda F para o vermelho. A

desexcitação eletrônica do centro  $F_H$  (OHT) é sempre não-radiativa, muito rápida (-  $10^{-12}\,\mathrm{seg}$ ) e independente da temperatura.

## VI.7. PROPOSIÇÃO DE NOVOS EXPERIMENTOS

- 1. Deve-se medir o tempo total de retorno do elétron F (na interação com o ion OH) para o KCl, KBr e RbCl (não a gragados) em função da temperatura (entre 10 + 100 K) para várias concentrações fixas de OH.
- 2. O mesmo tipo de medida deve ser efetuado para o cristal contendo somente o centro  $F_H(OH^-)$ . Esses dois experimentos envolvem a técnica de detecção de sinais pulsa dos na escala de tempo de pico segundos (principalmente para o caso do  $F_H(OH^-)$ ). Dessa forma será possível calcular os valores da probabilidade de desexcitação não radiativa  $(\tau_{nr}^{-1})$  em função da temperatura e da distância R (entre o centro F e o íon OH $^-$ ), ajudando portanto no aprimoramento do modelo proposto.

CAPÍTULO VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ATUAÇÃO DO ÍON OH NOS PRO CESSOS ELETRÔNICOS DOS HALETOS ALCALINOS

Nesse capitulo pretende-se <u>resumir</u> os efeitos (influências e/ou alterações) provocados nos processos eletrônicos dos haletos alcalinos pelo ion OH

Deve-se considerar dois casos distintos:

- 1) Com o ion OH no estado excitado.
- 2) Com o ion OH no estado fundamental.
- 1. O estudo compreensivo da fotodissociação do ion OH nos diversos haletos alcalinos mostrou que essa impureza produz armadilhas (sub produtos da quebra do OH) eficientes na captura dos elétrons livres (de condução ou elétrons provenientes da ionização de outros defeitos). Esses elétrons podem ser portanto, produzidos pelo dano de radiação na sub rede aniônica dos haletos alcalinos. Dois tipos de armadilhas (provenientes da fotodissocia ção do OH) foram observadas:
  - a) Armadilhas profundas:  $\square$  (centro  $\alpha$ ) e  $OH_{1}^{0}$  (moléculas  $OH^{0}$  intersticiais).
  - b) Armadilhas rasas: [e] (centro F) que podem produzir estados meta estáveis.

O caso (a) foi observado principalmente nas redes de KI, RbBr e RbI onde a fotodissociação do fon OH produz (so mente nessas matrizes) diretamente vacâncias aniônicas ( ) e moléculas OH intersticiais (quando a fotodis sociação é efetuada em temperaturas T > 50 K). Vacâncias aniônicas também podem ser produzidas indiretamente na destruição dos centros Os em KCl, KBr, e RbCl(como foi verificado experimentalmente na irradiação UV de alta intensidade em KBr:OH). As vacâncias aniônicas e as moléculas OH intersticiais participam de maneira efeti va no aprisionamento dos elétrons de rede produzidos pe lo dano de radiação na sub rede aniônicas. Isso conduz à um excesso de produção de vacâncias aniônicas disponíveis, aumentando portanto, a probabilidade de formação dos centros de agregados de F (ionizados) como o centro

F; por exemplo. O fato de que a impureza OH aumenta a produção de centros F; em KCl sob irradiação com elétrons de alta energia (1,5 MeV) já havia sido observado experimentalmente por Luty em 1980 (63). A produção de armadilhas rasas (b) observada nas matrizes de KI e RbI onde a desexcitação eletrônica do ion OH (em T > 77 K) produz diretamente centros F, e funcionam como armadilhas temporárias para os elétrons da rede. Isto é, os elétrons gerados pelo dano de radiação na rede são aprisio nados pelos centros F produzindo temporariamente o centro F' (vacância aniônica + 2 elétrons). Essa situação favo rece a formação de centros de agregados de F neutros, como os centros F, F, ...etc.

Considerando que os produtos da fotodissociação do ion OH sempre introduzem armadilhas (rasas ou profundas)pa ra os elétrons produzidos na rede, é fácil predizer que esta impureza tem o carácter de aumentar ou favorecer a formação de centros de agregados de F ionizados (como o centro  $F_2^+$ ) e consequentemente pode realmente interferir diminuindo a probabilidade de formação de centros de a gregados de F com excesso de elétrons. Isso também foi observado experimentalmente por Luty et al em 1964 (64) onde verificaram que a impureza OH presente no cristal de LiF diminue drasticamente a formação de centros  $F_2^-$  (centro com excesso de elétrons) durante o dano de radia ção à 300 K com elétrons de alta energia (2 MeV).

- 2. Uma vêz produzido centros F na rede cristalina, ou por irradiação de alta energia (raios-X ou elétrons) ou por coloração aditiva ou eletrolítica da amostra, o centro OH ainda presente na rede pode influenciar e interferir nos processos de desexcitação de defeitos eletrônicos do tipo F e também de seus agregados F<sub>2</sub>, F<sub>2</sub><sup>+</sup>. Foi verificado dois efeitos principais:
  - a) Indução de uma desexcitação rápida (~ 10<sup>-12</sup> seg) e não radiativa em centros eletrônicos que possuem uma função de onda (para o estado excitado) bastante espalhada. Esse foi o caso observado experimentalmente e discutido no Capítulo VI. Nesse caso ocorre a indução de uma desexcitação não radiativa eficiente (ηης ≈ 1)

para uma distância média de até 5 parâmetros de rede (- 31 A) de separação entre o centro F e o ion OH em KCl. Esse efeito é modulado pela taxa de reorientação do dipolo elétrico do ion OH que é extremamente dependente da temperatura. A eficiência da transição não radiativa induzida no centro F por reorientação dipolar é pequena. Uma estimativa mostrou que são necessárias - 10 reorien tações do dipolo OH para provocar o retorno não radia tivo do elétron F para o estado fundamental (15) do centro F.

b) Aumento da velocidade de reorientação de alguns cen tros de agregados de F como os centros F, e F, quan do excitados nas suas absorções mais energéticas (transição eletrônica lszg → 2pmµ com momento transição perpendicular ao eixo de simetria do defei to). O campo elétrico intenso proveniente do cipolo elétrico do ion OHT elimina a pequena barreira energé tica que impede o deslocamento do anion da vizinhança do defeito para a posição intermediária que produz a configuração de ponto de sela. Essa configuração de ponto de sela (possível para o centro F2 excitado em T > 50 K) é responsável pela reorientação do defeito. Em cristais puros contendo centros F, e F, essa bar reira energética existente entre as duas configurações possíveis do estado excitado: configuração de vacân cia (tipo H<sub>2</sub><sup>+</sup>) e configuração de ponto desela (tipo H<sub>3</sub><sup>+</sup>) é - 0,06 eV e limita a possibilidade de reorientação do defeito somente em temperaturas acima de 50 K65. Porém com a presença do ion OH nas proximidades do centro F2, F2, a reorientação mencionada ocorre em qualquer temperatura e com uma velocidade muitas  $v\underline{\hat{e}}$ zes maior.

O aumento da probabilidade de reorientação do centro  $F_2$  e  $F_2^+$  excitados, provoca a rápida difusão do defei to por saltos, aumentando assim a chance de recombinação do centro de agregado de F ionizado  $(F_2^+)$  com o seu elétron que foi aprisionado em alguma armadilha existente no cristal. Essa recombinação decresce o número de centros  $F_2^+$  disponíveis por exemplo, durante um bombeamento óptico do cristal dentro da cavidade (óptica) e consequentemente diminue o ganho do sistema para a obtenção da inversão de população e ação laser do centro  $F_2^+$ .

Finalizando, cabe dizer que este estudo visou dar uma con tribuição ao conhecimento das propriedades dos haletos alcalinos do pados com impurezas moleculares como o OH. A metodologia empregada obedeceu as duas abordagens distintas: uma fenomenológica e portanto mais qualitativa e a outra mais quantitativa sendo que em ambos os casos pretendeu-se explorar as possibilidades clássicas e quânticas do papel da impureza OH. A relevância deste estudo prende-se ao fato de que estudos como este são precursores de aplicações tecnológicas importantes como os lasers de centros de cor e mais recentemente os lasers vibracionais.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. J.A.L. ROBERTSON Irradiation Effects in Nuclear Fuels, Gordon and Breach Science Publishers, N.Y. 1969.
- 2. D.POOLEY and W.A. SIBLEY Color Centers and Radiation Damage, AERE-R 7347 (1973).
- 3. J. ROLFE Phys. Rev. Letters 1, 56 (1958).
- 4. H.W. ETZEL and D.A. PATTERSON Phys. Rev. 112, 112 (1958).
- 5. W. KANZING, H.R. HART and S. ROBERTS Phys.Rev.Letters, 13, 543 (1964).
- 6. K. BRUGGER and W.P. MASON -Phys.Rev.Letters 7, 270 (1961).
- 7. B. FRITZ, F.LÜTY and J. ANGER, Z. Physik 174, 240 (1963).
- 8. M.V. KLEIN Phys.Rev. <u>122</u>, 1393 (1961).
- 9. F.KERKOFF, Z. Physik <u>158</u>, 595 (1960).
- 10. J.A. CAPE Phys.Rev. 122, 18 (1968).
- 11. F. LÜTY J.Phys.Chem.Solids 23, 677 (1962).
- 12. U. KUHN and F. LÜTY Solid State Comm. 2 , 281 (1964). ←
- 13. A.S. NOWICK and W.R. HELLER Adv. Phys. 12, 251 (1963).
- 14. S. KAPPHAN and F. LÜTY J.Phys.Chem.Solids 34, 969 (1973).  $\leftarrow$
- 15. H. HÄRTEL and F. LÜTY Phys. Stat. Solidi 12, 347 (1965). -
- 16. C.J. DELBECQ, B. SMALLER and P.H. YUSTER Phys.Rev. <u>104</u>, 599 (1956).
- 17. G. SCHAEFER J. Phys. Chem. Solids 12, 233 (1960).
- 18. B. FRITZ J. Phys. Chem. Solids 23, 375 (1962).
- 19. A. HAUSMANN Z.Phys. 192, 313-328 (1966).
- 20. H. HARTEL and F. LUTY Z.Physik 177, B69 (1963). A
- 21. D.S. PAN and F. LÜTY Phys.Rev. Bl8, 1868 (1978). 4-

- 22. Y. KONDO and F. LÜTY Sol. State Commun. 40, 325, (1961). 4
- 23. Y. YANG and F. LÜTY Phys. Rev. Lett. 51, 419 (1983).
- 24. SIEVERS et al, Optics Letters (april 1984).
- 25. B. WEDDING and M.V. KLEIN Phys. Rev. 177, 1274 (1969).
- 26. M.V. KLEIN, B. WEDDING and M.A. LEVINE Phys. Rev. 180,902 (1969).
- 27. E. SONDER and W.A. SIBLEY Point Defects in Solids, Vol. 1, Cap. 4, ed. J.H. CRAWFORD JR. and C.M. SLIFKIN - Plenum Press, N.Y. 1972.
- 28. M.N. KABLER Point Defects in Solids, Vol.1, Cap.4, ed. J.H. CRAWFORD, JR and C.M. SLIFKIN Plenum Press, N.Y. (1972).
- 29. Y. TOYOZAWA Proceedings of the 1974 International Conference or Color Center in Ionic Crystals, Sendai, Japan, Communication \*D45.
- 30. G. ZIBOLD, Kerr Effect in Alkali Halides Due to Para Electric Defects (Cap.I) Tese de Doutoramento Utah (1971).
- 31. H. KOSTLIN Z.Physik 204, 290 (1967).
- 32. S.E. KAPPHAN A Study of Paraelectric Defects in Alkali Halides
  Crystals with Optical and Caloric Methods (Cap.II) Tese de
  Doutoramento Utah (1970).
- 33. R.S. KNOX Theory of Excitons Sol.Stat.Suppl. 5, 62 (1963).
- 34. W. MARTIENSSEN J. Phys. Chem. Sol. 2, 257 (1957).
- 35. H. KÖSTLIN Solid State Commum. 3 , 81 (1965).
- 36. D.A. PATTERSON and M.N. KABLER Solid State Commun. 3,75 (1965).
- 37. D.G. CHAE and B.G. DICK J. Phys. Chem. Solids 34, 1683 (1973).
- 38. C.K. CHAN, M. KLEIN and B. WEDDING Phys.Rev.Letters 17, 521
- 39. F. FISCHER Z.Physik 187, 268 (1965).
- 40. G. KURZ Phys.Stat.Solidi 31, 93 (1969). 4-
- , 41. S.P. MORATO Photodecomposition and Reactions of Hydroxyl and Hydrogen Defects in Potassium Chloride Crystals Tese de Doutoramento Utah (1975).

- 42. F. FISCHER Z. Physik 204, 351 (1967). 4-
- 43. J.M. SPAETH Z.Physik 192, 107 (1966).
- 44. L. GOMES and S.P. MORATO Solid Stat Comm. 41, 653 (1982).4-
- 45. A.G. BADALYAN and P.G. BARANOV -Phys.Stat.Solidi(b) 97, 95 (1980).  $\times$
- 46. CHR. HOENTZSCH and J.M. SPAETH Sol. Stat. Comm. 29, 577 (1979)
- 47. L. GOMES Tese de Mestrado USP (1978).
- 48. S.P. MORATO and L. GOMES J. de Physique. 7, C6-155 (1980).
- 49. W. RUSCH and H. SEIDEL Solid State Comm. 9, 231 (1971).
- 50. W. RUSCH and H. SEIDEL Phys. Stat. Solidi (b). 63, 183 (1974).

っく

- 51. F. LCHSE, G. REUTER and J.M. SPAETH Phys.Stat.Solidi(b) 89, 109
  (1978).
- 52. F. LUTY Physics of Color Centers, W.B. FOWLER Editor, Academic Press, N.Y. (1968). Capítulo 3.
- 53. D.S. PAN and F. LUTY Light Scattering in Solids, Chapter IX.
- 54. L.F. MOLLENAUER and G. BALDACCHINI Phys.Rev.Letters. 29, 465 (1972).
- 55. L.F. MOLLENAUER Methods of Experimental Physics, Vol. 15B, Aca demic Press (1979).
- 56. G. SPINOLO Phys. Rev. Vol. 137, A 1495 (1965).
- 57. H. FEDDERS, H. HUNGER and F. LUTY, Phys. Chem. Solids. 22, 299 1961).
- 58. A.G. BADALYAN and P.G. BARANOV Sov.Phys.Solid State. 22 , 2020 (1980).
- 59. L. GOMES and S.P. MORATO Radiation Effects. 73, 139 (1983).
- 60. DAVID HARRISON. Ph.D. Thesis, University of Utah, (1970).
- ) 61. S. KAPPHAN and F. LUTY Solid State Commum. 8, 349 (1970).
- ,62. B.G.DICK and D. STRAUCH. Phys. Rev. B2, 2200 (1970).

- 63. W. GELLERMANN, F. LUTY, K.P. KOCH and G. LITFIN Phys. Stat. 7

  7) Solidi, A57, 411 (1980).
- 64. F. LUTY Invited Paper on the Symposium of Optical Properties of Solids and Physics of Surfaces, México, July 17-20, (1979).

## CURRICULUM VITAE

NOME ..... LAERCIO GOMES

LOCAL (nascimento) ...... São Paulo - Brasil

DATA (nascimento) ..... 02 de abril, 1950

#### UNIVERSIDADES

•

- Universidade Estadual de Campinas UNICAMP Instituto de Física São Paulo, 1972 1975.
- Universidade de São Paulo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares São Paulo, 1976 1985 (pós-graduação).

### TÍTULOS

- Bacharel em Física, 1975 UNICAMP
- Mestre em Ciências, 1978 USP Dissertação: "Centro H<sub>2</sub>C nos H<u>a</u> letos Alcalinos: Propriedades Ópticas e Cinética de Formação e Destruição Posterior ao Dano de Radiação".

## POSIÇÃO PROFISSIONAL

- Pesquisador da CNEN-SP no IPEN

## **PUBLICAÇÕES**

- 1. "Kinectics of U<sub>2</sub> to H<sub>2</sub>O Defects Conversion in OH Doped KCl and KBr" (with S.P.Morato), <u>Journal de Physique</u> C-6 Supp.7 Tomo 4 pag. C-6-155, 1980.
- 2. "Hydrogen Transport Process in OH Doped KCl and KBr" (with S.P. Morato), Solid State Communications, 41, 653 (1982).
- 3. "Development of a Solid State Dosimeter Based on Thermoluminescent CaSO." Dy Crystal" (with S.P. Morato et al...) Nuclear Instruments and Methods, 200,449 (1982).

- 4. "H<sub>2</sub>O Defects in Alkali Halides", L.Gomes and S.P.Morato, Radiation Effects, 73,139 1983.
- 5. "Total Quenching of F Center Luminescence and Photoionization by OH Molecular Defects in KCl", L.Gomes and F.Luty, Physical Review B, 30, 7194 (1984).
- 6. "Relationship Between OH Defect Reorientation Rates and the Quenching of the F Center Luminescence in Alkali Halides", L. Gomes and F. Luty, para ser publicado no Physical Review B.